ИЗМЕРИТЕЛЬ КСВН ПАНОРАМНЫЙ
Р2-78...Р2-82

Альбом электрических схем

1.400.253 ТО1

ЧАСТЬ II

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
2.043.049 ЗЗ	Блок измерительный	4
2.245.209 ЗЗ	Головка детекторная	4
3.26I.0I2 ЗЗ	ГКЧ2	4
5.002.068 ЗЗ	Устройство усилительное канала	6
5.002.069 ЗЗ	Устройство усилительное опорного канала	7
5.008.0I5 ЗЗ	Преобразователь аналого-измерительный	9
5.030.I69 ЗЗ	Усилитель мощности	I0
5.030.I70 ЗЗ	Усилитель балансный I,25-2,5 ГГц	II
5.030.I74 ЗЗ	Усилитель I	II
5.032.236 ЗЗ	Усилитель опорной метки	I2
5.03I.089 ЗЗ	Усилитель входной	I3
5.035.37I ЗЗ	Формирователь управляющего напряжения I	I3
5.035.373 ЗЗ	Формирователь импульсных меток	I4
5.035.374 ЗЗ	Формирователь меток I,25-2,5 ГГц	I4
5.043.007 ЗЗ	Устройство индикации II	I4
5.043.008 ЗЗ	Устройство индикации I	I5
5.049.0II ЗЗ	Устройство осциллографическое	I7
5.05I.000 ЗЗ	Генератор кадровой развертки	I8
5.05I.00I ЗЗ	Генератор строчной развертки	20
5.067.3I3 ЗЗ	Фильтр НЧ переключаемый	2I
5.067.3I4 ЗЗ	Фильтр НЧ переключаемый	2I
5.08I.07I ЗЗ	Модулятор	22
5.087.2I0 ЗЗ	Узел питания высоковольтный I0 кВ, 0,I5 мА	22
5.087.235 ЗЗ	Устройство питания измерительного блока	22
5.087.2I9 ЗЗ	Узел питания ГКЧ	25
5.I03.352 ЗЗ	Устройство управления	27
5.I04.062 ЗЗ	Устройство сопряжения	29
5.I05.065 ЗЗ	Вычислитель	30
5.I05.492 ЗЗ	Устройство управления	3I
5.I06.082 ЗЗ	Устройство запоминающее	3I
5.I06.083 ЗЗ	Устройство постоянное запоминающее	32
5.I26.I99 ЗЗ	Генератор 48 МГц	33
5.I26.200 ЗЗ	Устройство генераторное I,25-2,5 ГГц	34
5.I26.20I ЗЗ	Генератор широкополосный I,25-2,5 ГГц	35
5.I26.202 ЗЗ	Генератор калибровочный 50 МГц	36
5.I26.204 ЗЗ	Генератор I,25-2,5 ГГц	36
5.I26.208 ЗЗ	Генератор I00 кГц	37
5.I26.2I2 ЗЗ	Генератор калибровочный	38
5.I29.046 ЗЗ	Фильтр питания	39
5.I39.I54 ЗЗ	Узел управления	39
5.I39.I55 ЗЗ	Устройство управления частотой	40
5.I57.0II ЗЗ	Регулятор мощности	4I
5.282.249 ЗЗ	Узел соединений	4I
5.282.253 ЗЗ	Устройство соединительное	42
5.282.26I ЗЗ	Узел соединений	43
5.404.2I8 ЗЗ	Устройство детекторное	43
5.406.059 ЗЗ	Смеситель стробоскопический	44
5.407.0I2 ЗЗ	Узел делительный	44
5.408.069 ЗЗ	Делитель частоты II	45
5.408.07I ЗЗ	Умножитель частоты	45
5.436.063 ЗЗ	Смеситель	46
5.436.I08 ЗЗ	Мост	47
5.436.I09 ЗЗ	Мост	48

Сведения об изменениях , вкл.

2.043.049 ЭЗ БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

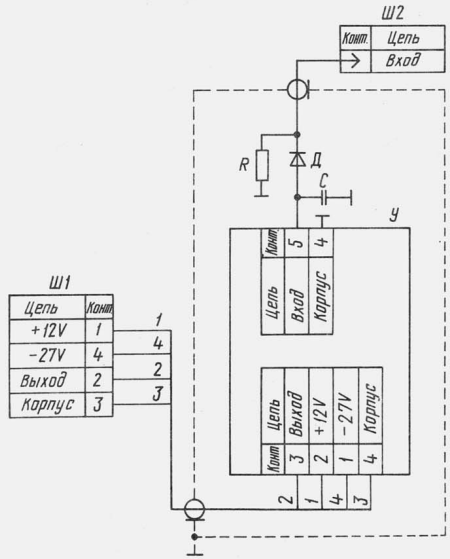
2.043.049 ПЭЗ (См. вкл. I)

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
У2	Устройство питания измерительного блока 5.087.235-0I	I
У3	Устройство осциллографическое 5.049.0II	I
У4	Преобразователь аналого-измерительный 5.008.0I5	I
У5	Устройство сопряжения 5.I04.062	I
У6	Устройство запоминающее 5.I06.082	I
У7	Устройство постоянное запоминающее 5.I06.083	I
У8	Вычислитель 5.I05.065	I
У9	Узел соединений 5.282.26I	I
Ш5	Розетка РГIН-3-5К 0.364.0II ТУ	I
Ш6	Розетка СН053-60/95х9р-2В 0.364.008 ТУ	I
Ш7...Ш9	Розетка РС4ТВ 0.364.047 ТУ	3
ПЛ	Панель лицевая	
В1	Тумблер Т3 0.360.007 ТУ	I
УI	Устройство управления 5.I03.352	I
ШI...Ш3	Вилка РС4ТВ 0.364.047 ТУ	3
Ш4	Вилка РПI0-7 0.364.004 ТУ	I

ГОЛОВКА ДЕТЕКТОРНАЯ

2.245.209 ЭЗ



2.245.209 ЭЗ ГОЛОВКА ДЕТЕКТОРНАЯ

2.245.209 ПЭЗ

Перечень элементов

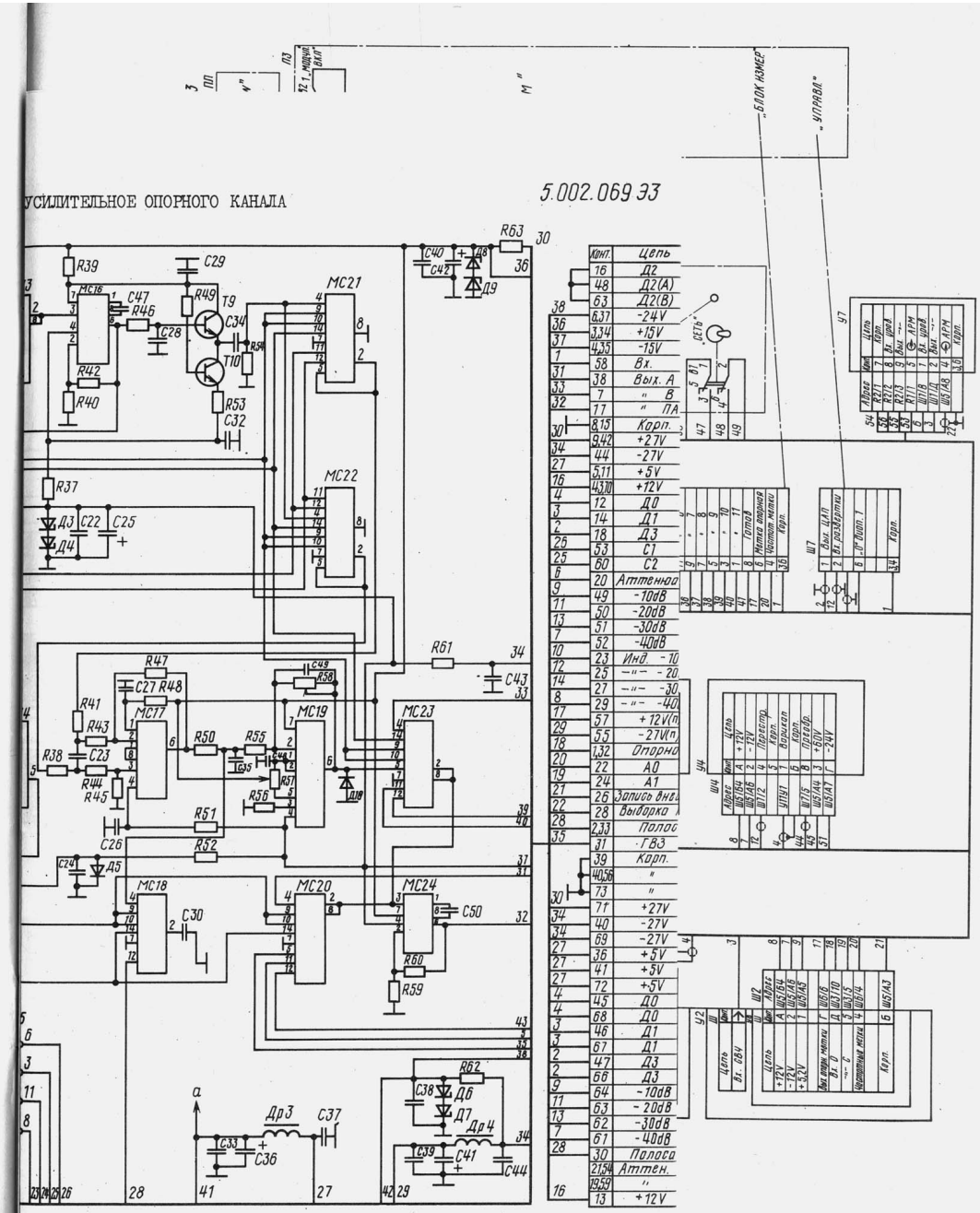
Обозначение	Наименование	Количество
R	Резистор С6-9-0,I25-50 Ом±2 % 0.467.I40 ТУ	I
С	Конденсатор конструктивный	I
Д	Диод 2А203А 3.360.093 ТУ	I
ШI	Розетка РС4ТВ с кожухом 0.364.047 ТУ	I
Ш2	Вилка конструктивная тип Ш вариант I ГОСТ I33I7-80	I
У	Усилитель 5.03I.089	I

3.26I.0I2 ЭЗ ГКЧ2

3.26I.0I2 ПЭЗ

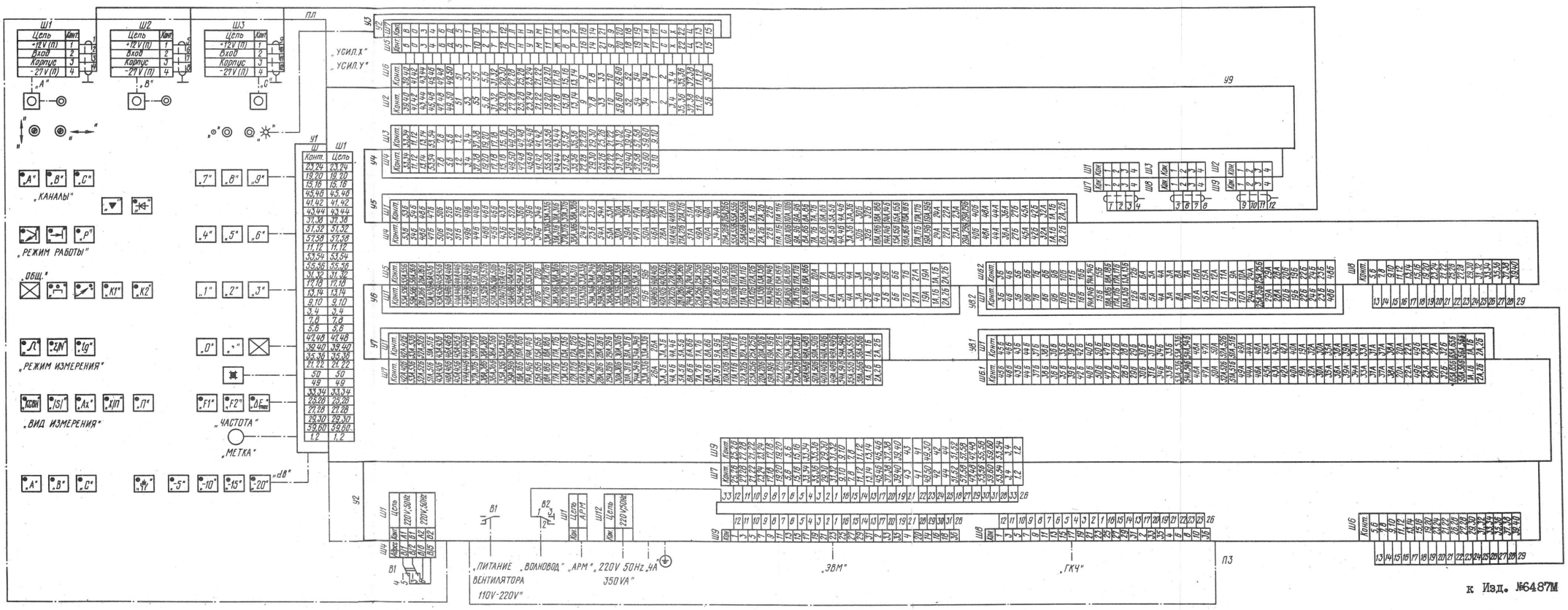
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
УI	Устройство генераторное I,25-5 ГГц 5.I26.200	I
У2	Формирователь меток I,25-2,5 ГГц 5.035.374	I
У3	Устройство управления частотой 5.I39.I55-0I	I
У4	Формирователь управляющего напряжения I 5.035.37I	I
У5	Узел питания ГКЧ 5.087.2I9	I
У6	Генератор калибровочный 50 МГц 5.I26.202	I
У7	Фильтр НЧ 5.067.334	I
	Розетки 0.364.0II ТУ	
ШI	РГIН-3-3К	I
Ш2	РГIН-3-2К	I
Ш3	РГIН-3-5К	I
Ш4	РГIН-3-2К	I
Ш5	Вилка РПI0-I5 0.364.004 ТУ	I
Ш6	Розетка РПМ7М-36Г-П 0.364.043 ТУ	I
Ш7	Розетка РПМ7М-8Г-П 0.364.043 ТУ	I
Ш8	Розетка РГIН-3-2К 0.364.0II ТУ	I
ЭЗ	Кабель 6.645.327-02	I
ПЛ	Панель лицевая	
	Резисторы СП4-Iа 0.468.045 ТУ	
	Резистор ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI	СП4-Iа-0,5-22 кОм-А-ВС-2-20	I
R2	СП4-Iа-0,5-4,7 кОм-А-ВС-2-I2	I
R3	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
ВI	Тумблер Т3 0.360.007 ТУ	I
Д11	Диод светоизлучающий 3Л34IА 0.339.I89 ТУ	I
ЭI	Кабель 6.645.335	I



2.043.049 33 БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

2.043.049 33

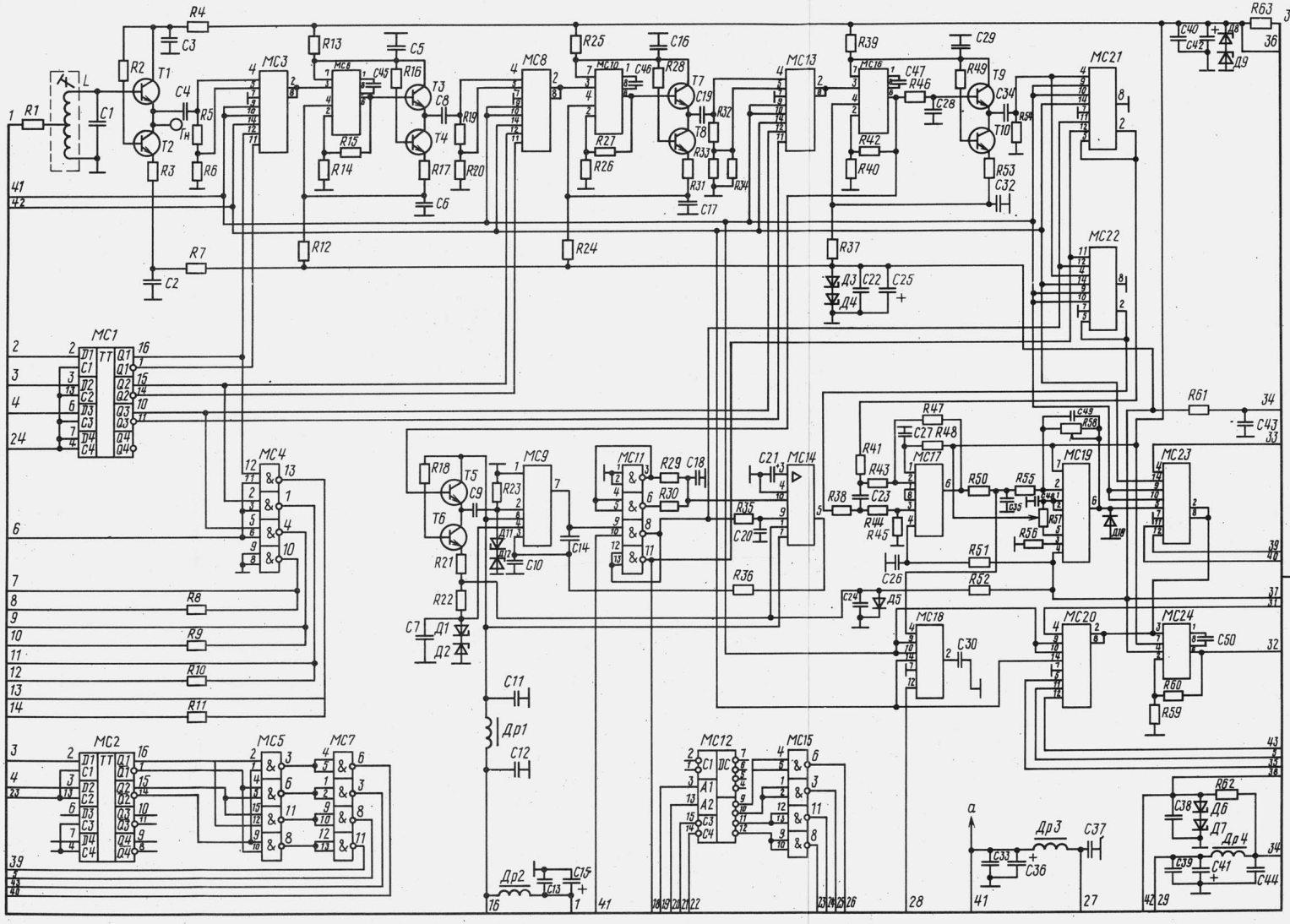


к Изд. №6487М

5.002.069 ЭЗ УСТРОЙСТВО УСИЛИТЕЛЬНОЕ ОПОРНОГО КАНАЛА

5.002.069 ЭЗ

Вкладка I



Конт.	Цепь
16	Д2
48	Д2(А)
63	Д2(В)
6,37	-24V
3,34	+15V
4,35	-15V
58	Вх.
38	Вых. А
7	" В
17	" ПАИ
8,15	Корп.
9,42	+27V
44	-27V
5,11	+5V
43,10	+12V
12	Д0
14	Д1
18	Д3
53	С1
60	С2
20	АттенюаторС
49	-10dB
50	-20dB
51	-30dB
52	-40dB
23	Инд. -10dB
25	—"— -20dB
27	—"— -30dB
29	—"— -40dB
57	+12V(п)
55	-27V(п)
1,32	Опорное
22	А0
24	А1
26	Запись внешняя
28	Выборка ПАИ
2,33	Полоса
31	ГВЭ
39	Корп.
40,56	"
73	"
71	+27V
40	-27V
69	-27V
36	+5V
41	+5V
72	+5V
45	Д0
68	Д0
46	Д1
67	Д1
47	Д3
66	Д3
64	-10dB
63	-20dB
62	-30dB
61	-40dB
30	Полоса
21,54	Аттен. А
19,59	" В
13	+12V

Питание микросхем

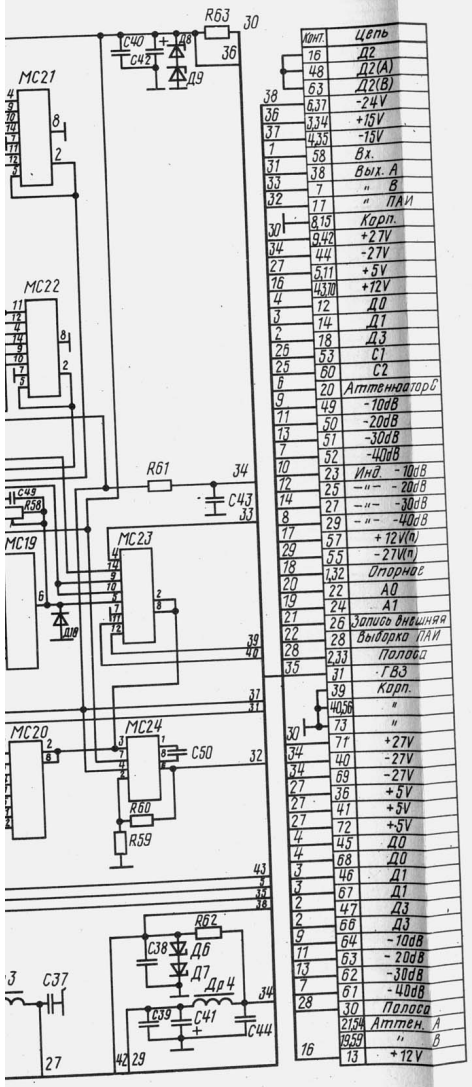
Уровень напряжения	Конт.микросхем
MC1, MC2	
Корпус	I2
а	5
MC4, MC5, MC7, MCII, MCI5	
Корпус	7
а	I4
MCI2	
Корпус	8
а	I6

2.043.049 ЭЗ БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

2.043.049 ПЭЗ (См. вкл. I)

Перечень элементов

5.002.069 ЭЗ



Конт.	Цепь
16	Д2
48	Д2(А)
63	Д2(В)
6,37	-24V
3,34	+15V
4,35	-15V
58	Вх.
38	Вых. А
7	" В
17	" ПАИ
8,15	Корп.
9,42	+27V
44	-27V
5,11	+5V
43,10	+12V
12	Д0
14	Д1
18	Д3
53	С1
60	С2
20	Аттенюатор С
49	-10dB
50	-20dB
51	-30dB
52	-40dB
23	Инд. -10dB
25	-"- -20dB
27	-"- -30dB
29	-"- -40dB
57	+12V(п)
55	-27V(п)
1,32	Опорная
22	А0
24	А1
26	Запись внешняя
28	Выборка ПАИ
2,33	Полоса
31	ГВЗ
39	Корп.
40,56	"
73	"
71	+27V
40	-27V
69	-27V
36	+5V
41	+5V
72	+5V
45	Д0
68	Д0
46	Д1
67	Д1
47	Д3
66	Д3
64	-10dB
63	-20dB
62	-30dB
61	-40dB
30	Полоса
21,54	Аттен. А
19,59	" В
13	+12V

2.245.209 ЭЗ ГОЛОВКА ДЕТЕКТОРНАЯ

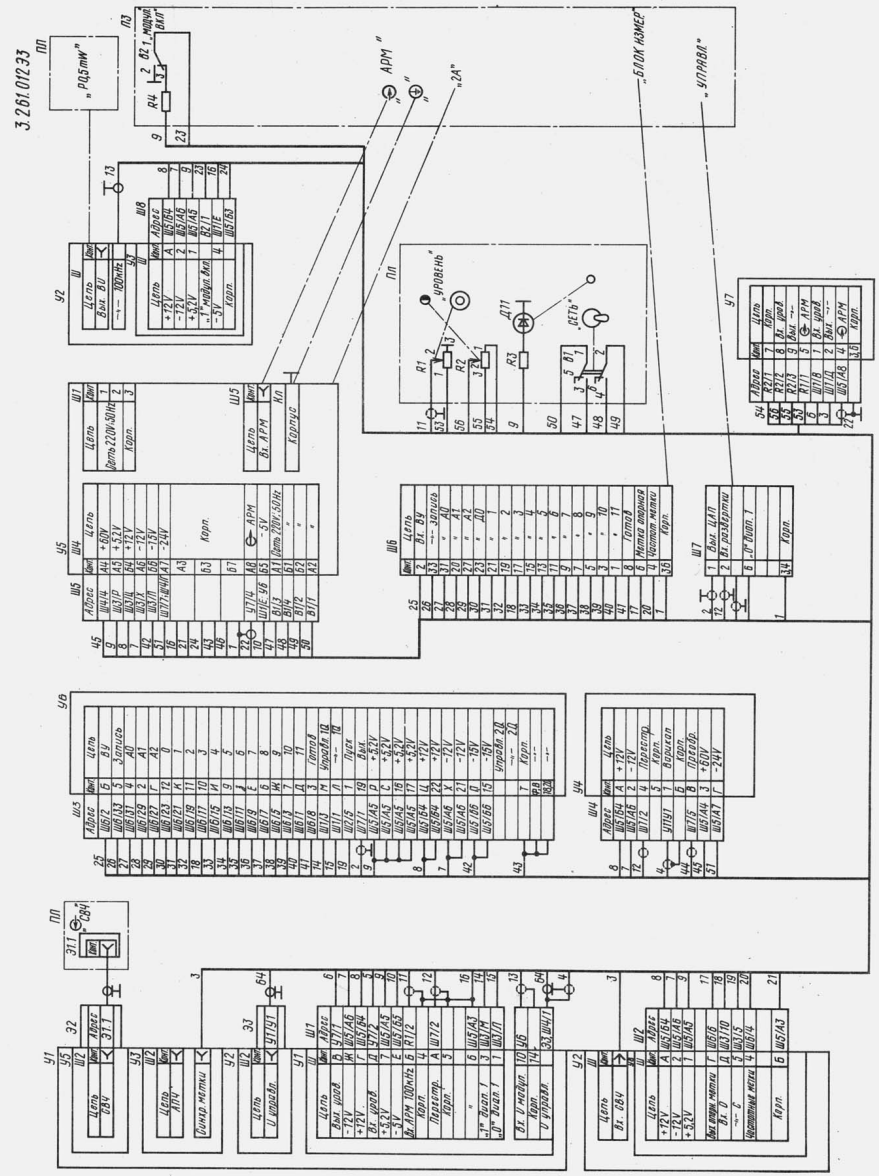
2.245.209 ПЭЗ

Вкладка I

Питание микросхем

Уровень напряжения	Конт.микросхем
МСI,МС2	
Корпус	I2
а	5
МС4, МС5, МС7, МСII, МСI5	
Корпус	7
а	I4
МСI2	
Корпус	8
а	I6

3.261.012 ЭЗ ПК12



I	2	3
П3	Панель задняя	
R4	Резистор ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 % 0.467.I07 ТУ	I
B2	Микротумблер МТI 0.360.0I6 ТУ	I

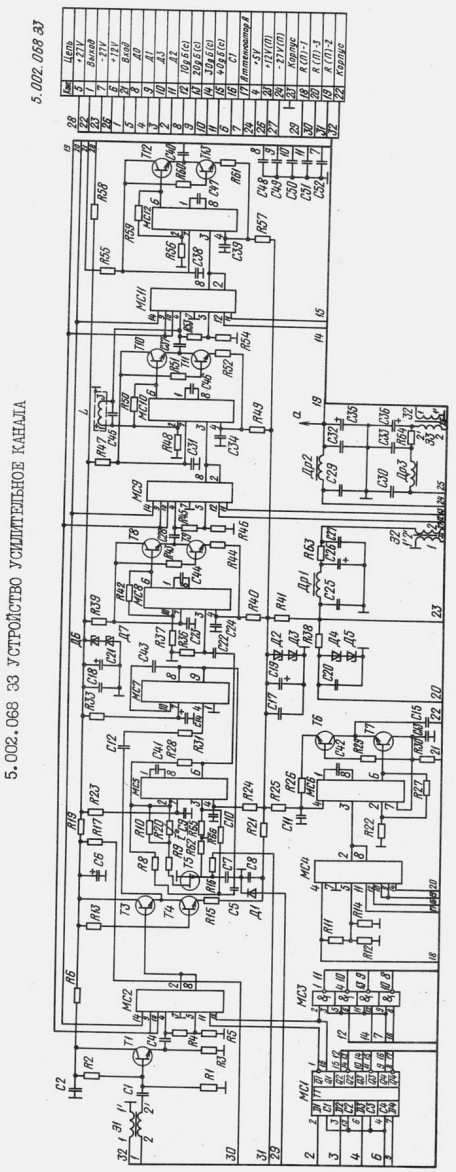
5.002.068 ЭЗ УСТРОЙСТВО УСИЛИТЕЛЬНОЕ КАНАЛА
5.002.068 П3З
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С2-29В 0.467.099 ТУ	
	Терморезистор ММТ-4а 0.468.086 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-47 кОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-33 кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R4	С2-29В-0,I25-I кОм±0,25 %-I,0-А	I
R5	С2-29В-0,I25-I0,I Ом±0,25 %-I,0-А	I
R6	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R8	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R9	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
RI0	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	I
RII	С2-29В-0,I25-I кОм±0,25 %-I,0-А	I
RI2	С2-29В-0,I25-464 Ом±0,25 %-I,0-А	I
RI3	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
RI4	С2-29В-0,I25-I07 кОм±0,25 %-I,0-А	I
RI5	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
RI6	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
RI7	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
RI9	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R20	ММТ-4а-I кОм	I
R2I	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R22	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R23...R25	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	3
R26	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R27	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I

Питание микросхем

Уровень напряжения	Конт. микросхемы
МСI	
+5 V	5
Корпус	I2
МС3	
а	I4
Корпус	7

5.002.068 ЭЗ УСТРОЙСТВО УСИЛИТЕЛЬНОЕ КАНАЛА



I	2	3
R28	ОМЛТ-0,I25-2,7 кОм±I0 %	I
R29	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
R30	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R3I	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
R33	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R36	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R37	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R38	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
R39, R40	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	2
R4I	ОМЛТ-2-I50 Ом±I0 %	I
R42	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R43	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
R44	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R45	С2-29В-0,I25-I,04 кОм±0,25 %-I,0-А	I
R46	С2-29В-0,I25-34 Ом±0,25 %-I,0-А	I
R47	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R48	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
R49	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R50	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R5I	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
R52	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R53	С2-29В-0,I25-I кОм±0,25 %-I,0-А	I
R54	С2-29В-0,I25-III Ом±0,25 %-I,0-А	I
R55	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R56	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R57	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R58	ОМЛТ-2-I50 Ом±I0 %	I
R59	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R60	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
R6I	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R62	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R63, R64	ОМЛТ-0,25-I50 Ом±I0 %	2
R65	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
R66	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.06I ТУ	
CI	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C2	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C4, C5	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C6	К53-I4-I6В-33 мкФ±20 %-В	I
C7...CII	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	5
CI2	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI3	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
CI4	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
CI5	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
CI7, CI8	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
CI9	К53-I4-I6 В-22 мкФ±20 %-В	I
C20	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C2I	К53-I4-I6 В-22 мкФ±20 %-В	I
C22	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C23...C25	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	3
C26	К53-I4-30 В-I0 мкФ±20 %-В	I
C27	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C28	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C29...C34	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	6

I	2	3
C35	К53-I4-6,3 В-I00 мкФ±20 %-В	I
C36	К53-I4-I6 В-I0 мкФ± 20 %-В	I
C37	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C38, C39	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
C40	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C4I, C42	КМ-5б-М47-33 пФ±I0 %-В	2
C43	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C44	КМ-5б-М47-I20 пФ±I0 %-В	I
C45	КМ-5б-МI500-I200 пФ±I0 %-В	I
C46, C47	КМ-5б-М47-33 пФ±I0 %-В	2
C48...C52	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	5
L	Индуктивность 4.770.005	I
ДI	Диод 2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
Д2	Стабилитрон 2СI33А 3.362.805 ТУ	I
Д3	Стабилитрон Д8I4Г 3.362.0I2 ТУ	I
Д4	Стабилитрон Д8I4Г 3.362.0I2 ТУ	I
Д5	Стабилитрон Д8I4Г 3.362.0I2 ТУ	I
Д6	Стабилитрон 2СI33А 3.362.805 ТУ	I
Д7	Стабилитрон Д8I4Г 3.362.0I2 ТУ	I
	Дроссели высокочастотные ДМ 0.477.005 ТУ	
ДрI	ДМ-0,I-500 мкГн±5 %-В	I
Др2	ДМ-0,2-200 мкГн±5 %-В	I
Др3	ДМ-0,I-500 мкГн±5 %-В	I
	Микросхемы	
МСI	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	I
МС2	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МС3	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	I
МС4	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МС5,МС6	544УД2А 0.347.040 ТУ	2
МС7	I22УНIД 3.088.0I5 ТУ	I
МС8	544УД2А 0.347.040 ТУ	I
МС9	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МСI0	544УД2А 0.347.040 ТУ	I
МСII	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МСI2	544УД2А 0.347.040 ТУ	I
	Транзисторы	
TI	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
Т3, Т4	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	2
Т5	2ПI03Д 3.365.000 ТУ	I
Т6...ТI3	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	8
ЭI...Э3	Линия с ферритом 5.433.333	3

5.002.069 ЭЗ УСТРОЙСТВО УСИЛИТЕЛЬНОЕ ОПОРНОГО КАНАЛА
5.002.069 П3З (См.вкл.I)
Перечень элементов

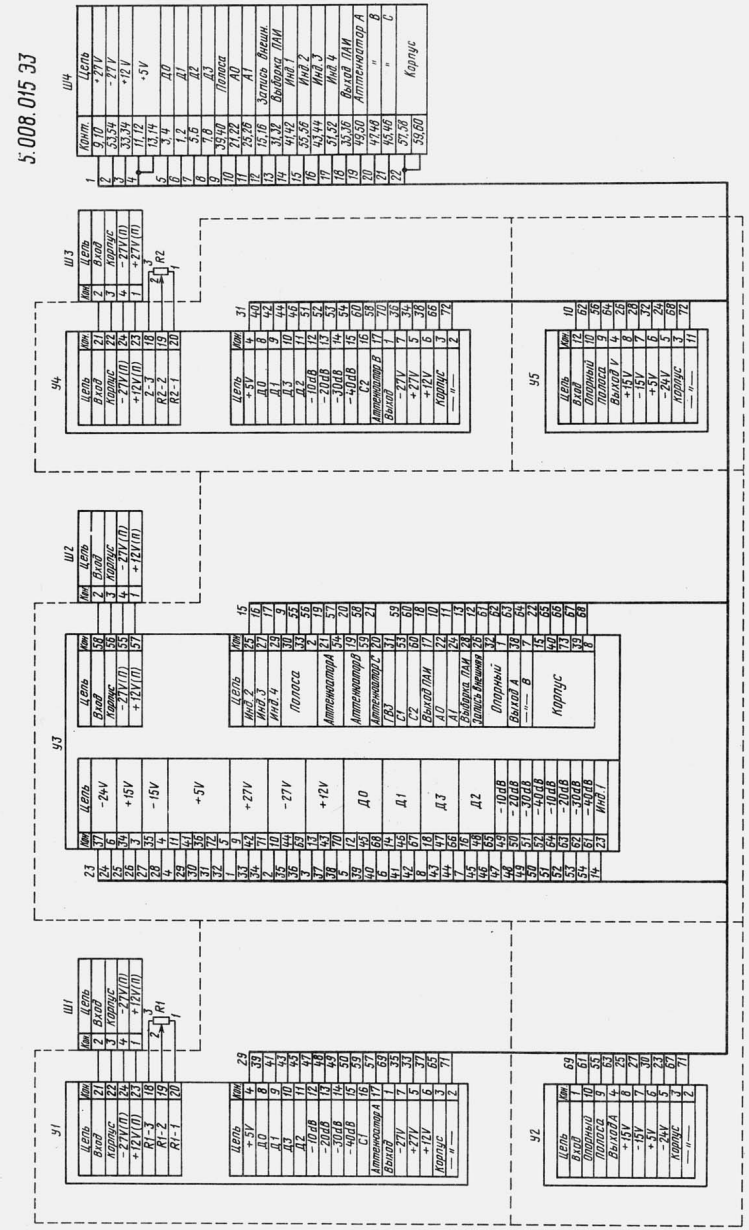
Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С2-29В 0.467.099 ТУ	

I	2	3
	Резисторы С2-36 0.467.089 ТУ	
	Резисторы СП4-I 0.468.045 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
R3, R4	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	2
R5	С2-29В-0,I25-I,04 кОм±0,25 %-I,0-А	I
R6	С2-29В-0,I25-34 Ом±0,25 %-I,0-А	I
R7	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R8...RII	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	4
RI2, RI3	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	2
RI4	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
RI5	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
RI6	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
RI7	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
RI8	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
RI9	С2-29В-0,I25-I кОм±0,25 %-I,0-А	I
R20	С2-29В-0,I25-III Ом±0,25 %-I,0-А	I
R2I	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R22	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
R23	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R24, R25	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	2
R26	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R27	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R28	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
R29, R30	С2-36-20 кОм±0,5 %-А-Н-В	2
R3I	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R32	С2-29В-0,I25-I кОм±0,25 %-I,0-А	I
R33	С2-29В-0,I25-464 Ом±0,25 %-I,0-А	I
R34	С2-29В-0,I25-I07 кОм±0,25 %-I,0-А	I
R35, R36	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	2
R37	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R38	С2-36-I0 кОм±0,5 %-А-Н-В	I
R39	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R40	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R4I	С2-36-I0 кОм±0,5 %-А-Н-В	I
R42	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R43, R44	С2-36-I0 кОм±0,5 %-А-Н-В	2
R45	С2-36-20 кОм±0,5 %-А-Н-В	I
R46	ОМЛТ-0,I25-3,3 кОм±I0 %	I
R47	С2-36-20 кОм±0,5 %-А-Н-В	I
R48	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R49	ОМЛТ-0,I25-220 кОм±I0 %	I
R50	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	I
R5I	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
R52	ОМЛТ-0,I25-I20 Ом±I0 %	I
R53	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R54	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R55, R56	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	2
R57	СП4-Iв-0,25-I00 кОм-А	I
R58	СП4-Iв-0,25-I00 кОм-А	I
R59	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	I
R60	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R6I	ОМЛТ-2-I50 Ом±I0 %	I
R62	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	I
R63	ОМЛТ-2-I50 Ом±I0 %	I

I	2	3
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.06I ТУ	
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI	КМ-5б-МI500-I200 пФ±I0 %-В	I
C2, C3	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
C4	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C5...C7	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	3
C8, C9	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
CI0...CI3	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	4
CI4	КМ-5б-М47-47 пФ±I0 %-В	I
CI5	К53-I4-I6 В-I0 мкФ±20 %-В	I
CI6, CI7	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
CI8...C20	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3
C2I	К53-I4-6,3 В-47 мкФ±20 %-В	I
C22	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C23	КМ-5б-М47-27 пФ±I0 %-В	I
C24	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C25	К53-I4-I6 В-22 мкФ±20 %-В	I
C26, C27	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
C28	КМ-5б-М47-220 пФ±I0 %-В	I
C29	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C30	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C32, C33	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
C34	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C35	КМ-6Б-Н90-0,22 мкФ-В	I
C36	К53-I4-6,3 В-I00 мкФ±20 %-В	I
C37...C40	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	4
C4I	К53-I4-30 В-I0 мкФ±20 %-В	I
C42	К53-I4-I6 В-22 мкФ±20 %-В	I
C43, C44	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
C45...C47	КМ-5б-М47-33 пФ±I0 %-В	3
C48	КМ-5б-М47-I20 пФ±I0 %-В	I
C49	КМ-5б-М47-27 пФ±I0 %-В	I
C50	КМ-5б-М47-33 пФ±I0 %-В	I
L	Индуктивность 4.770.005	I
	Стабилитроны	
ДI	2CI47A 3.362.805 ТУ	I
Д2	2CII3A 3.362.8I6 ТУ	I
Д3	2CI33A 3.362.805 ТУ	I
Д4...Д7	Д8I4Г 3.362.0I2 ТУ	4
Д8	2CI33A 3.362.805 ТУ	I
Д9	Д8I4Г 3.362.0I2 ТУ	I
ДI0	2CI47A 3.362.805 ТУ	I
ДII, ДI2	2CI47A 3.362.805 ТУ	2
	Дроссели высокочастотные ДМ 0.477.005 ТУ	
ДрI, Др2	ДМ-0,I-500 мкГн±5 %-В	2
Др3	ДМ-0,2-200 мкГн±5 %-В	I
Др4	ДМ-0,I-500 мкГн±5 %-В	I
TI...TI0	Транзистор 2T3I2Б 3.365.I43 ТУ	I0
	Микросхемы	
MCI, MC2	I33TM7 3.088.023 ТУI2	2
MC3	I43KTI 3.439.000 ТУ	I
MC4	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	I
MC5	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC6	544УД2А 0.347.040 ТУ	I
MC7	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I

5.008.015 ЭЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

5.008.015 ЭЗ



I	2	3
МС8	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МС9	52ICA2 0.347.0I5 ТУI	I
МСI0	544УД2А 0.347.040 ТУ	I
МСII	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
МСI2	I33ИД4 3.088.023 ТУ32	I
МСI3	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МСI4	I40УДIБ 0.347.004 ТУI	I
МСI5	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
МСI6, МСI7	544УД2А 0.347.040 ТУ	2
МСI8	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МСI9	544УД2А 0.347.040 ТУ	I
МС20...		
МС23	I43КТI 3.439.000 ТУ	4
МС24	544УД2А 0.347.040 ТУ	I

5.008.0I5 ЭЗ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

5.008.0I5 ПЭЗ

Перечень элементов

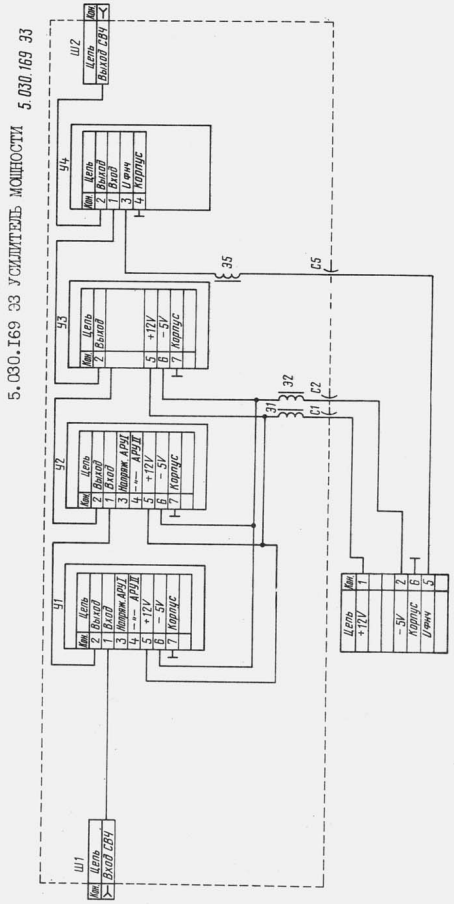
Обозначение	Наименование	Количество
RI, R2	Резистор СП4-Iа-0,5-I,5 кОм-А--ВС-2-25 0.468.045 ТУ	2
ШI...Ш3	Вилка РС4ТВ 0.364.047 ТУ	3
Ш4	Розетка СН053-60/95х9р-2-В 0.364.006	I
УI	Устройство усилительное 5.002.068-0I	I
У2	Устройство детекторное 5.404.2I8	I
У3	Устройство усилительное опорного канала 5.002.069	I
У4	Устройство усилительное 5.002.068	I
У5	Устройство детекторное 5.404.2I8	I

5.030.I69 ЭЗ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

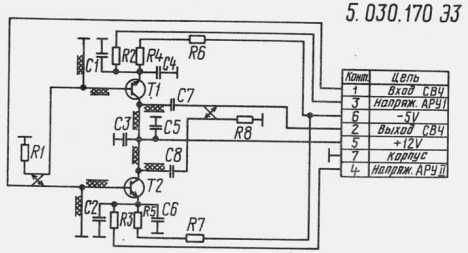
5.030.I69 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
CI, C2, C5	Конденсатор КI0-44-М750-I000 пФ 0.460.I64 ТУ	3
УI	Усилитель балансный I,25-2,5 ГГц 5.030.I70	I
У2	Усилитель балансный I,25-2,5 ГГц 5.030.I70-0I	I
У3	Усилитель балансный I,25-2,5 ГГц 5.030.I70	I
У4	Фильтр НЧ переключаемый 5.067.3I3	I
ШI, Ш2	Розетка конструктивная	2
ЭI,Э2,Э5	Линия с ферритом 5.433.326	3



5.030.I70 ЭЗ УСИЛИТЕЛЬ БАЛАНСНЫЙ I,25-2,5 ГГц



5.030.I70 ПЭЗ

Перечень элементов

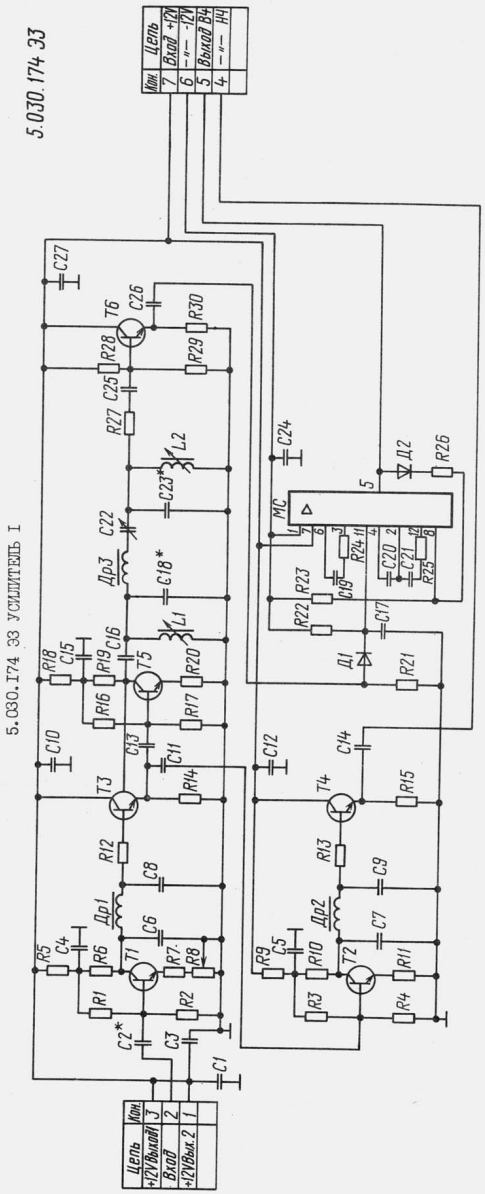
Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы конструктивные	
RI	50 Ом±I %	I
R2, R3	I кОм±I0 %	2
R4, R5	34 Ом±2 %	2
R6, R7	93 Ом±2 %	2
R8	50 Ом±I %	I
	Конденсаторы	
CI, C2	7.727.046	2
C3	I50 пФ±50 %	I
C4...C6	КI0-I7-2в-Н90-0,0I мкФ-I 0.460.I07 ТУ	3
C7, C8	I5 пФ±50 %	2
TI, T2	Транзистор 2Т640А-2 0.339.047 ТУ	2

5.030.I74 ЭЗ УСИЛИТЕЛЬ I

5.030.I74 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резистор С2-I0 0.467.072 ТУ	
	Резистор СП4-Iв 0.468.045 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-I8 кОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-I8 кОм±I0 %	I
R4	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R5, R6	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	2
R7	С2-I0-0,I25-I0 Ом±I %-В	I
R8	СП4-Iв-0,25-220 Ом-А	I
R9	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
RI0	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
RII	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
RI2,RI3	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	2
RI4,RI5	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	2



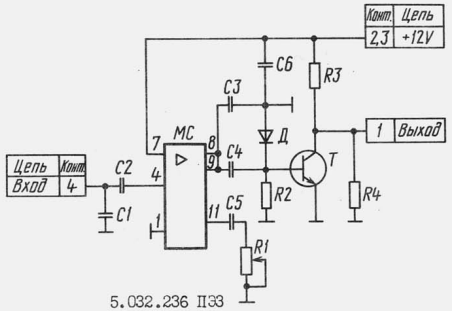
I	2	3
R16	ОМЛТ-0,125-18 кОм±10 %	1
R17	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
R18	ОМЛТ-0,125-470 Ом±10 %	1
R19	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R20	ОМЛТ-0,125-47 Ом±10 %	1
R21	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R22, R23	ОМЛТ-0,125-100 кОм±5 %	2
R24, R25	ОМЛТ-0,125-1,2 кОм±10 %	2
R26	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R27	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	1
R28, R29	ОМЛТ-0,125-4,7 кОм±10 %	2
R30	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К53-14 0.464.096 ТУ	
C1	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C2*	КМ-5б-М1500-1200 пФ±10 %-В	0,05
	КМ-5б-М1500-1500 пФ±10 %-В	0,05
	КМ-5б-М1500-2200 пФ±10 %-В	0,9
C3	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C4, C5	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C7	КМ-5б-М47-510 пФ±5 %-В	1
C9	КМ-5б-М47-510 пФ±5 %-В	1
C10	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C11	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C12	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C14	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C15	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C16, C17	КМ-5б-М1500-1200 пФ±10 %-В	2
C19	КМ-5б-М47-47 пФ±10 %-В	1
C20	КД-1-М47-18 пФ±10 %-В	1
C21	КМ-5б-М47-47 пФ±10 %-В	1
C24	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C25, C26	КМ-5б-М1500-1200 пФ±10 %-В	2
C27	К53-14-16 В-33 мкФ±20 %-В	1
Д1, Д2	Диод 2Д522Б 3.362.029-01 ТУ	2
	Дроссели высокочастотные ДМ 0.477.005 ТУ	
Др1	ДМ-0,4-20 мкГн±5 %-В	1
Др2	ДМ-0,1-500 мкГн±5 %-В	1
T1...T6	Транзистор 2Т316Д 0.336.019 ТУ	6
МС	Микросхема 140УД5А 0.347.004 ТУ3	1
	Переменные данные для исполнений 5.030.174	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор КТ4-21б 0.460.116 ТУ	
C6	КД-1-М47-22 пФ±5 %-В	1
C8	КД-1-М47-22 пФ±5 %-В	1
C13	КМ-5б-М75-220 пФ±10 %-В	1
C18*	КМ-5б-М47-470 пФ±5 %-В	1
C22	КТ4-21б-1/5 пФ-В	1
C23*	КМ-5б-М47-470 пФ±5 %-В	1

*430, 510 пФ (подбирается при регулировании).

I	2	3
L1, L2	Катушка индуктивности ВЧ К0/3-111-2,5 4.777.134 Сп 0.477.001 ТУ (Вывод 1-2)	2
Др3	Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-50 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	1
	5.030.174-01	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор КТ4-21б 0.460.116 ТУ	
C6	КМ-5б-М75-120 пФ±5 %-В	1
C8	КМ-5б-М75-120 пФ±5 %-В	1
C13	КМ-5б-М1500-1200 пФ±10 %-В	1
C18	КМ-5б-М47-430 пФ±5 %-В	1
C22	КТ4-21б-1/5 пФ-В	1
C23	КМ-5б-М47-430 пФ±5 %-В	1
L1, L2	Катушка индуктивности К0/3-111-2,5 4.777.134 Сп 0.477.001 ТУ (Вывод 1-3)	2
Др3	Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-250 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	1

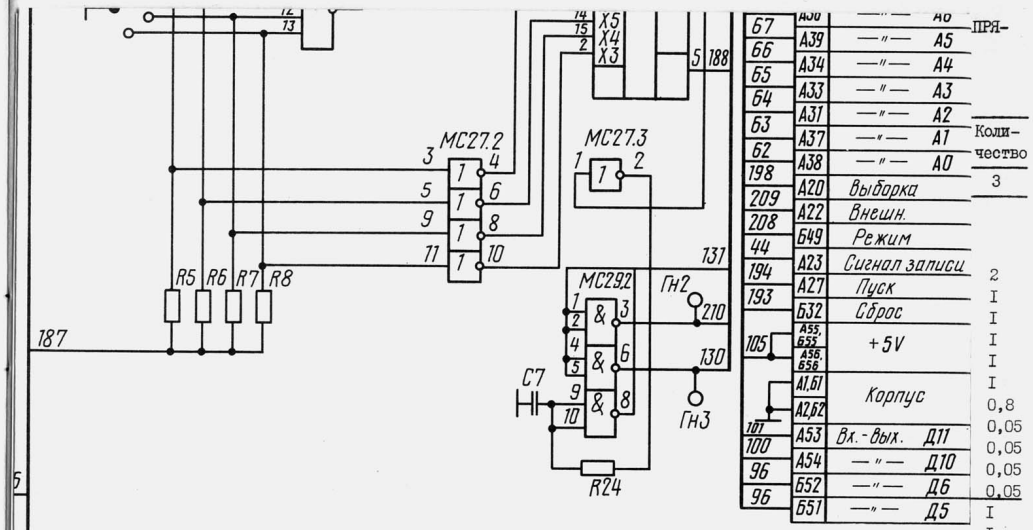
5.032.236 ЭЗ УСИЛИТЕЛЬ ОПОРНОЙ МЕТКИ

5.032.236 ЭЗ

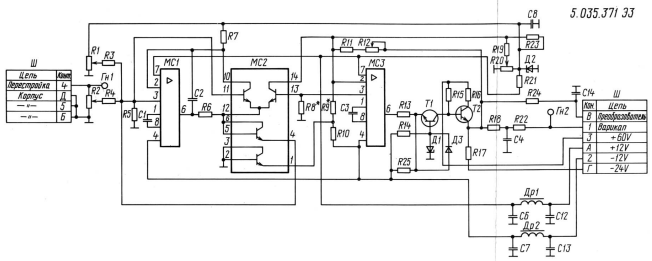


5.032.236 ПЭЗ
Перечень элементов

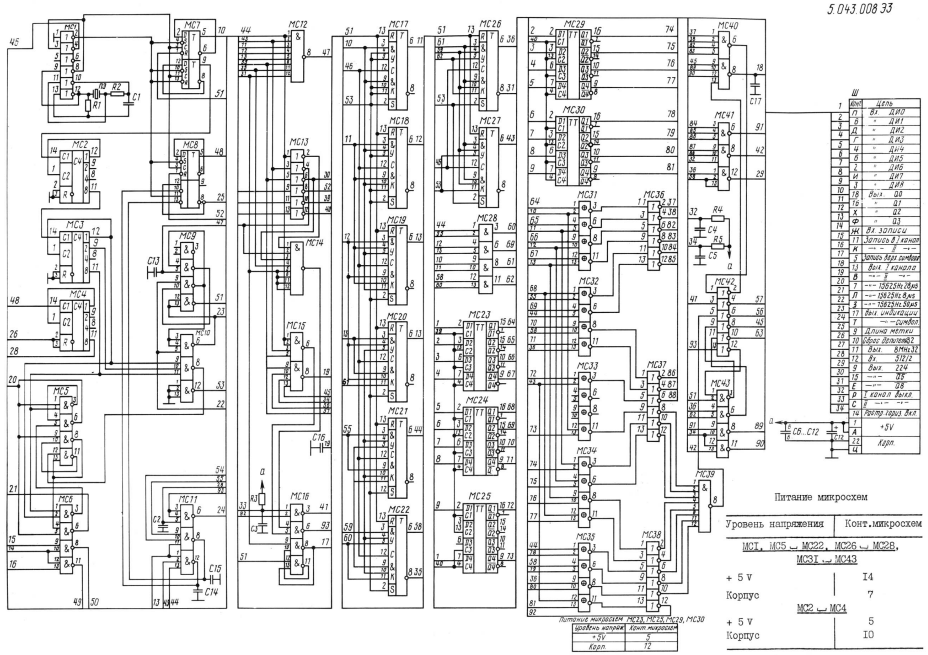
Обозначение	Наименование	Количество
	Резистор СП4-1в 0.468.045 ТУ	
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
R1	СП4-1в-0,25-33 кОм-А	1
R2	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R3	ОМЛТ-0,125-1,5 кОм±10 %	1
R4	ОМЛТ-0,125-820 Ом±10 %	1
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
C1	КМ-5б-М1500-1200 пФ±10 %-В	1
C2	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ-В	1
C3	КМ-5б-М1500-150 пФ±10 %-В	1
C4, C5	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ-В	2
C6	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ-В	1
Д	Диод 2Д522Б 3.362.029-01 ТУ	1
T	Транзистор 2Т312В 3.365.143 ТУ	1
МС	Микросхема 122УН1Д 3.088.015 ТУ	1


MC27.2
MC27.3
MC29.2
R5
R6
R7
R8
R24
C7
Гн2
Гн3
187
188
131
130
210
X5
X4
X3
Б7 А39 —"— А5
Б6 А34 —"— А4
Б5 А33 —"— А3
Б4 А31 —"— А2
Б3 А37 —"— А1
Б2 А38 —"— А0
198 А20 Выборка
209 А22 Внешн.
208 Б49 Режим
44 А23 Сигнал записи
194 А27 Пуск
193 Б32 Сброс
105 А55 Б55 А56 Б56 +5V
А1,Б1 А2,Б2 Корпус
101
100 А53 Вх.-вых. Д11
96 А54 —"— Д10
96 Б52 —"— Д6
Б51 —"— Д5
ПРЯ-
Коли-
чество
3
2
1
1
1
1
0,8
0,05
0,05
0,05
0,05
1
1
1
1

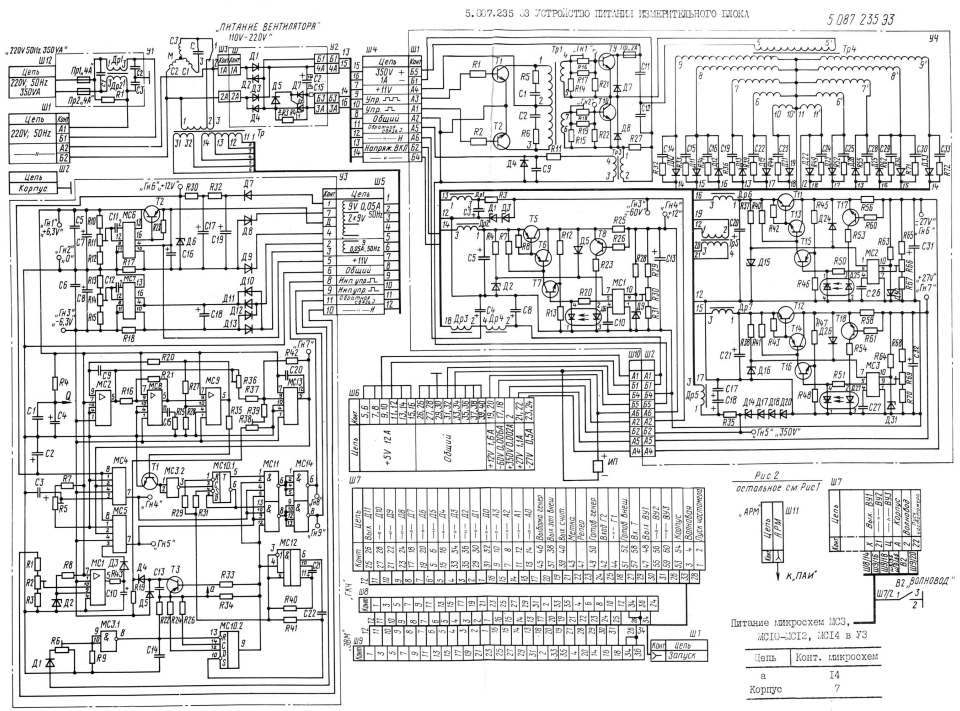
5.035.371 ЭЗ ФОРМИРОВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ I



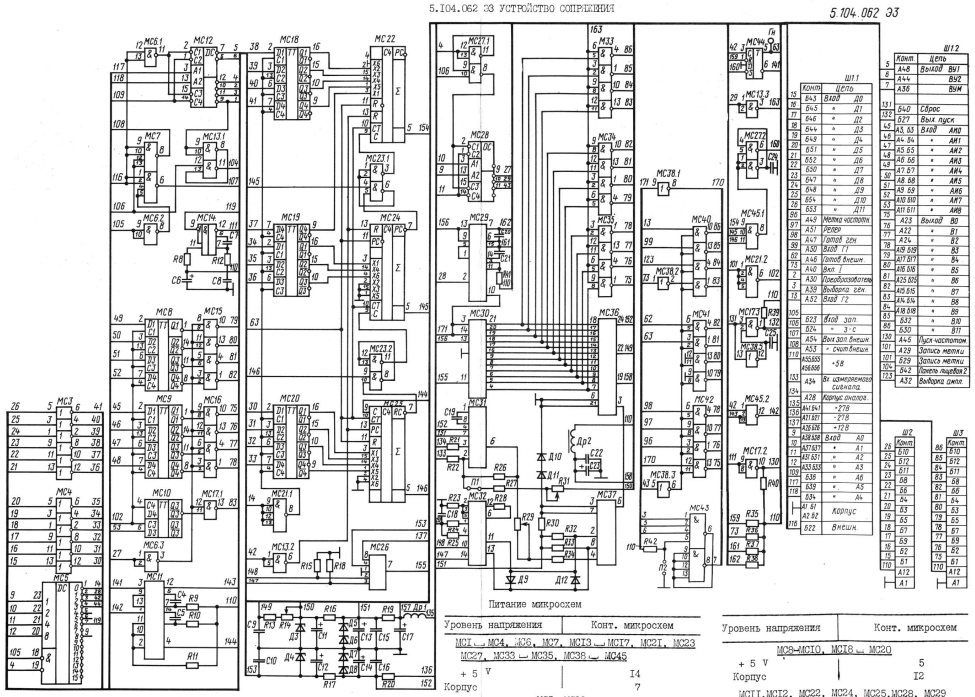
5.043.008 ЭЗ УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ I



5.087.235 ЭЗ УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА



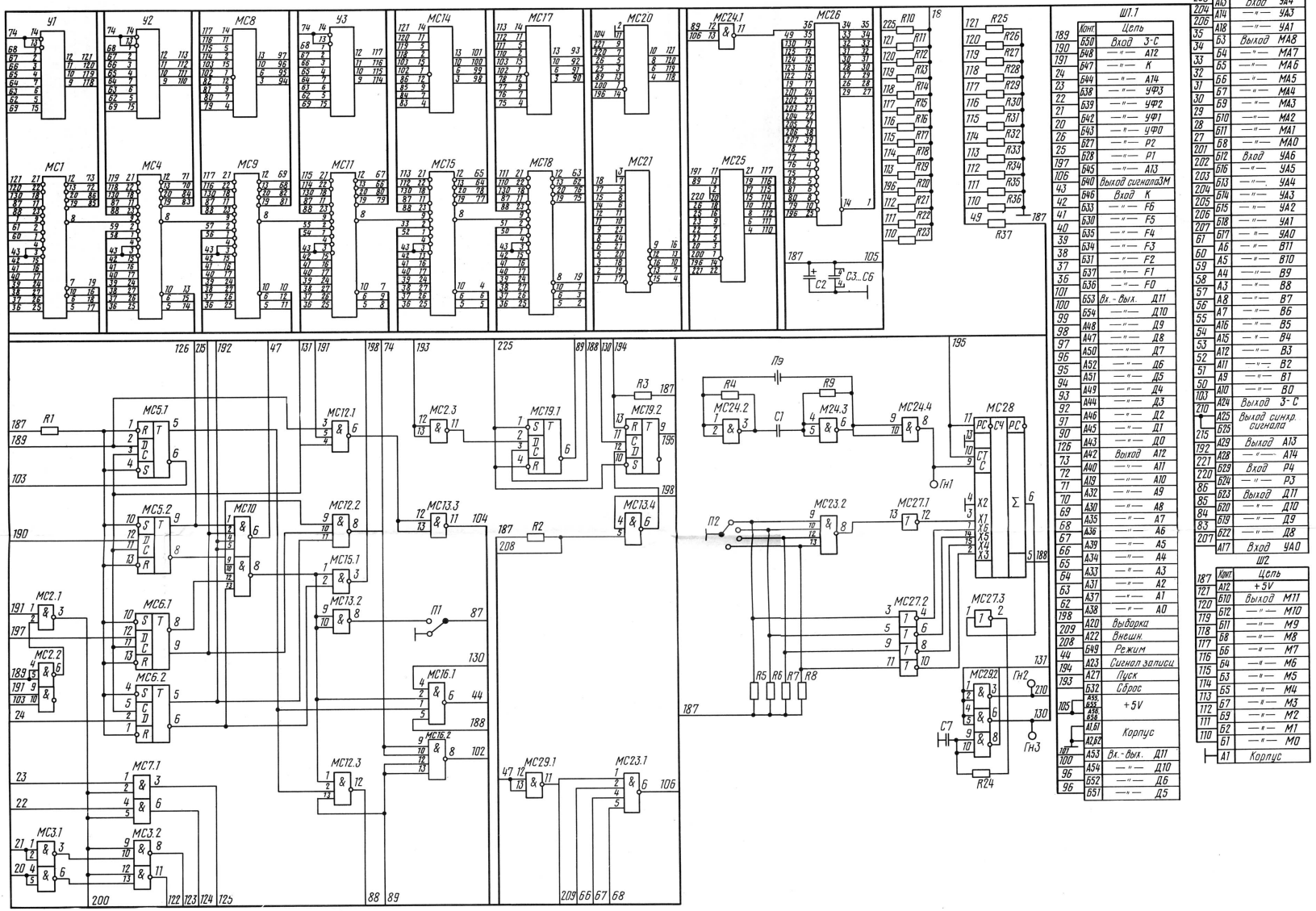
5.104.062 ЭЗ УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ



к Изд. №64871

5.105.065 ЭЭ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬ



Ш1.1

Конт.	Цепь
Б50	Вход З-С
Б48	—"— А12
Б47	—"— К
Б44	—"— А14
Б38	—"— УФ3
Б39	—"— УФ2
Б42	—"— УФ1
Б43	—"— УФ0
Б27	—"— Р2
Б28	—"— Р1
Б45	—"— А13
Б40	Выход сигнала ЗМ
Б46	Вход К
Б33	—"— F6
Б30	—"— F5
Б35	—"— F4
Б34	—"— F3
Б31	—"— F2
Б37	—"— F1
Б36	—"— F0
Б53	Вх.-Вых. Д11
Б54	—"— Д10
А48	—"— Д9
А47	—"— Д8
А50	—"— Д7
А52	—"— Д6
А51	—"— Д5
А49	—"— Д4
А44	—"— Д3
А46	—"— Д2
А45	—"— Д1
А43	—"— Д0
А42	Выход А12
А40	—"— А11
А19	—"— А10
А32	—"— А9
А30	—"— А8
А35	—"— А7
А36	—"— А6
А39	—"— А5
А34	—"— А4
А33	—"— А3
А31	—"— А2
А37	—"— А1
А38	—"— А0
А20	Выборка
А22	Внешн.
Б49	Режим
А23	Сигнал записи
А27	Пуск
Б32	Сброс
А55, Б55, А56, Б56	+5V
А1,Б1, А2,Б2	Корпус
А53	Вх.-Вых. Д11
А54	—"— Д10
Б52	—"— Д6
Б51	—"— Д5

Ш1.2

Конт.	Цепь
А13	Вход УА4
А14	—"— УА3
А18	—"— УА1
Б3	Выход МА8
Б4	—"— МА7
Б5	—"— МА6
Б6	—"— МА5
Б7	—"— МА4
Б9	—"— МА3
Б10	—"— МА2
Б11	—"— МА1
Б8	—"— МА0
Б12	Вход УА6
Б16	—"— УА5
Б13	—"—. УА4
Б14	—"— УА3
Б15	—"— УА2
Б18	—"— УА1
Б17	—"— УА0
А6	—"— В11
А5	—"— В10
А4	—"— В9
А3	—"— В8
А8	—"— В7
А7	—"— В6
А16	—"— В5
А15	—"— В4
А12	—"— В3
А11	—"— В2
А9	—"— В1
А10	—"— В0
А24	Выход З-С
А25	Выход синхр. сигнала
Б25	
А29	Выход А13
А28	—"— А14
Б29	Вход Р4
Б24	—"— Р3
Б23	Выход Д11
Б20	—"— Д10
Б19	—"— Д9
Б22	—"— Д8
А17	Вход УА0

Ш2

Конт.	Цепь
А12	+5V
Б10	Выход М11
Б12	—"— М10
Б11	—"— М9
Б8	—"— М8
Б6	—"— М7
Б4	—"— М6
Б3	—"— М5
Б5	—"— М4
Б7	—"— М3
Б9	—"— М2
Б2	—"— М1
Б1	—"— М0
А1	Корпус

Питание микросхем

Уровень напряжения	Конт. микросхем
У1–У3, МС8, МС14, МС28, МС17	
+ 5 V	16
Корпус	8
МС2 – МС3, МС5, МС7, МС10, МС12, МС13, МС16, МС19, МС23, МС24, МС27, МС29	
+ 5 V	14
Корпус	7

Уровень напряжения	Конт. микросхем
МС1, МС4, МС9, МС11, МС15, МС18, МС21	
+5 V	28
Корпус	14
МС20, МС25	
+5 V	24
Корпус	

Уровень напряжения	Конт. микросхем
МС26	
+ 5 V	40
Корпус	20

—"—	А0
—"—	А5
—"—	А4
—"—	А3
—"—	А2
—"—	А1
—"—	А0
Выборка	
Внешн.	
Режим	
Сигнал записи	
Пуск	
Сброс	
+5V	
Корпус	
Вх.-Вых.	Д11
—"—	Д10
—"—	Д6
—"—	Д5

207	Б22	—"—	Д8
	А17	Вход	УА0

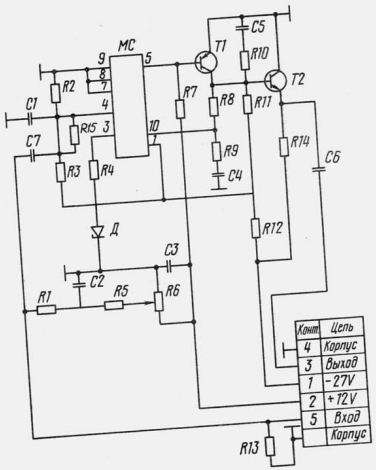
Ш2

	Конт.	Цепь	
187	А12	+5V	
121	Б10	Выход	М11
120	Б12	—"—	М10
119	Б11	—"—	М9
118	Б8	—"—	М8
117	Б6	—"—	М7
116	Б4	—"—	М6
115	Б3	—"—	М5
114	Б5	—"—	М4
113	Б7	—"—	М3
112	Б9	—"—	М2
111	Б2	—"—	М1
110	Б1	—"—	М0
	А1	Корпус	

...ения	Конт. микросхем
МС26	
	40
	20

5.031.089 ЭЗ УСИЛИТЕЛЬ ВХОДНОЙ

5.031.089 ЭЗ



5.031.089 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
	Резистор СП5-16ВВ 0.468.519 ТУ	
	Резисторы С2-23 0.467.081 ТУ	
R1	ОМЛТ-0,125-27 кОм±10 %	1
R2, R3	ОМЛТ-0,125-120 кОм±10 %	2
R4	ОМЛТ-0,125-1,8 кОм±10 %	1
R5	ОМЛТ-0,125-12 кОм±10 %	1
R6	СП5-16ВВ-0,125 Вт 4,7 кОм±10 %	1
R7	ОМЛТ-0,125-15 кОм±10 %	1
R8	С2-23-0,125-8,25 кОм±1 %-А-В-В	1
R9	С2-23-0,125-590 Ом±1 %-А-В-В	1
R10	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	1
R11	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R12	ОМЛТ-0,25-1,5 кОм±5 %	1
R13	ОМЛТ-0,125-5,6 кОм±5 %	1
R14	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	1
R15	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6А 0.460.061 ТУ	
C1	КМ-5б-МП500-220 пФ±10 %-В	1
C2...C4	КМ-6А-Н90-0,22 мкФ-В	3
C5	КМ-5б-МП500-220 пФ±10 %-В	1
C6	КМ-6А-Н90-0,22 мкФ-В	1
C7	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
Д	Стабилитрон 2С212Ж 3.362.825 ТУ	1
T1	Транзистор 2Т326Б 0.336.003 ТУ	1
T2	Транзистор 2Т312Б 3.365.143 ТУ	1
МС	Микросхема 122УД1Б 3.088.015 ТУ	1

5.035.371 ЭЗ ФОРМИРОВАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ I (См. вкл. 2)

5.035.371 ПЭ3
Перечень элементов

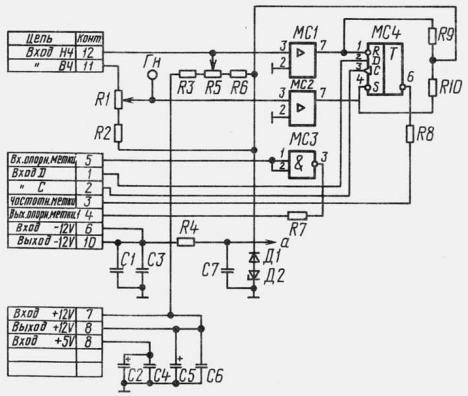
Обозначение	Наименование	Количество
1	2	3
	Резисторы СП4-1в 0.468.045 ТУ	
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
	Резисторы С2-36 0.467.089 ТУ	
R1, R2	СП4-1в-0,25-10 кОм-А	2
R3	ОМЛТ-0,125-30 кОм±5 %	1
R4	ОМЛТ-0,125-15 кОм±10 %	1
R5	С2-36-200 Ом±0,5 %-Н-В	1
R6	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R7	С2-36-15 кОм±0,5 %-Н-В	1
R8*	С2-36-200 Ом±0,5 %-Н-В	0,8
	С2-36-160 Ом±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-180 Ом±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-221 Ом±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-240 Ом±0,5 %-Н-В	0,05
R10	ОМЛТ-0,125-10 кОм±5 %	1
R11	ОМЛТ-0,125-33 кОм±5 %	1
R12	СП4-1в-0,25-33 кОм-А	1
R13	ОМЛТ-0,125-820 Ом±5 %	1
R14	ОМЛТ-0,125-560 Ом±10 %	1
R15	ОМЛТ-0,125-33 кОм±5 %	1
R16	ОМЛТ-0,125-680 Ом±10 %	1
R17	ОМЛТ-0,5-18 кОм±10 %	1
R18	ОМЛТ-0,125-1,2 кОм±5 %	1
R19	ОМЛТ-0,125-100 кОм±10 %	1
R20	СП4-1в-0,25-10 кОм-А	1
R21	ОМЛТ-0,125-240 Ом±5 %	1
R22	ОМЛТ-0,125-1,5 кОм±5 %	1
R23	ОМЛТ-0,125-56 кОм±10 %	1
R24	ОМЛТ-0,125-3,3 кОм±10 %	1
R25	ОМЛТ-0,125-1,8 кОм±10 %	1
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К73П-3 0.461.029 ТУ	
C1	КМ-5б-М47-33 пФ±10 %-В	1
C2, C3	КМ-5б-М47-270 пФ±10 %-В	2
C4	К73П-3-0,1±10 %-В	1
C6...C8	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3
C12, C13	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C14	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
Д1	Стабилитрон 2С156В 3.362.839 ТУ	1
Д2	Стабилитрон Д818Д 3.362.025 ТУ	1
Д3	Диод 2Д522Б 3.362.029-01 ТУ	1
Др1, Др2	Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-200 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	2
T1, T2	Транзистор 2Т630Б 3.365.043 ТУ	2
	Микросхемы	
МС1	153УД2 0.347.010 ТУ2	1
МС2	198НТ1А 0.348.002 ТУ	1

*Подбирается при настройке.

I	2	3
МС3	I53УД2 0.347.0I0 ТУ2	I
Ш	Вилка конструктивная I4 конт.	I
	<u>Переменные данные для исполнений 5.035.37I</u>	
	Резистор С2-36 0.467.089 ТУ	
R9*	С2-36-6,I9 кОм±0,5 %-Н-В	0,8
	С2-36-5,II кОм±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-5,62 кОм±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-6,8I кОм±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-7,5 кОм±0,5 %-Н-В	0,05
		I
	<u>5.035.37I-0I</u>	
	Резистор С2-36 0.467.089 ТУ	
R9*	С2-36-I0 кОм±0,5 %-Н-В	0,8
	С2-36-8,I6 кОм±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-9,09 кОм±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-II кОм±0,5 %-Н-В	0,05
	С2-36-I2 кОм±0,5 %-Н-В	0,05
		I

*Подбираются при настройке.

5.035.373 ЭЗ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ МЕТОК



5.035.373 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы СП4-Iв 0.468.045 ТУ	
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI	СП4-Iв-0,25-3,3 кОм-А	I
R2	ОМЛТ-0,I25-I5 кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R4	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
R5	СП4-Iв-0,25-3,3 кОм-А	I
R6	ОМЛТ-0,I25-3,9 кОм±I0 %	I
R7, R8	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	2
R9, RI0	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	2
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
CI	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C2	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C3, C4	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C5	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C6	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C7	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
ДI	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
Д2	Стабилитрон 2CI56A 3.362.805 ТУ	I
	Микросхемы	
MCI, MC2	52ICA2 0.347.0I5 ТУI	2
MC3	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC4	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I

5.035.374 ЭЗ ФОРМИРОВАТЕЛЬ МЕТОК I,25-2,5 ГГц

5.035.374 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
Ш	Вилка 3.640.033	I
УI	Усилитель опорной метки 5.032.236	I
У2	Смеситель стробоскопический 5.406.059	I
У3	Усилитель I 5.030.I74	I
У4	Смеситель 5.436.064	I
У5	Делитель частоты II 5.408.069	I
У6	Формирователь импульсных меток 5.035.373	I
У7	Генератор 48 МГц 5.I26.I99	I
У8	Узел соединений 5.282.249	I

5.043.007 ЭЗ УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ II

5.043.007 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К50-29 0.464.I56 ТУ	
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI	КМ-5б-М47-470 пФ±I0 %-В	I
C2	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C3, C4	КМ-5б-М47-68 пФ±I0 %-В	2
C5	К50-29-63В-I00 мкФ-В	I

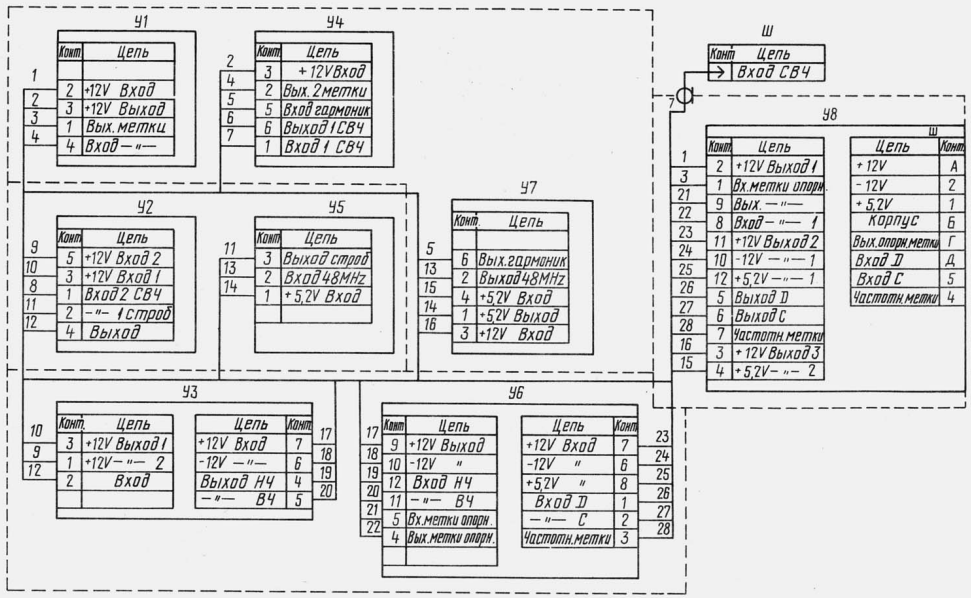
I	2	3
C6	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C7	К53-I4-I6В-33 мкФ±20 %-В	I
C8...CII	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	4
CI2	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI3	К53-I4-I6В-33 мкФ±20 %-В	I
CI4	К50-29-63В-I00 мкФ-В	I
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R4	ОМЛТ-0,5-33 Ом±I0 %	I
ДI, Д2	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	2
Д3, Д4	Стабилитрон 2CI47A 3.362.805 ТУ	2
Д5	Стабилитрон 2CI56A 3.362.805 ТУ	I
MCI-MCI2	Микросхемы	I2

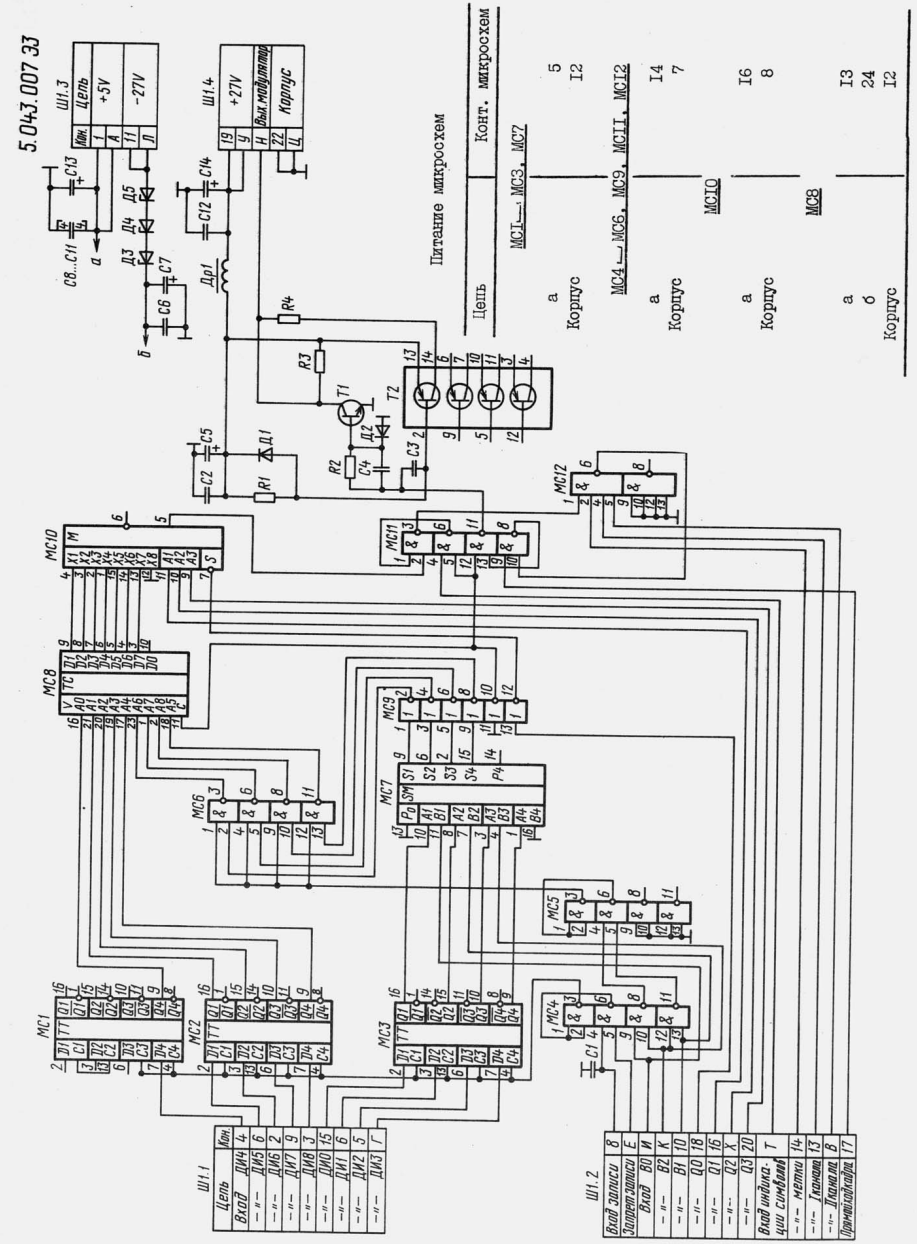
5.043.008 ЭЗ УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ I

5.043.008 ПЭ3 (См.вкл.2)
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI, R2	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	2
R3...R5	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	3
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI	КМ-5б-М750-220 пФ±I0 %-В	I
C2	КМ-5б-М750-220 пФ±I0 %-В	I
C3...C5	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3
C6...CII	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	6
CI2	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
CI3...CI7	КМ-5б-МI500-I000 пФ±I0 %-В	5
Пэ	Резонатор РГ-05-I4ГС 8000 кГц-М2-В 0.338.065 ТУ	I
Ш	Вилка конструктивная	I
	Микросхемы	
MCI	I33ЛНI 3.088.023 ТУ	I
MC2...MC4	I33ИЕ5 3.088.023 ТУII	3
MC5, MC6	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	2
MC7, MC8	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	2
MC9	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MCI0, MCII	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	2
MCI2	I33ЛА2 3.088.023 ТУ7	I
MCI3	I33ЛНI 3.088.023 ТУ	I
MCI4	I33ЛА2 3.088.023 ТУ7	I
MCI5	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
MCI6	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MCI7...		
MC22	I33ТВI 3.088.023 ТУ7	6

5.035.374 ЭЗ ФОРМИРОВАТЕЛЬ МЕТОК
I,25-2,5 ГГц





I	2	3
МС23...		
МС25	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	3
МС26,МС27	I33ТВI 3.088.023 ТУ7	2
МС28	I33ЛИI 3.088.023 ТУ	I
МС29,МС30	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	2
МС3I...		
МС35	I33ЛП5 3.088.023 ТУ3I	5
МС36...		
МС38	I33ЛНI 3.088.023 ТУ	3
МС39	I33ЛА2 3.088.023 ТУ7	I
МС40	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
МС4I	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I
МС42	I33ЛНI 3.088.023 ТУ	I
МС43	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I

5.049.0II ЭЗ УСТРОЙСТВО ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКОЕ

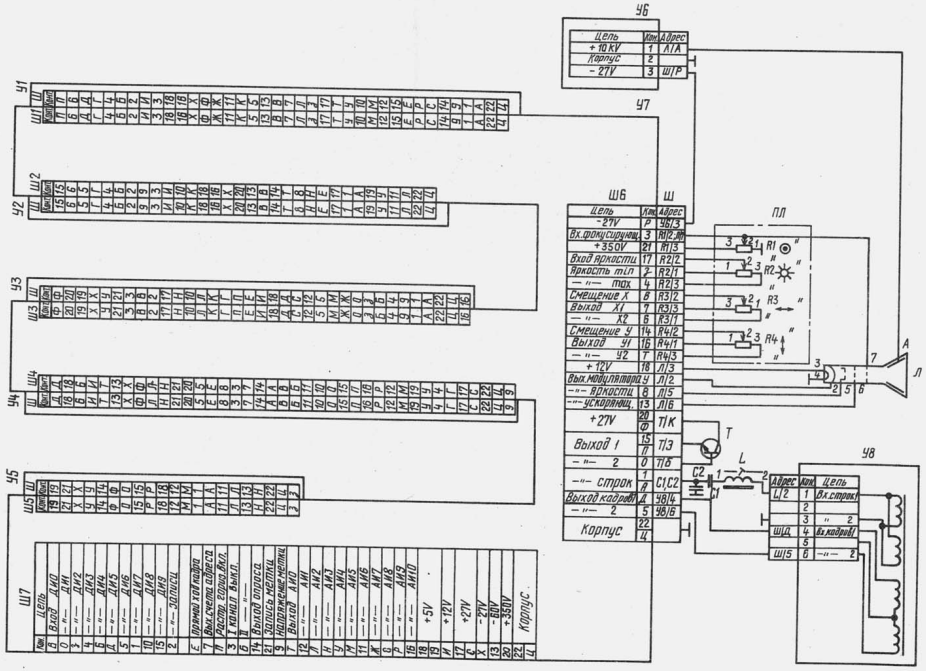
5.049.0II ПЭ3

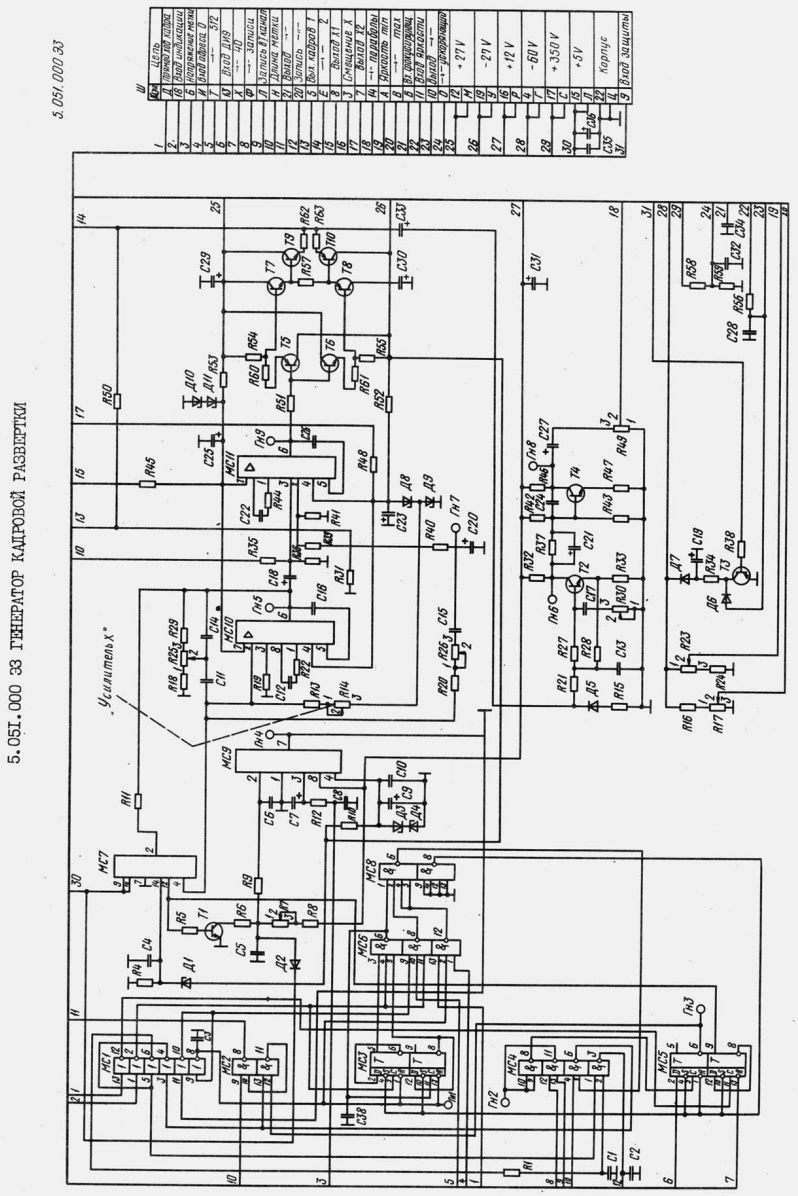
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Конденсаторы	
CI	К72П-5-500-0,I5±I0 % 0.46I.024 ТУ	I
C2	К73-I6-63 В-I5 мкФ±I0 % 0.46I.I08 ТУ	I
	Регулятор линейности строк 5.I25.007	I
Л	Трубка электронно-лучевая 23ЛМI6Б 0.335.I0I ТУ	I
Т	Транзистор 2Т809А 3.365.0I7 ТУ	I
УI	Устройство индикации I 5.043.008	I
У2	Устройство индикации II 5.043.007	I
У3	Устройство управления 5.I05.492	I
У4	Генератор кадровой развертки 5.05I.000	I
У5	Генератор строчной развертки 5.05I.00I	I

5.049.0II ЭЗ УСТРОЙСТВО ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКОЕ

5.049.011 ЭЗ





I	2	3
У6	Блок питания высоковольтный 5.087.210	I
У7	Устройство соединительное 5.282.253	I
У8	Система отклоняющая 5.791.015	I
Ш	Розетка РГ1Н-3-5 0.364.011 ТУ	I
ПЛ	Панель лицевая	
	Резисторы СП4-2 0.468.045 ТУ	
R1, R2	СП4-2 Ма-330 кОм А-ОС-3-60	2
R3, R4	СП4-2 Ма-1 кОм А-ОС-3-60	2

5.051.000 ЭЗ ГЕНЕРАТОР КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ
5.051.000 ПЭ
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
	Резисторы СП3-16а 0.468.087 ТУ	
R1	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	1
R4	ОМЛТ-0,125-4,7 кОм±10 %	1
R5	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
R6	ОМЛТ-0,125-100 Ом±10 %	1
R7	СП3-16а-330 кОм±30 %-2	1
R8	ОМЛТ-0,125-220 кОм±10 %	1
R9	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R10	ОМЛТ-0,5-1,5 кОм±10 %	1
R11	ОМЛТ-0,125-470 Ом±10 %	1
R12	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R13	ОМЛТ-0,125-470 кОм±10 %	1
R14	СП3-16а-470 кОм±30 %-2	1
R15	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	1
R16	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R17	СП3-16а-47 кОм±20 %-2	1
R18	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
R19	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R20	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
R21	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	1
R22	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R23	СП3-16а-47 кОм±20 %-2	1
R24	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R25, R26	СП3-16а-100 кОм±20 %-2	2
R27, R28	ОМЛТ-0,125-33 кОм±10 %	2
R29	ОМЛТ-0,125-100 кОм±10 %	1
R30	СП3-16а-6,8 кОм±20 %-2	1
R31	ОМЛТ-0,5-10 Ом±10 %	1
R32	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
R33	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R34	ОМЛТ-0,5-33 кОм±10 %	1
R35, R36	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	2
R37	ОМЛТ-0,125-68 кОм±10 %	1
R38	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R39	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R40	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1

I	2	3
R41	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	1
R42	ОМЛТ-0,125-22 кОм±10 %	1
R43	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	1
R44	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R45	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	1
R46	ОМЛТ-0,125-1 кОм±10 %	1
R47	ОМЛТ-0,125-470 Ом±10 %	1
R48	ОМЛТ-0,125-10 кОм±10 %	1
R49	СП3-16а-10 кОм±20 %-2	1
R50	ОМЛТ-0,5-221 Ом±10 %	1
R51	ОМЛТ-0,125-680 Ом±10 %	1
R52, R53	ОМЛТ-0,5-680 Ом±10 %	2
R54, R55	ОМЛТ-0,125-15 кОм±10 %	2
R56	ОМЛТ-0,125-1 МОм±10 %	1
R57	ОМЛТ-0,5-680 Ом±10 %	1
R58	ОМЛТ-0,25-470 кОм±10 %	1
R59	ОМЛТ-0,125-220 кОм±10 %	1
R60, R61	ОМЛТ-0,125-330 Ом±10 %	2
R62, R63	ОМЛТ-0,5-4,7 Ом±10 %	2
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К42У-2 0.462.082 ТУ	
	Конденсаторы К73П-3 0.461.029 ТУ	
	Конденсаторы К53-14 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы К50-29 0.464.156 ТУ	
C1, C2	КМ-5б-МП500-3300 пФ±10 %-В	2
C3	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C4	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C5	К73П-3-0,5±10 %-В	1
C6	КМ-5б-М47-100 пФ±10 %-В	1
C7	К53-14-10 В-10 мкФ±20 %-В	1
C8	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C9	К53-14-10 В-47 мкФ±20 %-В	1
C10	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C11	К73П-3-0,25-10 %-В	1
C12	КМ-5б-МП500-1000 пФ±10 %-В	1
C13	КМ-5б-Н90-0,068 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C14	К73П-3-0,25±10 %-В	1
C15	К73П-3-0,5±10 %-В	1
C16	КМ-5б-М47-27 пФ±10 %-В	1
C17	К73П-3-0,5±10 %-В	1
C18	К50-29-25 В-100 мкФ	1
C19	К50-29-100 В-100 мкФ	1
C20	К50-29-25 В-100 мкФ	1
C21	К53-14-30 В-4,7 мкФ±20 %-В	1
C22	КМ-5б-МП500-1000 пФ±10 %-В	1
C23	К50-29-25 В-100 мкФ	1
C24	К73П-3-0,5±10 %-В	1
C25	К50-29-25 В-100 мкФ	1
C26	КМ-5б-М47-27 пФ±10 %-В	1
C27	К50-29-16 В-220 мкФ	1
C28	КМ-5б-Н90-0,068 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C29, C30	К50-29-63 В-220 мкФ	2
C31	К50-29-16 В-220 мкФ	1
C32	К73П-3-0,05±10 %-В	1
C33	К50-29-25 В-47 мкФ	1
C34	К42У-2-500-0,033±10 %	1
C35	КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1

I	2	3
C36	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C38	КМ-6Б-МI500-6800 пФ±I0 %-В	I
ДI	Стабилитрон 2СI33А 3.362.805 ТУ	I
Д2	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
Д3, Д4	Стабилитрон 2СI56А 3.362.805 ТУ	2
Д5	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
Д6, Д7	Диод Д237А 3.362.02I ТУ	2
	Стабилитроны	
Д8	2СI68А 3.362.805 ТУ	I
Д9, ДI0	Д8I4Б 3.362.0I2 ТУ	2
ДII	2СI68А 3.362.805 ТУ	I
	Транзисторы	
TI, T2	2Т3I2Б 3.365.I43 ТУ	2
T3	2Т830Г 0.339.I39 ТУ	I
T4	2Т3I2Б 3.365.I43 ТУ	I
T5	2Т208И 3.365.035 ТУ	I
T6, T7	2Т608Б 3.365.0I3 ТУ	2
T8	2Т208И 3.365.035 ТУ	I
T9	2Т827А 0.339.II9 ТУ	I
TI0	2Т825А 0.339.054 ТУ	I
Ш	Вилка конструктивная	I
	Микросхемы	
МСI	I33ЛНI 3.088.023 ТУ22	I
МС2	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
МС3	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
МС4	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
МС5	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I

I	2	3
МС6	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I
МС7	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
МС8	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
МС9	52ICA2 0.347.0I5 ТУI	I
МСI0,МСII	I53УД2 0.347.0I0 ТУ2	2

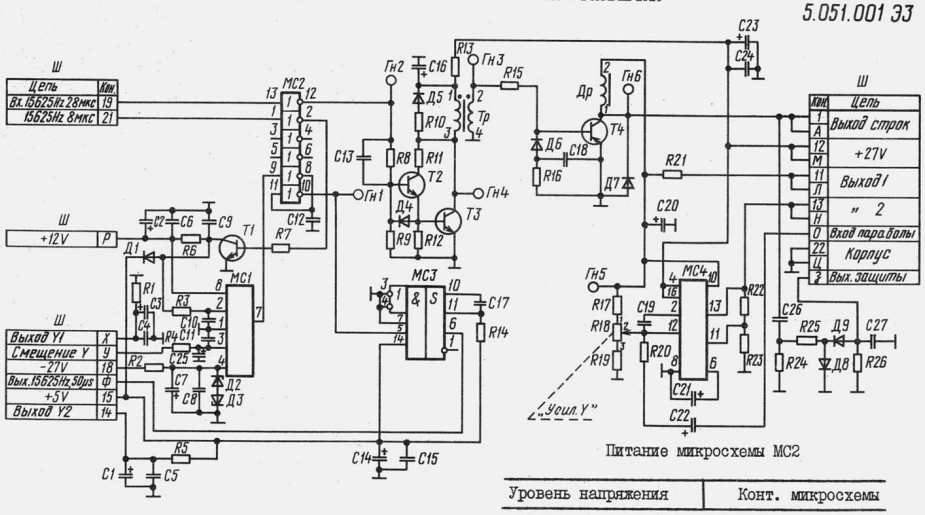
5.05I.00I Э3 ГЕНЕРАТОР СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ

5.05I.00I ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С5-I6МВ 0.467.5I3 ТУ	
	Резисторы СП3-I6а 0.468.087 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-I50 Ом±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,5-I,5 кОм±I0 %	I
R3, R4	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	2
R5, R6	ОМЛТ-0,I25-3,3 кОм±I0 %	2
R7	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R8	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R9	ОМЛТ-0,I25-3,3 кОм±I0 %	I
RI0	ОМЛТ-2-220 Ом±I0 %	I

5.05I.00I Э3 ГЕНЕРАТОР СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ

5.051.001 Э3



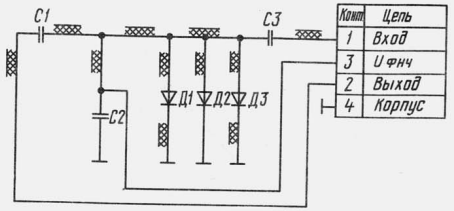
Питание микросхемы МС2

Уровень напряжения	Конт. микросхемы
+5 V	I4
Корпус	7

I	2	3
RII	ОМЛТ-0,I25-68 Ом±I0 %	I
RI2	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
RI3	ОМЛТ-2-220 Ом±I0 %	I
RI4	ОМЛТ-0,I25-33 кОм±I0 %	I
RI5	ОМЛТ-I-I Ом±I0 %-Т	I
RI6	ОМЛТ-0,5-6,8 Ом±I0 %-I	I
RI7	ОМЛТ-0,I25-3,9 кОм±I0 %	I
RI8	СП3-I6а-I кОм±20 %-2	I
RI9	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R20	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R2I	С5-I6МВ-I Вт 0,47 Ом I %	I
R22	ОМЛТ-0,I25-3,3 кОм±I0 %	I
R23	ОМЛТ-0,I25-68 кОм±I0 %	I
R24	ОМЛТ-0,25-I00 кОм±I0 %	I
R25, R26	ОМЛТ-0,5-I0 кОм±I0 %	2
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор К73П-3 0.46I.029 ТУ	
	Конденсаторы К50-29 0.464.I56 ТУ	
CI...C3	К53-I4-I6В-33 мкФ±20 %-В	3
C4...C6	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3
C7	К53-I4-I0В-47 мкФ±20 %-В	I
C8	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C9	К73П-3-0,05±I0 %-В	I
CI0,CI2	КМ-5б-М47-I00 пФ±I0 %-В	3
CI3	КМ-5б-МI500-I000 пФ±I0 %-В	I
CI4	К53-I4-I0В-47 мкФ±20 %-В	I
CI5	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI6	К50-29-63В-I00 мкФ-В	I
CI7	КМ-5б-М750-2200 пФ±I0 %-В	I
CI8	КМ-5б-МI500-4700 пФ±I0 %-В	I
CI9	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C20	К50-29-63В-I00 мкФ-В	I
C2I	К53-I4-3ОВ-22 мкФ±20 %-В	I
C22	К50-29-I6В-220 мкФ-В	I
C23	К50-29-63В-I00 мкФ-В	I
C24	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C25	К53-I4-I0В-I0 мкФ±20 %-В	I
C26,C27	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
ДI	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
Д2, Д3	Стабилитрон 2СI56А 3.362.805 ТУ	2
Д4...Д6	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	3
Д7	Диод 2Д202Ж 3.362.035 ТУ	I
Д8, Д9	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	2
Др	Дроссель 4.752.02I	I
	Транзисторы	
TI	2Т3I2Б 3.365.I43 ТУ	I
T2, T3	2Т630Б 3.365.043 ТУ	2
T4	2Т809А 3.365.0I7 ТУ	I
Тр	Трансформатор 4.739.008	I
Ш	Вилка конструктивная	I
	Микросхемы	
МСI	52ICA2 0.347.0I5 ТУI	I
МС2	I33ЛНI 3.088.023 ТУ	I
МС3	I33АГI 3.088.023 ТУ	I
МС4	I42ЕН2А 0.347.098 ТУI	I

5.067.3I3 Э3 ФИЛЬТР НЧ ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ

5.067.313 Э3

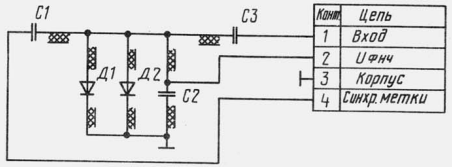


5.067.3I3 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Конденсаторы конструктивные	
CI	50 пФ±50 %	I
C2	I20 пФ±50 %	I
C3	50 пФ±50 %	I
ДI...Д3	Диод 2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	3

5.067.3I4 Э3 ФИЛЬТР НЧ ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ

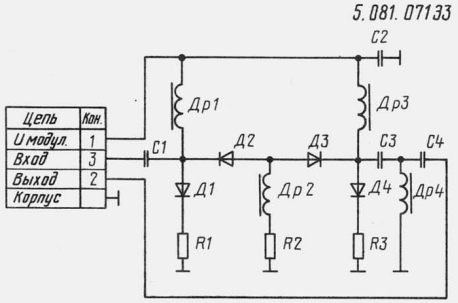
5.067.314 Э3



5.067.3I4 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
CI...C3	Конденсатор КI0-I7-2В-МI500--330 пФ±5 %-I 0.460.I07 ТУ	3
ДI, Д2	Диод 2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	2

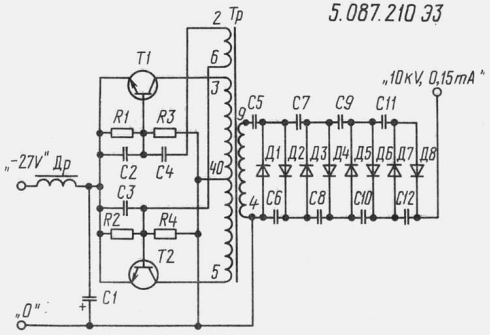
5.081.071 ЭЗ МОДУЛЯТОР



5.081.071 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы С2-10 0.467.072 ТУ	
R1	С2-10-0,125-45,3 Ом±1 %-В	1
R2	С2-10-0,125-27 Ом±1 %-В	1
R3	С2-10-0,125-45,3 Ом±1 %-В	1
	Конденсаторы К10-17 0.460.107 ТУ	
C1, C2	К10-17-2в-М47-470 пФ±10 %-3	2
C3	К10-17-2в-М750-220 пФ±10 %-2	1
C4	К10-17-2в-М47-470 пФ±10 %-3	1
Д1...Д4	Диод 2А517А-2 0.336.028 ТУ	4
Др1...	Дроссель высокочастотный	
Др3	ДМ-1,2-6 мкГн±0,4 мкГн-В 0.477.005 ТУ	3
Др4	Дроссель высокочастотный ДМ-3-1 мкГн±0,4 мкГн-В 0.477.005 ТУ	1

5.087.210 ЭЗ УЗЕЛ ПИТАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ 10 кВ, 0,15 мА



5.087.210 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
R1, R2	Резистор ОМЛТ-0,25-330 Ом±10 % 0.467.107 ТУ	2
R3, R4	Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 кОм±10 % 0.467.107 ТУ	2
C1	Конденсатор К50-29-63 В-470 мкФ 0.464.156 ТУ	1
C2, C3	Конденсатор КМ-6Б-Н90-0,47 мкФ-В 0.460.061 ТУ	2
C4	Конденсатор КМ-5б-Н90-0,1 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В 0.460.043 ТУ	1
C5...C12	Конденсатор К15-5-Н70-3 кВ-3300 пФ 0.460.084 ТУ	8
Д1...Д8	Диод 2Ц706Г 3.362.004 ТУ	8
Др	Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-20мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	1
T1, T2	Транзистор 2Т809А 3.365.017 ТУ	2
Тр	Катушка 5.760.502	1

5.087.235 ЭЗ УСТРОЙСТВО ПИТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА

5.087.235 ПЭ3 (См. вкл.2)
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
1	2	3
C	Конденсатор К42У-2-250-1±10 % 0.462.082 ТУ	1
M	Вентилятор 1,25 ЭВ-2,8-6-3270Т4 ТУ16.739.109-77	1
B1	Тумблер 0.360.007 ТУ	1
ИП	Счетчик ЭСВ-2,5-12,6-1 0.281.008 ТУ	1
Тр	Трансформатор 4.702.007	1
Ш1	Розетка РП10-7 0.364.004 ТУ	1
Ш2	Клемма 4.835.018	1
	Розетки	
Ш3	РП10-7 0.364.004 ТУ	1
Ш4	РП10-11 0.364.004 ТУ	1
Ш5	РГ1Н-3-4К 0.364.011 ТУ	1
Ш6	СН051-40/71х9р-2-В 0.364.006	1
Ш7	СН053-60/95х9р-2-В 0.364.006	1
Ш8, Ш9	РПМ7М-36Г-ПБ 0.364.043 ТУ	2
Ш10	Вилка РП10-11 0.364.004 ТУ	1
Ш12	Вилка ВД1 0.364.003 ТУ	1
	Переменные данные для исполнения 5.087.235	
Ш11	Розетка СР-50-73ФВ 0.364.010 ТУ	1

1	2	3
	5.087.235-01	
B2	Тумблер МТ1 0.360.016 ТУ	1
Ш11	Розетка СР-50-73ФВ 0.364.010 ТУ	1
У1	Фильтр сетевой 5.087.231	1
R1	Резистор ОМЛТ-1-1,0 МОм±5 %	1
C1	Конденсатор К42У-2-1000-0,1±10 % 0.462.082 ТУ	1
C2, C3	Конденсатор К15-5-Н70-1,6 кВ-0,01 мкФ 0.460.084 ТУ	2
Др1, Др2	Дроссель 4.752.022	2
Пр1, Пр2	Вставка плавкая ВП1-1-4А 250 В 0.480.003 ТУ	2
У2	Выпрямитель 5.121.064	1
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
R1, R2*	ОМЛТ-2-100 кОм±5 %	2
R3, R4**	ОМЛТ-2-200 Ом±5 %	2
R5	ОМЛТ-1-100 Ом±5 %	1
C2...	Конденсатор К50-29-450 В-22 мкФ	
C15***	0.464.156 ТУ	14
Д1	Диод 2Д210В 0.336.076 ТУ	1
Д2	Диод 2Д206В 3.362.113 ТУ	1
Д3	Диод 2Д210В 0.336.076 ТУ	1
Д4	Диод 2Д206В 3.362.113 ТУ	1
Д5	Стабилитрон 2С213Ж 3.362.825 ТУ	1
Д6	Тиристор 2У202Л 3.362.022 ТУ	1
Д7	Диод Д237Б 3.362.021	1
Ш	Вилка РП10-7 0.364.004 ТУ	1
У3	Генератор 5.411.142	1
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
	Резисторы СП4-1 0.468.045 ТУ	
	Резистор С5-16 0.467.513 ТУ	
R1	ОМЛТ-0,25-120 Ом±5 %	1
R2	СП4-1в-0,25-470 Ом-А	1
R3	ОМЛТ-0,25-330 Ом±5 %	1
R4	ОМЛТ-0,25-15 Ом±5 %	1
R5	СП4-1в-0,25-470 Ом-А	1
R6	СП4-1в-0,25-1 кОм-А	1
R7	ОМЛТ-0,25-220 Ом±5 %	1
R8	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R9	ОМЛТ-0,25-150 Ом±5 %	1
R10	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R11	СП4-1в-0,25-2,2 кОм-А	1
R12	ОМЛТ-0,25-750 Ом±5 %	1
R13	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R14	СП4-1в-0,25-2,2 кОм-А	1
R15	ОМЛТ-0,25-750 Ом±5 %	1
R16	ОМЛТ-0,25-5,6 кОм±5 %	1
R17, R18	С5-16 МВ-1 Вт-0,82 Ом±1 %	2
R19	ОМЛТ-0,25-10 кОм±5 %	1
R20	ОМЛТ-0,25-10 кОм±5 %	0,2
	ОМЛТ-0,25-12 кОм±5 %	0,6
	ОМЛТ-0,25-15 кОм±5 %	0,2

*R = 50 кОм

**R = 100 Ом

***C = 308 мкФ

1	2	3
R21	ОМЛТ-0,25-5,6 кОм±5 %	1
R22	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R23	ОМЛТ-0,25-100 Ом±5 %	1
R24	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R25	ОМЛТ-0,25-220 Ом±5 %	1
R26	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R27, R28	ОМЛТ-0,25-10 кОм±5 %	2
R29	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R30	ОМЛТ-1-270 Ом±5 %	1
R31	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R32	ОМЛТ-1-270 Ом±5 %	1
R33	ОМЛТ-0,25-10 кОм±5 %	1
R34	ОМЛТ-0,25-1 кОм±5 %	1
R35	ОМЛТ-0,25-10 кОм±5 %	1
R36	СП4-1в-0,25-47 кОм-А	1
R37	ОМЛТ-0,25-10 кОм±5 %	1
R38	СП4-1в-0,25-10 кОм-А	1
R39	ОМЛТ-0,25-5,6 кОм±5 %	1
R40	ОМЛТ-0,25-33 кОм±5 %	1
R41	ОМЛТ-0,25-120 кОм±5 %	1
R42	ОМЛТ-0,25-10 кОм±5 %	1
R43	ОМЛТ-0,25-5,6 кОм±5 %	1
	Конденсаторы К50-29 0.464.156 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор К53-14 0.464.096 ТУ	
C1	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C2	К50-29-16 В-100 мкФ	1
C3	К50-29-16 В-22 мкФ	1
C4	К50-29-16 В-100 мкФ	1
C5, C6	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C7, C8	К50-29-16 В-100 мкФ	2
C9	КМ-5б-М75-820 пФ±10 %-В	1
C10	К53-14-16 В-4,7 мкФ+20 %-В	1
C11, C12	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C13	К50-29-16 В-22 мкФ	1
C14	КМ-5б-Н90-0,015 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
C15	КМ-5б-М75-470 пФ±10 %-В	1
C16	КМ-29-16 В-2200 мкФ	1
C17	К50-29-63 В-100 мкФ	1
C18	К50-29-16 В-470 мкФ	1
C19	К50-29-63 В-100 мкФ	1
C20	КМ-5б-М75-470 пФ±10 %-В	1
C21	К50-29-16 В-47 мкФ	1
C22	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	1
Д1	Диод 2Д510А 3.362.096 ТУ	1
Д2	Стабилитрон 2С139А 3.362.805 ТУ	1
Д3...Д5	Диод 2Д103А 3.362.060 ТУ	3
Д6	Стабилитрон Д814Д 3.362.012 ТУ	1
Д7	Диод 2Д103А 3.362.060 ТУ	1
Д8, Д9	Диод Д237Б 3.362.021 ТУ	2
Д10...Д13	Диод 2Д103А 3.362.060 ТУ	4
	Микросхемы	
МС1, МС2	140УД1А 0.347.004 ТУ1	2
МС3	133ЛА3 3.088.023 ТУ7	1
МС4, МС5	521СА2 0.347.015 ТУ1	2
МС6, МС7	142ЕН1Б 0.347.098 ТУ1	2

I	2	3
МС8, МС9	I40УДIА 0.347.004 ТУI	2
МСI0	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
МСII	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
МСI2	I33АГI 3.088.023 ТУ34	I
МСI3	I40УДIА 0.347.004 ТУI	I
МСI4	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
	Транзисторы	
ТI	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
Т2	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	I
Т3	2Т203Б 3.365.007 ТУ	I
У4	Преобразователь 5.I2I.II9	I
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С5-I6МВ 0.467.5I3 ТУ	
	Резисторы СП4-Iв 0.468.045 ТУ	
	Резистор С5-5 0.467.505 ТУ	
RI, R2	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	2
R3	ОМЛТ-2-3,3 кОм±5 %	I
R4	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	I
R5, R6	ОМЛТ-0,25-750 Ом±5 %	2
R7	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	I
R8	ОМЛТ-0,25-I00 Ом±5 %	I
RII	ОМЛТ-0,25-I8 Ом±5 %	I
RI2, RI3	ОМЛТ-0,25-390 Ом±5 %	2
RI4, RI5	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	2
RI6	СП4-Iв-0,25-I00 Ом-А	I
RI7	ОМЛТ-0,25-33 Ом±5 %	I
RI8	СП4-Iв-0,25-I00 Ом-А	I
RI9	ОМЛТ-0,25-33 Ом±5 %	I
R20	ОМЛТ-0,25-620 Ом±5 %	I
R2I, R22	ОМЛТ-0,5-22 Ом±5 %	2
R23	ОМЛТ-0,25-820 Ом±5 %	I
R25	С5-I6 МВ-I Вт-0,I5 Ом±I %	I
R26	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	I
R27	С5-5-2 Вт-3,9 Ом±5 %	I
R28	ОМЛТ-0,25-330 Ом±5 %	I
R29	ОМЛТ-0,25-680 Ом±5 %	I
R30	СП4-Iв-0,25-470 Ом-А	I
R3I	ОМЛТ-0,25-I,6 кОм±5 %	I
R32...R34	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	3
R35	ОМЛТ-2-I6 кОм±5 %	I
R36	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	I
R37, R38	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	2
R39	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	I
R40, R4I	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	2
R42, R43	ОМЛТ-0,25-I00 Ом±5 %	2
R44	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	I
R45	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±5 %	I
R46	ОМЛТ-0,25-I,2 кОм±5 %	I
R47	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±5 %	I
R48	ОМЛТ-0,25-I,2 кОм±5 %	I
R49	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	I
R50, R5I	ОМЛТ-0,25-620 Ом±5 %	2
R52	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	I

I	2	3
R53, R54	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±5 %	2
R55	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	I
R56, R58	С5-I6МВ-I Вт-0,I5 Ом±5 %	2
R60, R6I	ОМЛТ-0,25-I кОм±5 %	2
R62	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	I
R63, R64	ОМЛТ-0,25-I,8 кОм±5 %	2
R65	ОМЛТ-0,25-3,3 кОм±5 %	I
R66	СП4-Iв-0,25-470 Ом-А	I
R67	ОМЛТ-0,25-I,6 кОм±5 %	I
R68	ОМЛТ-0,25-3,3 кОм±5 %	I
R69	СП4-Iв-0,25-470 Ом-А	I
R70	ОМЛТ-0,25-I,6 кОм±5 %	I
R7I, R72	ОМЛТ-0,25-27 Ом±5 %	2
	Конденсаторы К50-29 0.464.I56 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.06I ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К42У-2 0.462.082 ТУ	
	Конденсаторы КI5-5 0.460.084 ТУ	
CI, C2	КМ-6Б-Н90-0,0I5 мкФ-В	2
C3	К50-29-I60 В-4,7 мкФ	I
C4	К50-29-6,3 В-I000 мкФ	I
C5	К50-29-63 В-I00 мкФ	I
C8	К50-29-6,3 В-470 мкФ	I
C9	КМ-5б-Н30-6800 пФ$^{50}_{20}$ %-В	I
CI0	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{80}_{20}$ %-В	I
CII, CI2	К42У-2-250-I±I0 %	2
CI3	К50-29-25 В-I00 мкФ	I
CI4...CI6	КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{50}_{20}$ %-В	3
CI7, CI8	К50-29-300 В-4,7 мкФ	2
CI9	КI5-5-Н70-I,6 кВ-I000 пФ	I
C20, C2I	К50-29-63 В-I00 мкФ	2
C22	КI5-5-Н70-I,6 кВ-I000 пФ	I
C23, C24	КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{50}_{20}$ %-В	2
C25	КI5-5-Н70-I,6 кВ-I000 пФ	I
C26, C27	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{80}_{20}$ %-В	2
C28	КI5-5-Н70-I,6 кВ-I000 пФ	I
C29, C30	КМ-5б-Н30-3300 пФ$^{50}_{20}$ %-В	2
C3I, C32	К50-29-63 В-I00 мкФ	2
C33	КI5-5-Н70-I,6 кВ-I000 пФ	I
	Стабилитроны	
ДI	2С536А 3.362.823 ТУ	I
Д2	2С530А 3.362.823 ТУ	I
Д3	2С536А 3.362.823 ТУ	I
	Диоды	
Д4	2Д5I0А 3.362.096 ТУ	I
Д5	2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
Д6	Оптрон 30УI03В 0.336.I05 ТУ	I
Д7, Д8	Диод 2Д230Г 0.339.465 ТУ	2
Д9	Стабилитрон Д8I8Д 3.362.045 ТУ	I
ДI0...ДI3	Диод 2Д230Г 0.339.465 ТУ	4
	Стабилитроны	
ДI4	2С600А 3.362.827 ТУ	I
ДI5, ДI6	2С530А 3.362.823 ТУ	2
ДI7	2С600А 3.362.827 ТУ	I
ДI8	Диод 2ЦI06В 3.362.004 ТУ	I

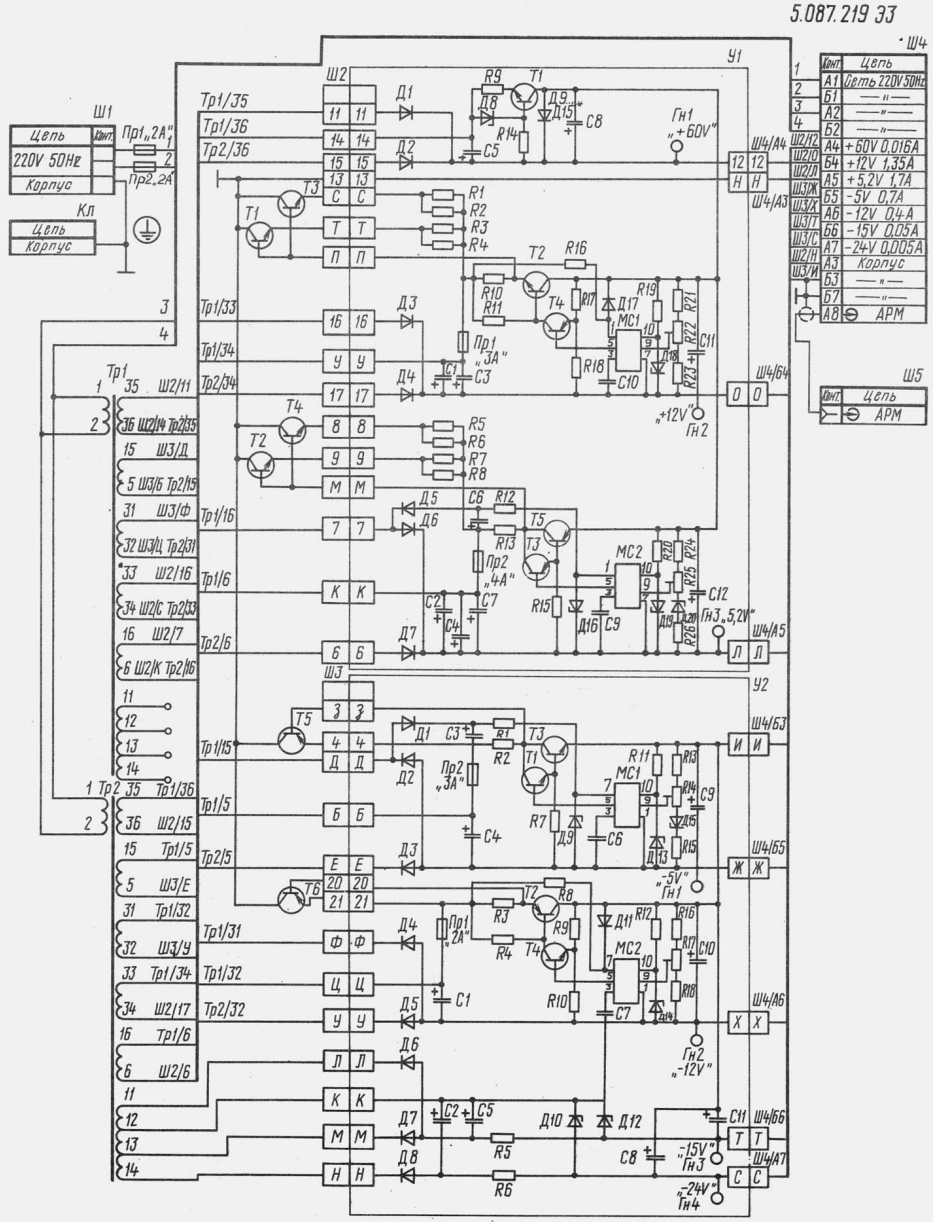
I	2	3
	Стабилитроны	
ДI9	2С600А 3.362.827 ТУ	I
Д20	2С5I5А 3.362.823 ТУ	I
	Диоды:	
Д2I, Д22	2Д2I9Б 0.339.075 ТУ	2
Д23	2ЦI06В 3.362.004 ТУ	I
Д24	2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
Д25	Оптрон 30УI03В 0.336.I03 ТУ	I
Д26	Диод 2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
Д27	Оптрон 30УI03В 0.336.I03 ТУ	I
Д28, Д29	Диод 2Д230В 0.339.465 ТУ	2
Д30, Д3I	Стабилитрон Д8I8Д 3.362.025 ТУ	2
Д32, Д33	Диод 2Д230В 0.339.465 ТУ	2
	Дроссели	
ДрI, Др2	4.752.022	2
Др3, Др4	4.752.0I3	2
Др5...Др7	4.752.022	3
МСI...МС3	Микросхема I40УД5А 0.347.004 ТУ3	3
Пр	Вставка плавкая ВПI-I-2А 0.480.003 ТУ	I
	Транзисторы:	
ТI, Т2	2Т608Б 3.365.0I3 ТУ	2
Т5, Т6	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	2
Т7	КТ8I7В 0.336.I87 ТУ	I
Т8	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	I
Т9, ТI0	2Т809А 3.365.0I7 ТУ	2
ТII	КТ8I7А 0.336.I87 ТУ	I
ТI2	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	I
ТI3	КТ8I7В 0.336.I87 ТУ	I
ТI4, ТI5	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	2
ТI6, ТI7	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	2
ТI8	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	I
ТрI	Трансформатор согласующий 4.777.I60	I
Тр3	Трансформатор 4.739.0I3	I
Тр4	Трансформатор 4.739.0II	I
Тр5	Трансформатор 4.739.0I0 ТУ	I
ШI	Вилка РПI0-II 0.364.004 ТУ	I
Ш2	Розетка РПI0-II 0.364.004 ТУ	I

5.087.2I9 ЭЗ УЗЕЛ ПИТАНИЯ ГКЧ
5.087.2I9 ПЭЗ
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Транзисторы	
Т3, Т4	2Т203Б 3.365.007 ТУ	2
Т5	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	I
МСI, МС2	Микросхема I40УДIА 0.347.004 ТУI	2
У2	Стабилизатор 5.I23.320	
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI	ОМЛТ-I-I кОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,5-I00 Ом±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,5-I00 Ом±I0 %	I

I	2	3
R4	ОМЛТ-0,25-I кОм±I0 %	I
R5	ОМЛТ-I-I00 Ом±I0 %	I
R6	ОМЛТ-2-2,7 кОм±I0 %	I
R7	ОМЛТ-0,25-I кОм±I0 %	I
R8	ОМЛТ-0,25-I кОм±I0 %	I
R9, RI0	ОМЛТ-0,5-390 Ом±I0 %	2
RII	ОМЛТ-0,5-330 Ом±I0 %	I
RI2	ОМЛТ-0,25-330 Ом±I0 %	I
RI3	ОМЛТ-0,25-I00 Ом±I0 %	I
RI4	СП4-IВ-0,25-470 Ом-А	I
RI5	ОМЛТ-0,25-470 Ом±I0 %	I
RI6	ОМЛТ-0,25-330 Ом±I0 %	I
RI7	СП4-IВ-0,25-470 Ом-А	I
RI8	ОМЛТ-0,25-45 кОм±I0 %	I
	Конденсаторы К50-29 0.464.I56 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
CI	К50-29-25В-2200 мкФ	I
C2	К50-29-63В-220 мкФ	I
C3	К50-29-25В-47 мкФ	I
C4	К50-29-I6В-2200 мкФ	I
C5	К50-29-25В-2200 мкФ	I
C6, C7	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C8	К50-29-63В-220 мкФ	I
C9	К50-29-I6В-220 мкФ	I
CI0	К50-29-25В-220 мкФ	I
CII	К50-29-25В-2200 мкФ	I
	Диоды:	
ДI	2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
Д2, Д3	2Д206В 3.362.II3 ТУ	2
Д4, Д5	2Д206В 3.362.0I3 ТУ	2
Д6...Д8	2ДI03А 3.362.060 ТУ	3
Д9, ДI0	Стабилитрон 2С5I2А 3.362.823 ТУ	2
ДII	Диод 2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
	Стабилитроны	
ДI2	2С433А 3.362.8I9 ТУ	I
ДI3	2СI33А 3.362.805 ТУ	I
ДI4	Д8I8Д 3.362.025 ТУ	I
ДI5	2СI33А 3.362.805 ТУ	I
ПрI	Вставка плавкая ВПI-I-2А 250В 0.480.003 ТУ	I
Пр2	Вставка плавкая ВПI-I-3А 250 В 0.480.003 ТУ	I
	Транзисторы	
ТI	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
Т2	КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	I
Т3	КТ8I7В 0.336.I87 ТУ	I
Т4	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
МСI, МС2	Микросхема I40УДIА 0.347.004 ТУI	2
Кл	Клемма 4.835.0I8	I
ПрI, Пр2	Вставка плавкая ВПI-I-2А 250 В 0.48I.003 ТУ	2
ТI...Т4	Транзистор КТ8I7В 0.336.I87 ТУ	4
Т5, Т6	Транзистор КТ8I6В 0.336.I86 ТУ	2
ТрI	Трансформатор 4.702.380	I
Тр2	Трансформатор 4.702.380	I
ШI	Шнур соединительный 4.860.2I3	I
Ш2, Ш3	Розетка РТIН-3-5К 0.364.0II ТУ	2

5.087.219 ЭЗ УЗЕЛ ПИТАНИЯ ГКЧ



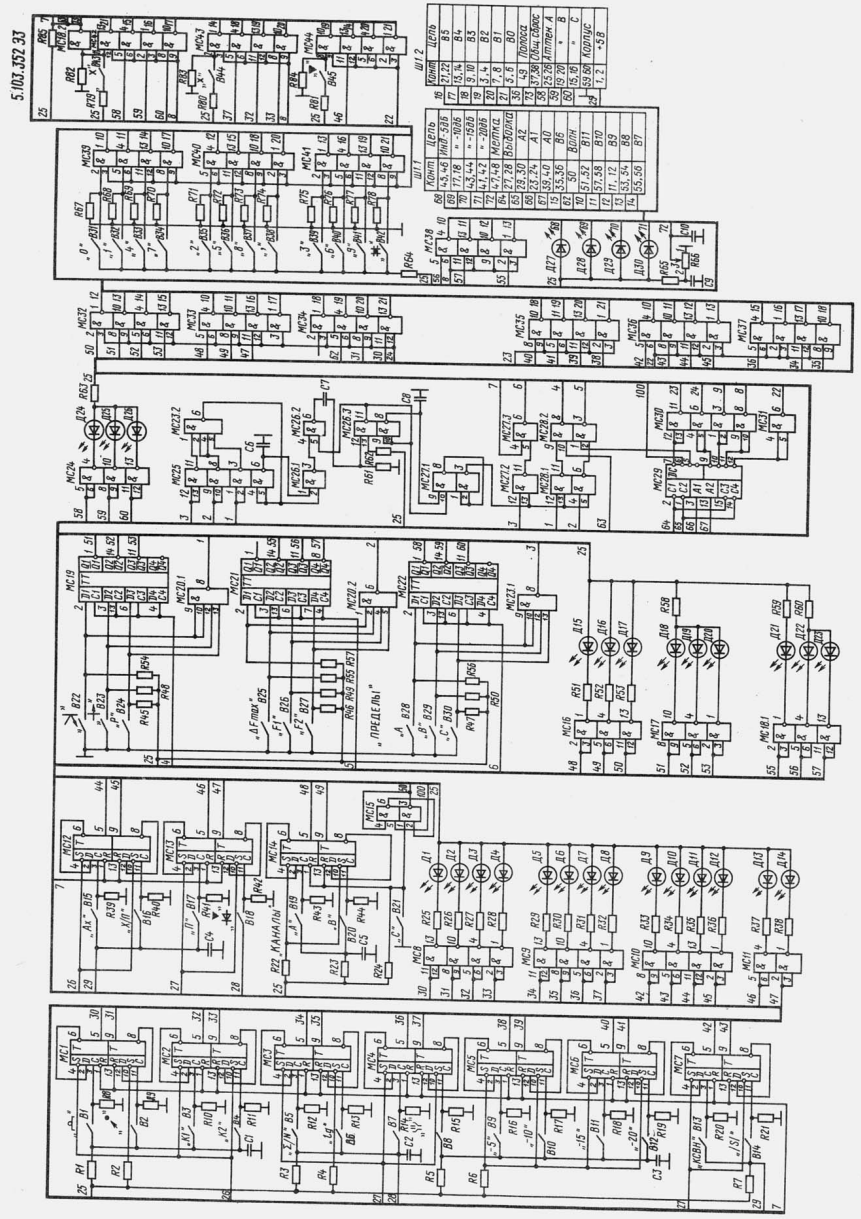
I	2	3
Ш4	Розетка РПП0-I5Л 0.364.004 ТУ	I
Ш5	Розетка СР-50-73ф 0.364.0I0 ТУ	I
УI	Стабилизатор 5.I23.3I9	
	Резисторы МОН 0.467.038 ТУ	
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы СП4-Iв 0.468.045 ТУ	
RI...R8	МОН-0,5-I0ом±I0 %	8
R9	ОМЛТ-0,5-I80 Ом±I0 %	I
RI0	ОМЛТ-0,5-I00 Ом±I0 %	I
RII	ОМЛТ-0,25-I кОм±I0 %	I
RI2	ОМЛТ-I-I кОм±I0 %	I
RI3	ОМЛТ-0,5-I00 Ом±I0 %	I
RI4	ОМЛТ-2-6,8 кОм±I0 %	I
RI5	ОМЛТ-0,25-I кОм±I0 %	I
RI6	ОМЛТ-0,25-I кОм±I0 %	I
RI7, RI8	ОМЛТ-0,5-390 Ом±I0 %	2
RI9	ОМЛТ-0,25-330 Ом±I0 %	I
R20	ОМЛТ-0,5-330 Ом±I0 %	I
R2I	ОМЛТ-0,25-330 Ом±I0 %	I
R22	СП4-Iв-0,25-470 Ом-А	I
R23	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±I0 %	I
R24	ОМЛТ-0,25-I00 Ом±I0 %	I
R25	СП4-Iв-0,25-470 Ом-А	I
R26	ОМЛТ-0,25-470 Ом±I0 %	I
	Конденсаторы К50-29 0.464.I56 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
CI	К50-29-25в-2200 мкФ	I
C2	К50-29-I6В-2200 мкФ	I
C3	К50-29-25В-2200 мкФ	I
C4	К50-29-I6В-2200 мкФ	I
C5	К50-29-I00В-47 мкФ	I
C6	К50-29-25В-47 мкФ	I
C7	К50-29-I6В-2200 мкФ	I
C8	К50-29-I00В-22 мкФ	I
C9, CI0	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
CII	К50-29-25В-220 мкФ	I
CI2	К50-29-I6В-220 мкФ	I
	Диоды	
ДI, Д2	Д237А 3.362.02I ТУ	2
Д3, Д4	2Д202Р 3.362.035 ТУ	2
Д5	2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
Д6, Д7	2Д202Р 3.362.035 ТУ	2
	Стабилитроны	
Д8	2CI47Г 3.362.805 ТУ	I
Д9...ДI5*	Д8I8Д 3.362.025 ТУ	7
ДI6	2C5I2A 5.362.822 ТУ	I
ДI7	Диод 2ДI03А 3.362.060 ТУ	I
ДI8	Стабилитрон Д8I8Д 3.362.025 ТУ	I
ДI9, Д20	Стабилитрон 2CI33A 3.362.805 ТУ	2
ПрI	Вставка плавкая ВПI-I-3А 250 В 0.480.003 ТУ	I
Пр2	Вставка плавкая ВПI-I-4А 250 В 0.480.003 ТУ	I
TI, T2	Транзистор КТ8I7В 0.336.I87 ТУ	2

*Последовательно.

5.I03.352 ЭЗ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

5.I03.352 ПЭЗ
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-2,2 МОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-2,2 МОм±I0 %	I
R4	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R5	ОМЛТ-0,I25-2,2 МОм±I0 %	I
R6	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R7	ОМЛТ-0,I25-2,2 МОм±I0 %	I
R8...R2I	ОМЛТ-0,I25-390 Ом±I0 %	I4
R22	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R23	ОМЛТ-0,I25-2,2 МОм±I0 %	I
R24	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R25...R38	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I4
R39...R44	ОМЛТ-0,I25-390 Ом±I0 %	6
R45...R50	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	6
R5I...R53	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	3
R54...R57	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	4
R58...R60	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	3
R6I	ОМЛТ-0,I25-390 Ом±I0 %	I
R62	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R63	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
R64	ОМЛТ-0,I25-I20 Ом±I0 %	I
R65	ОМЛТ-0,I25-I,8 кОм±I0 %	I
R66	5.638.004	I
R67...R78	ОМЛТ-0,I25-390 Ом±I0 %	I2
R79...R8I	ОМЛТ-0,I25-I20 Ом±I0 %	3
R82...R84	ОМЛТ-0,I25-390 Ом±I0 %	3
R85	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.06I ТУ	
CI...C5	КМ-5б-МI500-3300 пФ±I0 %-В	5
C6	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C7	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ-В	I
C8	КМ-6Б-Н90-0,47 мкФ-В	I
C9, CI0	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
	Кнопки	
BI	6.6I8.207-49	I
B2	6.6I8.207-50	I
B3	6.6I8.207-5I	I
B4	6.6I8.207-52	I
B5	6.6I8.207-04	I
B6	6.6I8.207-53	I
B7	6.6I8.207-06	I
B8	6.6I8.207-54	I
B9	6.6I8.207-08	I
BI0	6.6I8.207-09	I
BII	6.6I8.207-I0	I
BI2	6.6I8.207-II	I
BI3	6.6I8.207-I2	I
BI4	6.6I8.207-59	I
BI5	6.6I8.207-I4	I



I	2	3
BI6	6.6I8.207-I5	I
BI7	6.6I8.207-I7	I
BI8	6.6I8.207-90	I
BI9	6.6I8.207-I8	I
B20	6.6I8.207-I9	I
B2I	6.6I8.207-20	I
B22	6.6I8.207-69	I
B23	6.6I8.207-70	I
B24	6.6I8.207-23	I
B25	6.6I8.207-24	I
B26	6.6I8.207-78	I
B27	6.6I8.207-79	I
B28	6.6I8.207-I8	I
B29	6.6I8.207-I9	I
B30	6.6I8.207-20	I
B3I	6.6I8.207-27	I
B32	6.6I8.207-28	I
B33	6.6I8.207-3I	I
B34	6.6I8.207-34	I
B35	6.6I8.207-29	I
B36	6.6I8.207-32	I
B37	6.6I8.207-35	I
B38	6.6I8.207-37	I
B39	6.6I8.207-30	I
B40	6.6I8.207-33	I
B4I	6.6I8.207-36	I
B42	6.6I8.207-75	I
B43	6.6I8.207-39	I
B44	6.6I8.207-39	I
B45	6.6I8.207-76	I
ДI...Д30	Светодиод ЗЛ34IА 0.339.I89 ТУ	30
ШI	Розетка СН053-60/95х9р-2-В	I
	0.364.006	
	Микросхемы	
МСI...МС7	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	7
МС8...МСII	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	4
МСI2...		
МСI4	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	3

Питание микросхем

Уровень напряжения	Конт. микросхем
МСI...МСI8, МС20, МС23...МС28, МС30...МС44	
+5 V	I4
Корпус	7
МСI9, МС2I, МС22	
+5 V	5
Корпус	I2
МС29	
+5 V	I6
Корпус	8

I	2	3
МСI5	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
МСI6...		
МСI8	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
МСI9	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	I
МС20	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
МС2I,МС22	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	2
МС23	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
МС24	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	I
МС25...		
МС27	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	3
МС28	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
МС29	I33ИД4 3.088.023 ТУ32	I
МС30,МС3I	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	2
МС32...		
МС44	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	I3

5.I04.062 ЭЗ УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ

5.I04.062 ПЭЗ (См.вкл.2)

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы СП5-2 0.468.506 ТУ	
R8	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R9, RI0	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	2
RII	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
RI2	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
RI3	ОМЛТ-0,I25-22 кОм±I0 %	I
RI4	СП5-2-I5 кОм±I0 %	I
RI5	ОМЛТ-0,I25-430 Ом±5 %	I
RI6	ОМЛТ-0,25-I,5 кОм±I0 %	I
RI7	ОМЛТ-0,25-9I0 Ом±5 %	I
RI8	ОМЛТ-0,I25-430 Ом±5 %	I
RI9, R20	ОМЛТ-0,5-330 Ом±I0 %	2
R2I, R22	ОМЛТ-0,I25-20 кОм±5 %	2
R23	ОМЛТ-0,I25-82 кОм±I0 %	I
R24, R25	ОМЛТ-0,I25-I,2 кОм±I0 %	2
R26	ОМЛТ-0,I25-20 кОм±5 %	I
R27	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
R28	ОМЛТ-0,I25-2 кОм±5 %	I
R29	СП5-2-4,7 кОм±I0 %	I
R30	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	I
R3I	СП5-2-I0 кОм±I0 %	I
R32...R34	ОМЛТ-0,I25-5,I кОм±5 %	3
R35	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R36	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R37, R38	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±5 %	2
R39...R42	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	4
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы КМ 0.460.043 ТУ	
C4, C5	КМ-5б-М47-390 пФ±I0 %-В	2
C6	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C7	КМ-5б-МI500-I200 пФ±I0 %-В	I

I	2	3
C8	КМ-5б-Н90-0,068 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C9	КМ-5б-МI500-2200 пФ±I0 %-В	I
CI0	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CII	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
CI2	К53-I4-6,3 В-22 мкФ±20 %-В	I
CI3, CI4	К53-I4-I6 В-22 мкФ±20 %-В	2
CI5, CI6	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
CI7	К53-I4-30 В-22 мкФ±20 %-В	I
CI8	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI9	КМ-5б-М47-I8 пФ±I0 %-В	I
C20	КМ-5б-МI500-820 пФ±I0 %-В	I
C2I	КМ-5б-М47-I00 пФ±I0 %-В	I
C22	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C23	К53-I4-6,3 В-22 мкФ±20 %-В	I
C24, C25	КМ-5б-МI500-I500 пФ±I0 %-В	2
Д3	Стабилитрон Д8I8Д 3.362.025 ТУ	I
Д4, Д5	Стабилитрон 2CI56A 3.362.805 ТУ	2
Д6, Д7	Стабилитрон Д8I4В 3.362.0I2 ТУ	2
Д8	Стабилитрон 2CI56A 3.362.805 ТУ	I
Д9...ДI2	Диод 2Д5I0А 3.362.096 ТУ	4
	Дроссели высокочастотные ДМ 0.477.005 ТУ	
ДрI, Др2	ДМ-0,2-200 мкГн±5 %-В	2
ШI	Вилка конструктивная II2 контактов	I
Ш2, Ш3	Вилка конструктивная 24 контакта	2
	Микросхемы:	
MC3, MC4	I33ЛHI 3.088.023 ТУ22	2
MC5	I33ИД3 3.088.023 ТУ33	I
MC6	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC7	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
MC8...		
MCI0	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	3
MCII	I33АГ3 3.088.023 ТУ58	I
MCI2	I33ИД4 3.088.023 ТУ32	I
MCI3	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MCI4	I33АГ3 3.088.023 ТУ58	I
MCI5...		
MCI7	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
MCI8...		
MC20	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	3
MC2I	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
MC22	I33ИВ3 3.088.023 ТУI6	I
MC23	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC24,MC25	I33ИВ3 3.088.023 ТУI6	2
MC26	52ICA2 0.347.0I5 ТУ2	I
MC27	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC28	I33ИД4 3.088.023 ТУ32	I
MC29	I33АГ3 3.088.023 ТУ58	I
MC30	I33ИРI7 3.088.023 ТУ6I	I
MC3I	I53УД2 0.347.0I0 ТУ2	I
MC32	I98НТ6Б 0.348.002 ТУ	I
MC33...		
MC35	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
MC36	594ПАI 0.347.230 ТУ	I
MC37	I59НТIА 3.456.0I4 ТУ	I
MC38	I33ЛHI 3.088.023 ТУ22	I

I	2	3
MC40...		
MC42	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
MC43	I33ЛАI 3.088.023 ТУ7	I
MC44	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC45	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I

5.I05.065 ЗЗ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ

5.I05.065 ПЗЗ (См.вкл.2)

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI...R3	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	3
R4	ОМЛТ-0,I25-430 Ом±5 %	I
R5...R8	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	4
R9	ОМЛТ-0,I25-430 Ом±5 %	I
RI0	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
RII...RI9	ОМЛТ-0,I25-360 Ом±I0 %	9
R20	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R2I...R23	ОМЛТ-0,I25-360 Ом±I0 %	3
R24	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R25...R36	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	I2
R37	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор К53-I4 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.06I ТУ	
CI	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C2	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C3...C6	КМ-6Б-Н90-0,22 мкФ-В	4
C7	КМ-5б-М47-330 пФ±I0 %-В	I
Пэ	Резонатор РГ-05-I4ГС 5000 кГц-МЗ-У 0.338.065 ТУ	I
	Микросхемы:	
MCI	589ИК02 0.347.2I4 ТУ2	I
MC2, MC3	53ОЛА3 0.347.022 ТУI	2
MC4	589ИК02 0.347.2I4 ТУ2	I
MC5, MC6	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	2
MC7	I33ЛИI 3.088.023 ТУ2I	I
MC8	589АПI6 0.347.2I4 ТУ6	I
MC9	589ИК02 0.347.2I4 ТУ2	I
MCI0	53ОЛАI 0.347.022 ТУI	I
MCII	589ИК02 0.347.2I4 ТУ2	I
MCI2	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I
MCI3	53ОЛА3 0.347.022 ТУI	I
MCI4	589АПI6 0.347.2I4 ТУ6	I
MCI5	589ИК02 0.347.2I4 ТУ2	I
MCI6	53ОЛАI 0.347.022 ТУI	I
MCI7	589АПI6 0.347.2I4 ТУ6	I
MCI8	589ИК02 0.347.2I4 ТУ2	I
MCI9	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC20	589ИРI2 0.347.2I4 ТУ4	I
MC2I	589ИК03 0.347.2I4 ТУ3	I
MC23	53ОЛАI 0.347.022 ТУI	I
MC24	53ОЛА3 0.347.022 ТУI	I
MC25	589ИРI2 0.347.2I4 ТУ4	I

I	2	3
MC26	589ИК0I 0.347.2I4 ТУI	I
MC27	I33ЛHI 3.088.023 ТУ22	I
MC28	I33ИВ3 3.088.023 ТУI6	I
MC29	53ОЛА3 0.347.022 ТУ	I
ШI	Вилка конструктивная II2 контактов	I
Ш2	Вилка конструктивная 24 контакта	I

Переменные данные для исполнений

5.I05.065

P556PT4 Устройство запоминающее

УI	3.482.000-33	I
У2	3.482.000-35	I
У3	3.482.000-34	I

5.I05.065-0I

P556PT4 Устройство запоминающее

УI	3.482.007-33	I
У2	3.482.007-35	I
У3	3.482.007-34	I

5.I05.492 ЗЗ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

5.I05.492 ПЗЗ (См.вкл. 3)

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI...R6	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	6
R7	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R9	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
RI0	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
RII...RI6	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	6
	Конденсаторы КМ 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI, C2	КМ-5б-МI500-3300 пФ±I0 %-В	2
C3	КМ-5б-М750-680 пФ±I0 %-В	I
C4	КМ-5б-МI500-I000 пФ±I0 %-В	I
C5, C6	КМ-5б-МI500-3300 пФ±I0 %-В	2
C7	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C8...CI3	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	6
Ш	Вилка конструктивная	I
	Микросхемы	
MCI	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I

I	2	3
MC2	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC3	I33ИЕ5 3.088.023 ТУII	I
MC4	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I
MC5	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC6	I33ЛHI 3.088.023 ТУ	I
MC7	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC8,MC9	I33ИЕ5 3.088.023 ТУII	2
MCI0,MCII	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	2
MCI2	I33ИЕ5 3.088.023 ТУII	I
MCI3	I33ЛА2 3.088.023 ТУ7	I
MCI4,MCI5	I33ЛHI 3.088.023 ТУ	2
MCI6	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I
MCI7	I33ЛА2 3.088.023 ТУ7	I
MCI8	I33ИЕ5 3.088.023 ТУII	I
MCI9...		
MC2I	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
MC22,MC23	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	2
MC24,MC25	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	2
MC26	I33ЛHI 3.088.023 ТУ	I
MC27	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC28	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I
MC29	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC30	I33ИЕ5 3.088.023 ТУII	I
MC3I	I33АГI 3.088.023 ТУ	I
MC32	I33ЛHI 3.088.023 ТУ	I
MC33, MC34	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	2
MC35...		
MC37	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
MC38	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC39	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
MC40	I33ЛHI 3.088.023 ТУ	I

5.I06.082 ЗЗ УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАЮЩЕЕ

5.I06.082 ПЗЗ (См.вкл. 3)

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,5-I,2 кОм±I0 %	I
RI5	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
RI6...R2I	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	6
R22	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R23	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R24	ОМЛТ-0,I25-56 Ом±I0 %	I
R25...R27	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	3
R28	ОМЛТ-0,I25-820 Ом±I0 %	I
R29	ОМЛТ-0,I25-I8 кОм±I0 %	I
R30	ОМЛТ-0,I25-820 Ом±I0 %	I
R3I	ОМЛТ-0,I25-I8 кОм±I0 %	I
R32, R33	ОМЛТ-0,I25-8,2 кОм±I0 %	2
R34, R35	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	2

I	2	3
R36	ОМЛТ-0,I25-56 Ом±I0 %	I
R37	ОМЛТ-0,I25-27 Ом±I0 %	I
R38	ОМЛТ-0,I25-56 Ом±I0 %	I
R39	ОМЛТ-0,I25-27 Ом±I0 %	I
R40	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.06I ТУ	
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI	КМ-5б-Н90-0,033 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C2	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C3	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C4...CI0	КМ-6Б-Н90-0,47 мкФ-В	7
CII	КМ-5б-Н90-0,033 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI2	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
CI3...CI7	КМ-6Б-Н90-0,47 мкФ-В	5
CI8	КМ-5б-М47-I80 пФ±I0 %-В	I
CI9	КМ-5б-М47-27 пФ±I0 %-В	I
C20	КМ-5б-М47-82 пФ±I0 %-В	I
C2I	КМ-5б-М47-27 пФ±I0 %-В	I
C22	КМ-5б-М47-680 пФ±I0 %-В	I
C23	КМ-5б-М47-27 пФ±I0 %-В	I
C24	КМ-5б-М47-I00 пФ±I0 %-В	I
C25, C26	КМ-5б-МI500-I500 пФ±I0 %-В	2
C27...C30	КМ-5б-М47-56 пФ±I0 %-В	4
C3I...C34	КМ-6Б-Н90-0,47 мкФ-В	4
ДI, Д2	Стабилитрон 2CI47A 3.362.805 ТУ	2
	Транзисторы	
TI	2Т363А 0.336.008 ТУ	I
T2	2Т368А 0.336.05I ТУ	I
T3	2Т363А 0.336.008 ТУ	I
T4	2Т368А 0.336.05I ТУ	I
ШI	Вилка конструктивная II2 контактов	I
	Микросхемы	
MCI,MC2	565РУIА 0.347.I45 ТУ	2
MC3,MC4	I33ЛНI 3.088.023 ТУ22	2
MC5	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC6,MC7	589ИРI2 0.347.2I4 ТУ4	2
MC8	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	I
MC9	I33ЛА4 3.088.023 ТУ7	I
MCI0...		
MCI3	565РУIА 0.347.I45 ТУ	4
MCI4...		
MCI6	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
MCI7,MCI8	565РУIА 0.347.I45 ТУ	2
MCI9...		
MC2I	I33ЛА8 3.088.023 ТУ7	3
MC22...		
MC25	565РУIА 0.347.I45 ТУ	4
MC26...		
MC28	I33АГ3 3.088.023 ТУ58	3
MC29...		
MC32	565РУIА 0.347.I45 ТУ	4
MC33	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC34,MC35	565РУIА 0.347.I45 ТУ	2
MC36	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I

I	2	3
MC37	I33ЛАII 3.088.023 ТУ45	I
MC38,MC39	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	2
MC40,MC4I	565РУIА 0.347.I45 ТУ	2
MC42	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	I
MC43...		
MC46	565РУIА 0.347.I45 ТУ	4
MC47...		
MC50	I33ЛА3 3.088.023 ТУ	4

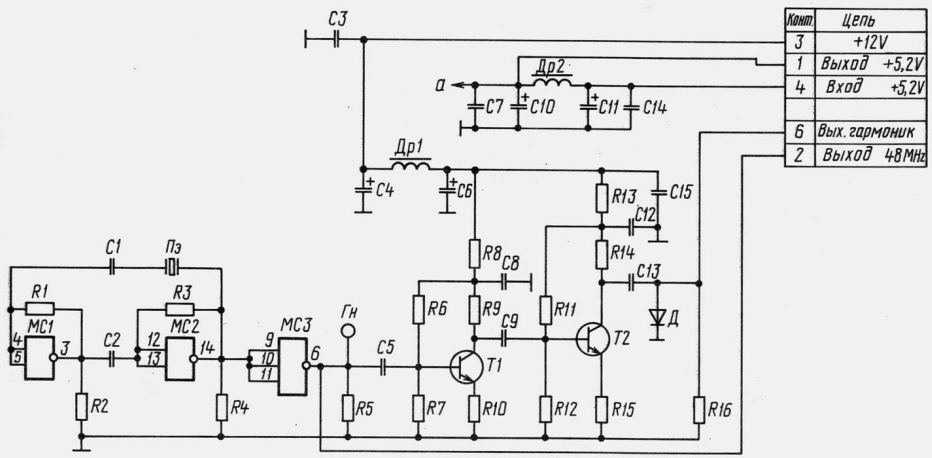
5.I06.083 ЭЗ УСТРОЙСТВО ПОСТОЯННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ

5.I06.083 ПЭЗ (См. вкл.3)

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI...R3	ОМЛТ-0,I25-I,2 кОм±I0 %	3
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор К53-I4 0.464.096 ТУ	
	Конденсатор КМ-6Б 0.464.06I ТУ	
CI...C7	КМ-5б-Н90-0,033 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	7
C8	К53-I4-6,3 В-33 мкФ±20 %-В	I
C9	КМ-6Б-Н90-0,47 мкФ-В	I
	Микросхемы	
MCI, MC2	I33ЛШ5 3.088.023 ТУ3I	2
MC3	I33ЛИI 3.088.023 ТУ2I	I
MC4	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC5	I33ЛРI 3.088.023 ТУ7	I
MC6	I33ТМ2 3.088.023 ТУ20	I
MC7	I33ЛРI 3.088.023 ТУ7	I
MC8	53ЦЛА3 0.347.022 ТУI	I
MC9	I33ЛАI 3.088.023 ТУ7	I
M556PT7	Устройства запоминающие	
УI	3.482.000-0I	I
У2	3.482.000-02	I
У3	3.482.000-03	I
У4	3.482.000-04	I
У5	3.482.000-05	I
У6	3.482.000-06	I
У7	3.482.000-07	I
У8	3.482.000-08	I
У9	3.482.000-09	I
УI0	3.482.000-I0	I
УII	3.482.000-II	I
УI2	3.482.000-I2	I
ШI	Вилка конструктивная II2 контактов	I

5.I26.I99 ЭЗ ГЕНЕРАТОР 48 МГц



Питание микросхемы МС

Цепь	Конт. микросхем
a	I, I6
Корпус	8

5.I26.I99 ПЭЗ

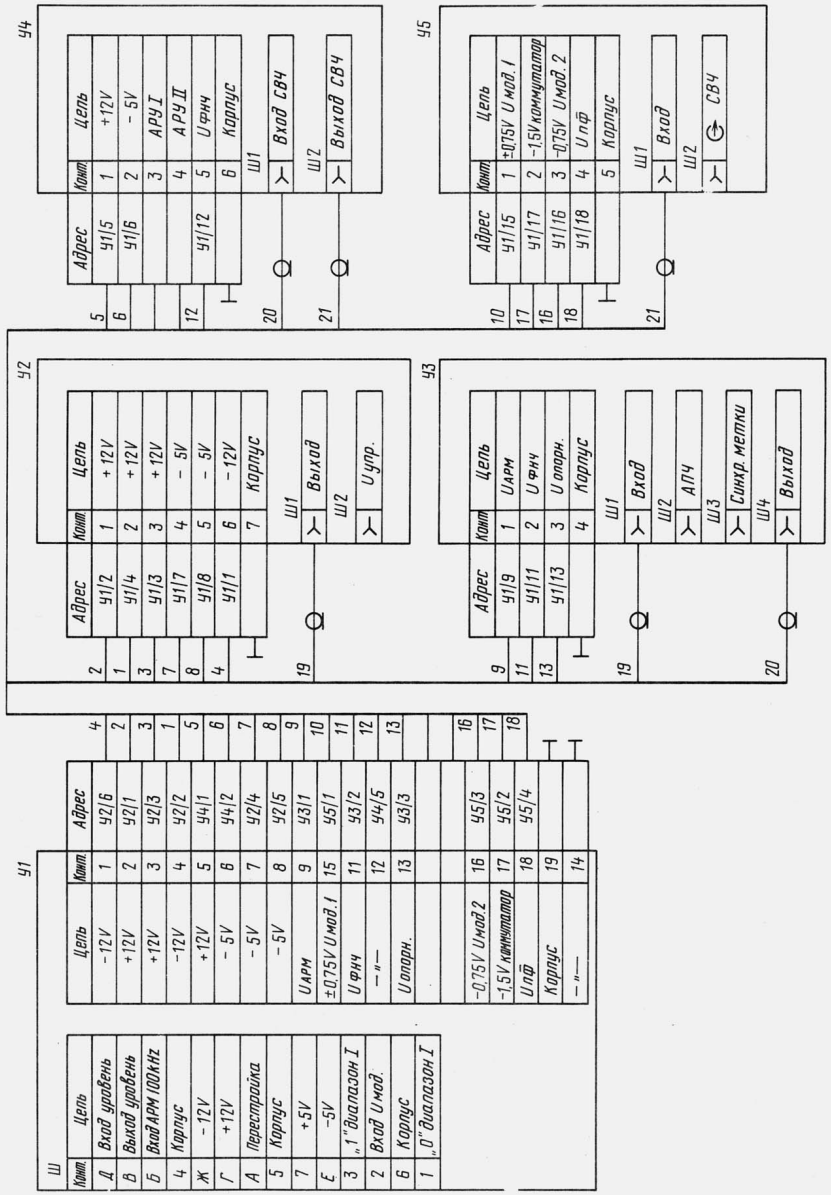
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI...R5	ОМЛТ-0,I25-5I0 Ом±5 %	5
R6	ОМЛТ-0,I25-I2 кОм±I0 %	I
R7	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R8, R9	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	2
RI0	ОМЛТ-0,I25-47 Ом±I0 %	I
RII	ОМЛТ-0,I25-I2 кОм±I0 %	I
RI2	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
RI3	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
RI4	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	I
RI5	ОМЛТ-0,I25-27 Ом±I0 %	I
RI6	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	I
	Конденсаторы КД-I 0.460.I54 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К53-I4 0.464.C96 ТУ	
CI, C2	КД-I-М47-I5 пФ±5 %-3-В	2
C3	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I

I	2	3
C4	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C5	КМ-5б-МI500-I50 пФ±I0 %-В	I
C6	К53-I4-I6 В -33 мкФ±20 %-В	I
C7, C8	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C9	КМ-5б-МI500-I50 пФ±I0 %-В	I
CI0,CII	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	2
CI2	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI3	КМ-5б-МI500-I50 пФ±I0 %-В	I
CI4,CI5	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
Д	Диод 2Д524А 3.362.I37 ТУ	I
ДрI	Дроссель высокочастотный ДМ-0,I-200 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	I
Др2	Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-30 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	I
Пэ	Резонатор РГ-08-I4БВ-48 МГц-Б2-У 0.338.068 ТУ	I
TI, T2	Транзистор 2Т368Б 0.336.05I ТУ	2
MC	Микросхема I00ЛМI05 3.088.068 ТУ 3.088.068 ТУ4	I

5.126.200 ЭЗ

5.126.200 ЭЗ УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРНОЕ
I,25-2,5 ГГц



5.126.200 ЭЗ УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРНОЕ
I,25-2,5 ГГц

5.126.200 ПЭЗ
Перечень элементов

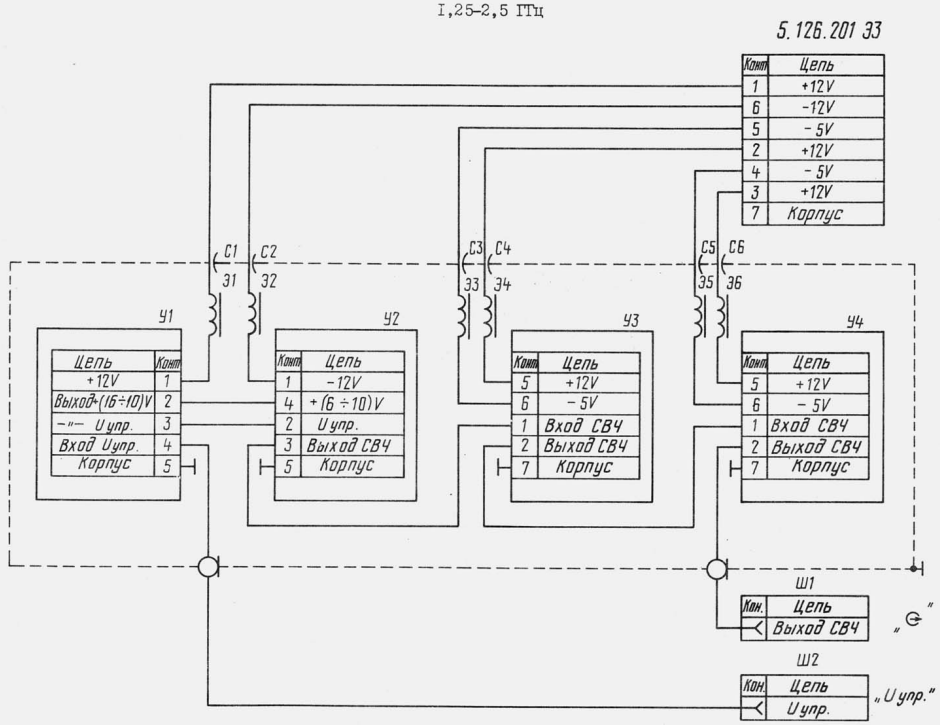
Обозначение	Наименование	Количество
У1	Узел управления 5.139.154	1
У2	Генератор широкополосный I,25-2,5 ГГц 5.126.201	1
У3	Узел делительный 5.407.012	1
У4	Усилитель мощности 5.030.169	1
У5	Умножитель частоты 5.408.071	1

5.126.201 ЭЗ ГЕНЕРАТОР ШИРОКОПОЛОСНЫЙ
I,25-2,5 ГГц

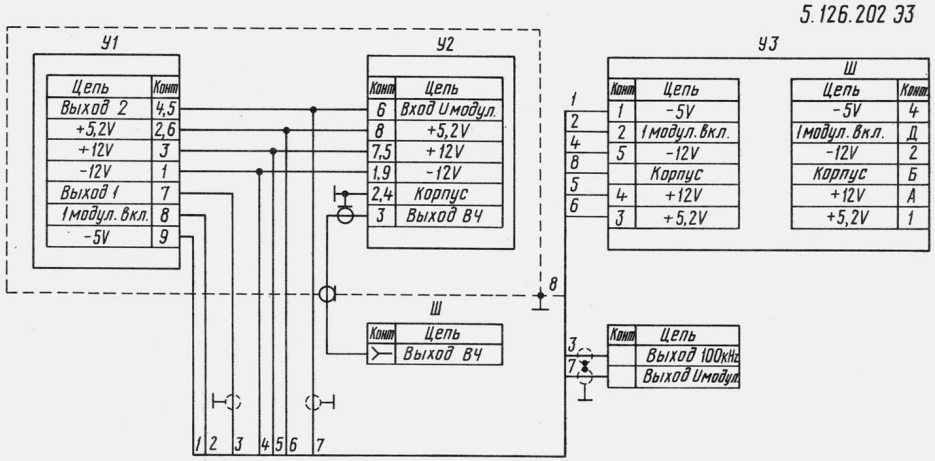
5.126.201 ПЭЗ
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
С1...С6	Фильтр Б-23А-1000 пФ-В 0.206.021	6
Ш1, Ш2	Розетка конструктивная	2
Э1...Э6	Линия с ферритом 5.433.326	6
У1	Фильтр питания 5.129.046	1
У2	Генератор I,25-2,5 ГГц 5.126.204	1
У3	Усилитель балансный I,25-2,5 ГГц 5.030.170-01	1
У4	Усилитель балансный I,25-2,5 ГГц 5.030.170-02	1

5.126.201 ЭЗ ГЕНЕРАТОР ШИРОКОПОЛОСНЫЙ
I,25-2,5 ГГц



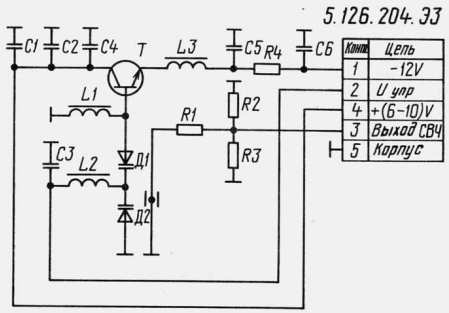
5.I26.202 ЭЗ ГЕНЕРАТОР КАЛИБРОВОЧНЫЙ 50 МГц



5.I26.202 ПЭЗ
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
У1	Генератор I00 кГц 5.I26.208	I
У2	Генератор калибровочный 5.I26.2I2	I
У3	Узел соединения 5.282.274	I
Ш	Розетка 3.647.003	I

5.I26.204 ЭЗ ГЕНЕРАТОР I,25-2,5 ГГц



5.I26.204 ЭЗ ГЕНЕРАТОР I,25-2,5 ГГц

5.I26.204 ПЭЗ
Перечень элементов

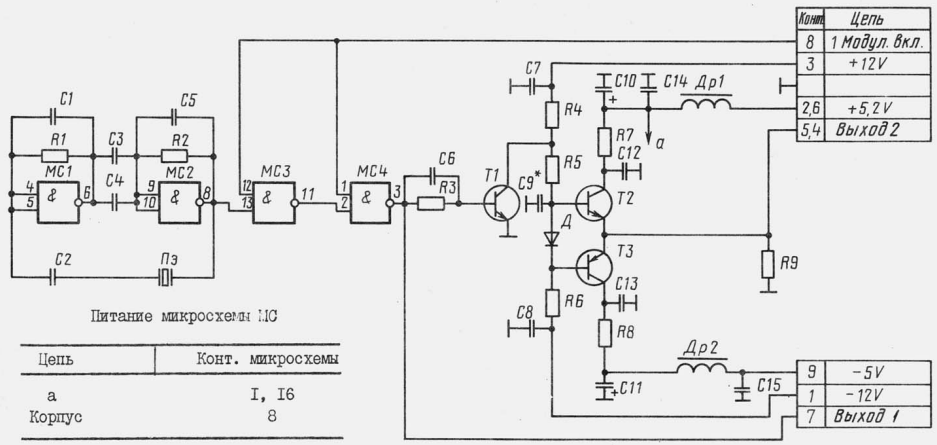
Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы	
RI	29,8 Ом±I %	I
R2, R3	I42 Ом±I %	2
R4	345 Ом±I0 %	I
	Конденсаторы KI0-I7 0.460.I07 ТУ	
CI, C2	KI0-I7-I В-Н90-0,0I мкФ-2	2
C3	KI0-I7-I В-МI500-I00 пФ±I0 %-I	I
C4, C5	KI0-I7-I В-МI500-I50 пФ±I0 %-2	2
C6	KI0-I7-I В-М90-0,0I мкФ-2	I
LI	Индуктивность	I
L2	Индуктивность 7.767.032	I
L3	Индуктивность	I
ДI, Д2	Диод 2А6IIБ 0.336.03I ТУ	2
T	Транзистор 2Т640А-2 0.339.047 ТУ	I

5.I26.208 ЭЗ ГЕНЕРАТОР I00 кГц

5.I26.208 ПЭЗ
Перечень элементов

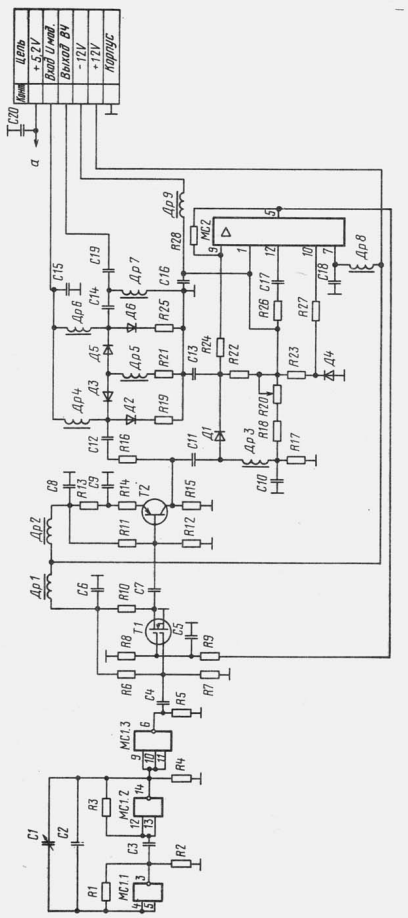
Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С2-I0 0.467.072 ТУ	
	Резистор С2-36 0.467.089 ТУ	
RI, R2	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	2
R3	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R4	С2-I0-0,25-475 Ом±I %-В	I
R5	С2-36-3I6 Ом±0,5 %-Н-В	I
R6	С2-I0-0,25-I,43 кОм±I %-В	I
R7	ОМЛТ-0,I25-82 Ом±I0 %	I
R8	ОМЛТ-0,25-33 Ом±I0 %	I
R9	ОМЛТ-0,I25-I0 кОм±I0 %	I
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор КМ-6 0.460.06I ТУ	
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI	КМ-5б-МI500-680 пФ±I0 %-В	I
C2, C3	КМ-5б-МI500-5600 пФ±I0 %-В	2
C4	КМ-5б-МI500-5600 пФ±I0 %-В	I
C5	КМ-5б-МI500-680 пФ±I0 %	I
C6	КМ-5б-М750-I50 пФ±I0 %-В	I
C7, C8	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	2
C9*	КМ-5б-МI500-I500 пФ±I0 %-В	0,8
	КМ-5б-МI500-I200 пФ±I0 %-В	0,I
	КМ-5б-МI500-I800 пФ±I0 %-В	0,I
		I
CI0,CII	К53-I4-I0 В-I0 мкФ±20 %-В	2
CI2...CI5	КМ-6Б-Н90-0,33 мкФ-В	4
Д	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
ДрI,Др2	Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-60 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	2
Пэ	Резонатор РК753М-I7 БФ-I00 К-В 3.38I.020 ТУ	I
	Транзисторы	
TI	2Т3I6Б 0.336.0I9 ТУ	I
T2	2Т3I2В 3.365.I43 ТУ	I
T3	2Т326Б 0.336.003 ТУ	I
МС	Микросхема I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I

5.I26.208 ЭЗ ГЕНЕРАТОР I00 кГц



Питание микросхемы МС

Цепь	Конт. микросхемы
а	I, I6
Корпус	8



5.126.212 ЭЗ

Питание микросхемы МС1

Цепь	Конт. микросхем
a	I, I6
Корпус	8

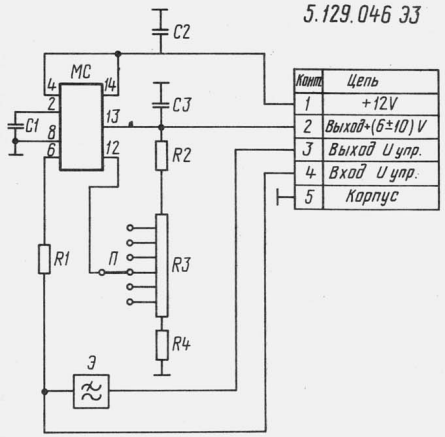
5.I26.2I2 ЭЗ ГЕНЕРАТОР КАЛИБРОВОЧНЫЙ

5.I26.2I2 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С2-I0 0.467.072 ТУ	
	Резистор СП4-I 0.468.045 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-5I0 Ом±5 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-I кОм±5 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-5I0 Ом±5 %	I
R4, R5	ОМЛТ-0,I25-I кОм±5 %	2
R6	ОМЛТ-0,I25-68 кОм±I0 %	I
R7	ОМЛТ-0,I25-22 кОм±I0 %	I
R8	ОМЛТ-0,I25-I МОм±I0 %	I
R9	ОМЛТ-0,I25-33 кОм±I0 %	I
RI0	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
RII	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	I
RI2	ОМЛТ-0,I25-I2 кОм±I0 %	I
RI3	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
RI4	ОМЛТ-0,I25-24 Ом±5 %	I
RI5	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	I
RI6	ОМЛТ-0,I25-5I Ом±5 %	I
RI7	ОМЛТ-0,I25-270 Ом±I0 %	I
RI8	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
RI9	С2-I0-0,I25-45,3 Ом±I %-В	I
R20	СП4-Iв-0,25-3,3 кОм-А	I
R2I	С2-I0-0,I25-27,I Ом±I %-В	I
R22, R23	ОМЛТ-0,I25-I50 кОм±I0 %	2
R24	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R25	С2-I0-0,I25-45,3 Ом±I %-В	I
R26	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R27	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R28	ОМЛТ-0,I25-68 кОм±I0 %	I
	Конденсатор КТ4-2I 0.460.II6 ТУ	
	Конденсаторы КД-I 0.460.I54 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
CI	КТ4-2Iб-2/I0 пФ-В	I
C2	КД-I-М47-6,8 пФ±5 %-3-В	I
C3	КД-I-М47-I8 пФ±I0 %-В	I
C4	КМ-5б-М75-I20 пФ±I0 %-В	I
C5	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C6	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C7	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C8	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C9	КМ-5б-МI500-I000 пФ±I0 %-В	I
CI0,CII	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
CI2	КМ-5б-М75-330 пФ±I0 %-В	I
CI3	КМ-5б-МI500-3300 пФ±I0 %-В	I
CI4, CI5	КМ-5б-М75-220 пФ±I0 %-В	2
CI6	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI7	КМ-5б-М75-I20 пФ±I0 %-В	I
CI8	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI9	КМ-5б-М75-330 пФ±I0 %-В	I
C20	КМ-5б-Н90-0,I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I

I	2	3
	Диоды	
ДI	2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
Д2, Д3	2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	2
Д4	2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
Д5, Д6	2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	2
	Дроссели высокочастотные ДМ 0.477.005 ТУ	
ДрI,Др2	ДМ-0I-I00 мкГн±5 %-В	2
Др3	ДМ-3-I мкГн±0,4 мкГн-В	I
Др4...		
Др6	ДМ-0,6-6 мкГн±5 %-В	3
Др7	ДМ-3-I мкГн±0,4 мкГн-В	I
Др8,Др9	ДМ-0,I-I00 мкГн±5 %-В	2
TI	Транзистор 2П350Б 3.365.2I5 ТУ	I
T2	Транзистор 2Т363А 0.336.008 ТУ	I
МСI	Микросхема I00ЛМI05 3.088.068 ТУ, 3.088.068 ТУ4	I
МС2	Микросхема I40УДIБ 0.347.004 ТУI	I

5.I29.046 ЭЗ ФИЛЬТР ПИТАНИЯ



5.I29.046 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы	
RI	47 кОм±I0 %	I
R2	I,4 кОм±I0 %	I
R3	350 Ом±I0 %	I
R4	680 Ом±I0 %	I
CI...C3	Конденсатор КIO-I7-IВ-Н90-0,I мкФ-Б 0.460.I07 ТУ	3
Э	Фильтр конструктивный	I
МС	Микросхема I42ЕНIА 0.347.098 ТУI	I

5.I39.I54 ЭЗ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

5.I39.I54 ПЭ3 (См.вкл. 3)
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы СП4-Iв 0.468.045 ТУ	
	Резисторы С2-I0 0.467.072 ТУ	
R2	ОМЛТ-0,I25-47 кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-33 кОм±I0 %	I
R5	ОМЛТ-0,I25-680 кОм±I0 %	I
R6, R7	ОМЛТ-0,25-270 Ом±I0 %	2
RI4	ОМЛТ-0,I25-I00 кОм±I0 %	I
RI7	ОМЛТ-0,I25-270 Ом±I0 %	I
RI8	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
RI9	ОМЛТ-0,I25-68 кОм±I0 %	I
R20	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R2I	ОМЛТ-0,I25-22 кОм±I0 %	I
R22	ОМЛТ-0,I25-22 кОм±I0 %	I
R24	СП4-Iв-0,25-47 кОм-А	I
R25	СП4-Iв-0,25-47 кОм-А	I
R26	СП4-Iв-0,25-2,2 кОм-А	I
R27	ОМЛТ-0,I25-47 кОм±I0 %	I
R28	ОМЛТ-0,I25-680 кОм±I0 %	I
R29	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R30, R3I	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	2
R32	ОМЛТ-0,I25-22 кОм±I0 %	I
R33	ОМЛТ-0,I25-270 кОм±I0 %	I
R34	ОМЛТ-0,I25-330 кОм±I0 %	I
R35	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	I
R36...R38	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	3
R39...R4I	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	3
R42	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R43	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	I
R44	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R45	ОМЛТ-0,I25-47 кОм±I0 %	I
R46...R48	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	3
R49	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
R50	ОМЛТ-0,I25-47 кОм±I0 %	I
R5I	СП4-Iв-0,25-2,2 кОм-А	I
R52	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
R53	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	I
R54	ОМЛТ-0,25-27 Ом±I0 %	I
R55	ОМЛТ-0,I25-6,8 кОм±I0 %	I
R56, R57	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	2
R58	ОМЛТ-I-33 Ом±5 %	I
R59	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	I
R60	СП4-Iв-0,25-680 Ом-А	I
R6I	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R62	С2-I0-0,25-I8 Ом±I %-В	I
R63	ОМЛТ-0,25-I00 Ом±I0 %	I
R64	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R65	С2-I0-0,25-I8 Ом±I %-В	I
R66	ОМЛТ-0,25-I00 Ом±I0 %	I
R67	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R68	С2-I0-0,25-I8 Ом±I %-В	I

I	2	3
R69	ОМЛТ-0,5-27 Ом±I0 %	I
R70	ОМЛТ-0,25-68 Ом±I0 %	I
R7I	ОМЛТ-0,I25-470 Ом±I0 %	I
R72	ОМЛТ-0,I25-I50 Ом±I0 %	I
R73	ОМЛТ-0,I25-I20 Ом±I0 %	I
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI	КМ-5б-МI500-I000 пФ±I0 %-В	I
C2	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C3	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C4	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C5	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C7	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C8, C9	КМ-5б-МI500-I000 пФ±I0 %-В	2
CI2	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI4	КМ-5б-Н90-0,022 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI5	КМ-5б-М47-I00 пФ±I0 %-В	I
CI6	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI7	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
CI8	КМ-5б-М47-I00 пФ±I0 %-В	I
CI9	КМ-5б-М47-47 пФ±I0 %-В	I
C20	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C2I	КМ-5б-Н90-0,022 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C22...C28	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	7
C29	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C30	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C3I	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C32	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C33...C35	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3
C36	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C37	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C38	К53-I4-I0 В-47 мкФ±20 %-В	I
C39	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
C40	К53-I4-6,3 В-I00 мкФ±20 %-В	I
ДI...Д3	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	3
Д5	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
Д6, Д7	Стабилитрон 2СI56А 3.362.805 ТУ	2
Д9, ДI0	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	2
ДI2...Д24	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I3
	Дроссели высокочастотные 0.477.005 ТУ	
ДрI...		
Др3	ДМ-0,4-I25 мкГн±5 %-В	3
Др4	ДМ-0,4-I25 мкГн±5 %-В	I
	Транзисторы	
TI	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
T2	2Т603Б 3.365.003 ТУ	I
T3...T5	2Т326Б 0.336.003 ТУ	3
T6	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
T7, T8	2Т603Б 3.365.003 ТУ	2
T9	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
TI0	2Т603Б 3.365.003 ТУ	I
TII	2ТЗI2Б 3.365.I43 ТУ	I
TI2...TI5	2Т603Б 3.365.003 ТУ	4
Ш	Вилка конструктивная	I

I	2	3
	Микросхемы	
MCI	I98УДIБ 0.348.002 ТУ	I
MC3	I33ЛА3 3.088.023 ТУ	I
MC4	I40УД5А 0.347.004 ТУ3	I
MC5	52ICA2 0.347.0I5 ТУI	I

5.I39.I55 ЭЗ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ

5.I39.I55 ПЭЗ (См.вкл. 3)

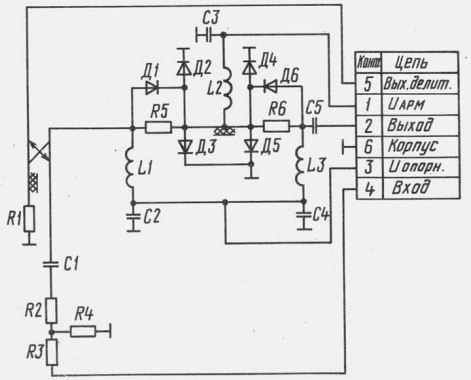
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
I	2	3
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С2-36 0.467.089 ТУ	
	Резисторы СП5-2 0.468.506 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-2,2 кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,I25-3,3 кОм±I0 %	I
R4	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	I
R5	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
R6	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	I
R7	С2-36-I,2I кОм±0,5 %-Н-В	I
R8	СП5-2-I кОм±I0 %	I
R9	С2-36-9,53 кОм±0,5 %-Н-В	I
RI0,RII	ОМЛТ-0,I25-3,3 кОм±I0 %	2
RI2	СП5-2-I кОм±I0 %	I
RI3	С2-36-I0 кОм±0,5 %-Н-В	I
RI4	С2-36-I2,I кОм±0,5 %-Н-В	I
RI5	С2-36-7,5 кОм±0,5 %-Н-В	I
RI6	ОМЛТ-0,I25-3,3 кОм±I0 %	I
RI7	СП5-2-I кОм±I0 %	I
RI8	С2-36-200 Ом±0,5 %-Н-В	I
RI9	ОМЛТ-0,I25-4,7 кОм±I0 %	I
R20	ОМЛТ-0,I25-680 Ом±I0 %	I
	Конденсаторы К53-I4 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
CI, C2	К53-I4-I6 В-22 мкФ±20 %-В	2
C3	К53-I4-6,3 В-33 мкФ±20 %-В	I
C5	КМ-5б-М75-330 пФ±I0 %-В	I
C6...C8	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3
CI0	КМ-5б-МI500-I000 пФ±I0 %-В	I
CII	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI2	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI3	К53-I4-I6 В-33 мкФ±20 %-В	I
CI4	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
CI5...CI7	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3
CI8	К53-I4-I6 В-22 мкФ±20 %-В	I
CI9, C20	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C2I, C22	КМ-5б-Н90-0,I мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C23, C24	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	2
C25...C32	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	8
C33...C35	КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	3

I	2	3
C36	КМ-5б-М47-I80 пФ±I0 %-В	I
ДI, Д2	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	2
Д3	Стабилитрон Д8I8Д 3.362.025 ТУ	I
Д4	Диод 2Д522Б 3.362.029-0I ТУ	I
	Дроссели высокочастотные ДМ 0.477.005 ТУ	
ДрI,Др2	ДМ-0,I-200 мкГн±5 %-В	2
Др3	ДМ-0,6-60 мкГн±5 %-В	I
	Микросхемы	
MCI	I33ИД4 3.088.023 ТУ32	I
MC2	530ЛА3 0.347.022 ТУI	I
MC3, MC4	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	2
MC5, MC6	I33ЛА6 3.088.023 ТУ7	2
MC7	I33ЛАI 3.088.023 ТУ7	I
MC8...MCI4	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	7
MCI5,MCI6	594ПАI 0.347.230 ТУ	2
MCI7...		
MCI9	I40УД7 0.347.004 ТУ5	3
MC20...		
MC22	I33ТМ7 3.088.023 ТУI2	3
MC23	572ПАIА 0.347.I82 ТУI	I
MC24	I40УД7 0.347.004 ТУ5	I
Ш	Вилка конструктивная	I
	Переменные данные для исполнений 5.I39.I55	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.06I ТУ	
C4	КМ-6Б-Н90-I мкФ-В	I
C9	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ-В	I
	5.I39.I55-0I	
	Конденсаторы К73П-3 0.46I.029 ТУ	
C4	К73П-3-0,25±I0 %-В	I
C9	К73П-3-0,25±I0 %-В	I

5.I57.0II ЭЗ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

5.157.011 ЭЗ



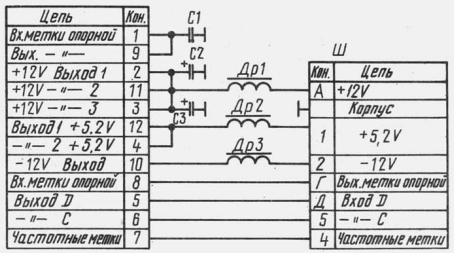
5.I57.0II ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы конструктивные	
RI	50 Ом±I %	I
R2, R3	8,5±0,3 Ом	2
R4	I42 Ом±I %	I
R5, R6	49 Ом±I %	2
CI...C5	Конденсатор КI0-I7-2в-МI500-330 пФ±±5 %-I 0.460.I07 ТУ	5
LI...L3	Индуктивность 7.767.I46-0I	3
ДI...Д6	Диод 2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	6

5.282.249 ЭЗ УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЙ

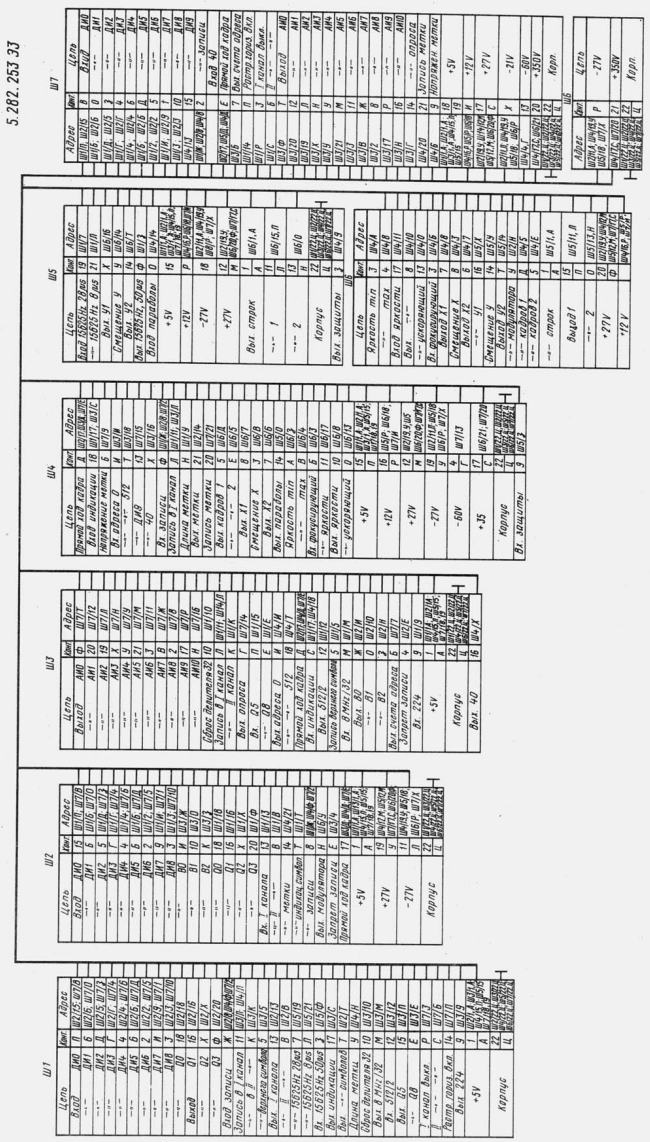
5.282.249 ЭЗ



5.282.249 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Конденсатор КМ 0.460.06I ТУ	
	Конденсатор К53-I4 0.464.096 ТУ	
CI	КМ-5б-Н90-0,047 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В	I
C2, C3	К53-I4-I6В-33 мкФ±20 %-В	2
	Дроссели высокочастотные ДМ 0.477.005 ТУ	
ДрI	ДМ-0,2-200 мкГн±5 %-В	I
Др2	ДМ-0,4-I25 мкГн±5 %-В	I
Др3	ДМ-0,2-200 мкГн±5 %-В	I
Ш	Вилка конструктивная	I



5.282.253 ЭЗ УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ

5.282.253 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
Ш1...Ш5	Розетка РГ1Н-3-5А 0.364.011 ТУ	5
Ш6, Ш7	Вилка конструктивная	2

5.282.261 ЭЗ УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЙ

5.282.261 ПЭЗ (См. вкл.3)

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
R1...R12	ОМЛТ-0,125-680 Ом±10 %	12
R13...R24	ОМЛТ-0,125-360 Ом±10 %	12
	Микросхемы	
МС1...МС3	589АП16 0.347.214 ТУ6	3
МС4	133ЛП5 3.088.023 ТУ31	1
Ш1...Ш3	Вилка СН055-60/93х9В-23-В 0.364.006 ТУ	3
Ш4...Ш7	Розетка СНП14-112/170х10Р-19-В 0.364.008 ТУ	4
Ш8	Вилка СН051-40/69х9В-23-В 0.364.006 ТУ	1
Ш9	Вилка СН053-60/93х9В-23-В 0.364.006 ТУ	1

5.404.218 ЭЗ УСТРОЙСТВО ДЕТЕКТОРНОЕ

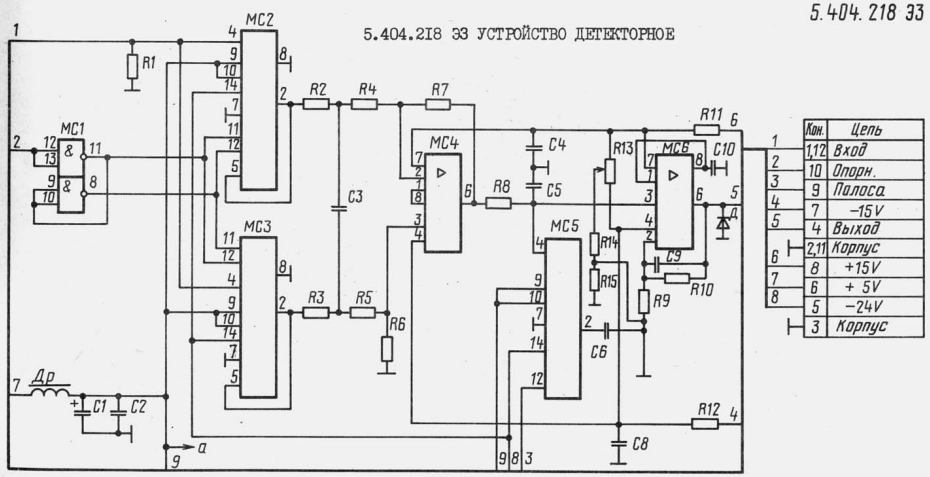
5.404.218 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы ОМЛТ 0.467.107 ТУ	
	Резисторы С2-29В 0.467.099 ТУ	
	Резистор СП5-2 0.462.506 ТУ	
R1	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
R2...R5	С2-29В-0,125-10 кОм±1 %-1,0-А	4
R6, R7	С2-29В-0,125-20 кОм±1 %-1,0-А	2
R8	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	1
R9	ОМЛТ-0,125-2,2 кОм±10 %	1
R10	ОМЛТ-0,125-4,7 кОм±10 %	1
R11, R12	ОМЛТ-0,125-47 Ом±10 %	2
R13	СП5-2-22 кОм±10 %	1
R14	ОМЛТ-0,125-6,8 кОм±10 %	1
R15	ОМЛТ-0,125-220 Ом±10 %	1
	Конденсатор К53-14 0.464.096 ТУ	
	Конденсаторы КМ-6Б 0.460.061 ТУ	
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
C1	К53-14-6,3 В-100 мкФ±20 %-В	1
C2	КМ-6Б-Н90-1 мкФ-В	1
C3	КМ-5б-М47-27 пФ±10 %-В	1
C4	КМ-6Б-Н90-1 мкФ-В	1
C5	КМ-6Б-Н90-0,22 мкФ-В	1
C6	КМ-6Б-Н90-2,2 мкФ-В	1
C8	КМ-6Б-Н90-1 мкФ-В	1

5.404.218 ЭЗ

5.404.218 ЭЗ УСТРОЙСТВО ДЕТЕКТОРНОЕ



Питание микросхемы МС1

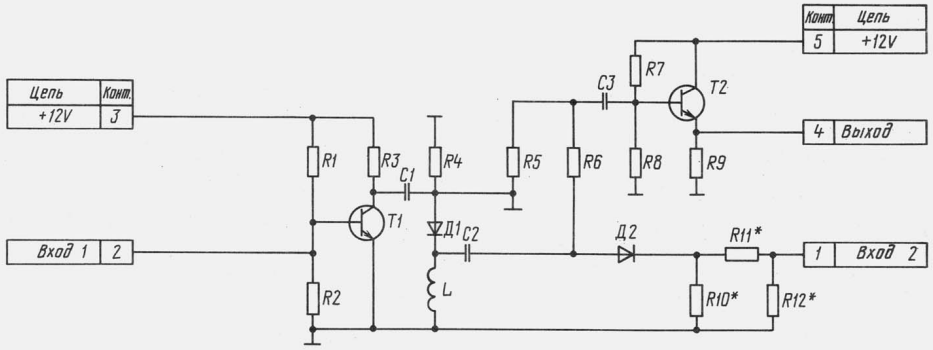
Цепь	Конт. микросхем
а	14
Корпус	7

I	2	3
C9	КМ-5б-М47-33 пФ±I0 %-В	I
CI0	КМ-5б-М47-I20 пФ±I0 %-В	I
Д	Стабилитрон 2CI47A 3.362.805 ТУ	I
Др	Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-200 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	I

	Микросхемы	
MCI	I33ЛА3 3.088.023 ТУ7	I
MC2; MC3	I43КТI 3.439.000 ТУ	2
MC4	544УД2А 0.347.040 ТУ	I
MC5	I43КТI 3.439.000 ТУ	I
MC6	544УД2А 0.347.040 ТУ	I

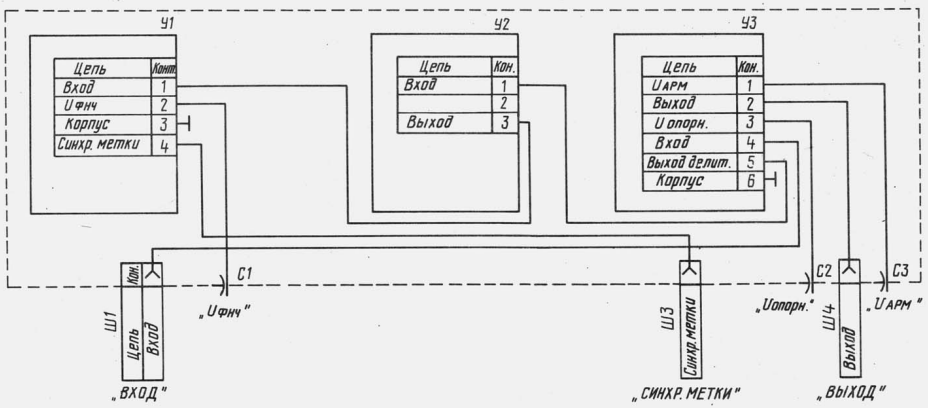
5.406.059 ЭЗ СМЕСИТЕЛЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ

5.406.059 ЭЗ



5.407.0I2 ЭЗ УЗЕЛ ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

5.407.012 ЭЗ



5.406.059 ЭЗ СМЕСИТЕЛЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ

5.406.059 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
	Резисторы С2-I0 0.467.072 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-I5 кОм±I0 %	I
R2	ОМЛТ-0,I25-I,5 кОм±I0 %	I
R3	ОМЛТ-0,5-I80 Ом±5 %	I
R4	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R5	ОМЛТ-0,I25-I20 кОм±I0 %	I
R6	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
R7	ОМЛТ-0,I25-I5 кОм±I0 %	I
R8	ОМЛТ-0,I25-I2 кОм±I0 %	I
R9	ОМЛТ-0,I25-I кОм±I0 %	I
RI0*	С2-I0-0,I25-437 Ом±I %-В	0,95
	С2-I0-0,I25-I50 Ом±I %-В	0,03
	С2-I0-0,I25-88,7 Ом±I %-В	0,02
		I
RII*	С2-I0-0,I25-II,7 Ом±I %-В	0,95
	С2-I0-0,I25-37,4 Ом±I %-В	0,03
	С2-I0-0,I25-7I,5 Ом±I %-В	0,02
		I
RI2*	С2-I0-0,I25-437 Ом±I %-В	0,95
	С2-I0-0,I25-I50 Ом±I %-В	0,03
	С2-I0-0,I25-88,7 Ом±I %-В	0,02
		I
	Конденсаторы КМ-5б 0.460.043 ТУ	
	Конденсатор КД-I 0.460.I54 ТУ	
CI	КМ-5б-MI500-820 пФ±I0 %-В	I
C2	КД-I-М47-4,7 пФ±I0 %-3-В	I
C3	КМ-5б-MI500-820 пФ±I0 %-В	I
L	Индуктивность конструктивная	I
ДI	Диод 2Д524А 3.362.I37 ТУ	I
Д2	Диод 3АII7А-6 0.339.005 ТУ	I
TI	Транзистор 2Т368Б 0.336.05I ТУ	I
T2	Транзистор 2Т3I6Д 0.336.0I9 ТУ	I

*Подбирается при регулировании

5.407.0I2 ЭЗ УЗЕЛ ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

5.407.0I2 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
CI...C3	Конденсатор КТП-2Аа-М750-I00 пФ±I0 % 0.460.I53 ТУ	3
ШI,Ш3,Ш4	Контакт	3
УI	Фильтр НЧ переключаемый 5.067.3I4	I
У2	Плата полосковая 7.I00.I62	I
У3	Регулятор мощности 5.I57.0II	I

5.408.069 ЭЗ ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ II

5.408.069 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы ОМЛТ 0.467.I07 ТУ	
RI	ОМЛТ-0,I25-I00 Ом±I0 %	I
R3...R5	ОМЛТ-0,I25-5I0 Ом±5 %	3
R6	ОМЛТ-0,I25-220 Ом±I0 %	I
R7	ОМЛТ-0,I25-27 Ом±I0 %	I
R8	ОМЛТ-0,I25-330 Ом±I0 %	I
CI...C3	Конденсатор КМ-5б-Н90-0,0I5 мкФ$^{+80}_{-20}$ %-В 0.460.043 ТУ	3
Др	Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-60 мкГн±5 %-В 0.477.005 ТУ	I
TI	Транзистор 2Т326Б 0.336.003 ТУ	I
T2	Транзистор 2Т3I6Д 0.336.0I9 ТУ	I
MC	Микросхема I00ТМI3I 3.088.068 ТУ 3.088.068 ТУI0	I

5.408.07I ЭЗ УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

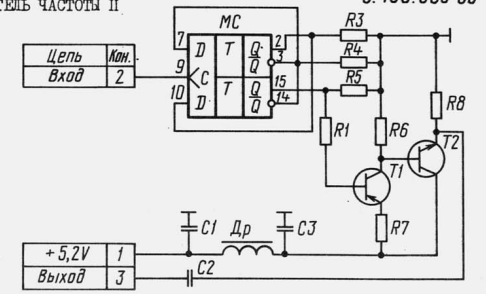
5.408.07I ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
CI...C4	Конденсатор КТП-2Аа-MI500-330 пФ±I0 % 0.460.I53 ТУ	4
ШI, Ш2	Переход коаксиально-полосковый 2.236.078	2
Э	Линия с ферритом 5.433.326	I
УI	Узел полосковый 6.I2I.377	I
CI...C4	Конденсатор КI0-I7-2в-MI500-330 пФ±5 %-I 0.460.I07 ТУ	4
LI...L3	Индуктивность 7.767.I46-0I	3
ДI...Д8	Диод 2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	8
У2	Узел полосковый 6.I2I.596	I
RI	Резистор конструктивный 26±0,5 Ом	I
R2, R3	Резистор конструктивный 70,4±I Ом	2
R4	Резистор конструктивный 26±0,5 Ом	I
	Конденсаторы КI0-I7 0.460.I07 ТУ	
CI	КI0-I7-2в-М47-68 пФ±I0 %-I	I
C2	КI0-I7-2в-MI500-330 пФ±5 %-I	I
LI...L3	Индуктивность 7.767.033	3
ДI...Д4	Диод 3АII7А-6 0.339.005 ТУ	4
Д5...Д8	Диод 2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	4
ЭI	Линия коаксиальная 5.433.057-0I	I
Э2	Заготовка (провод ПЭТВ-939-0,3I l = 20 мм)	I
У3	Узел полосковый 6.I2I.597	I
CI, C2	Конденсатор КI0-I7-2в-MI500-330 пФ ±5 %-I 0.460.I07 ТУ	2
ДI...Д4	Диод 2А5I7А-2 0.336.028 ТУ	4
L	Индуктивность 7.767.033	I

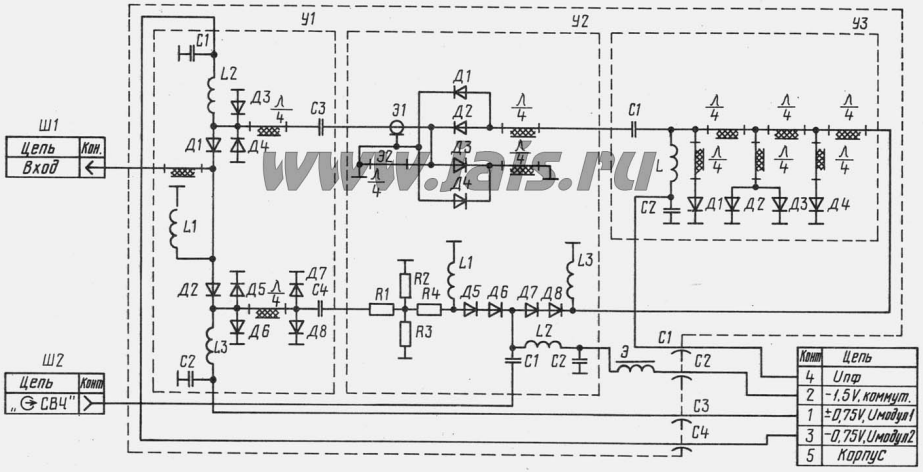
5.408.069 ЭЗ ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ II

5.408.069 ЭЗ

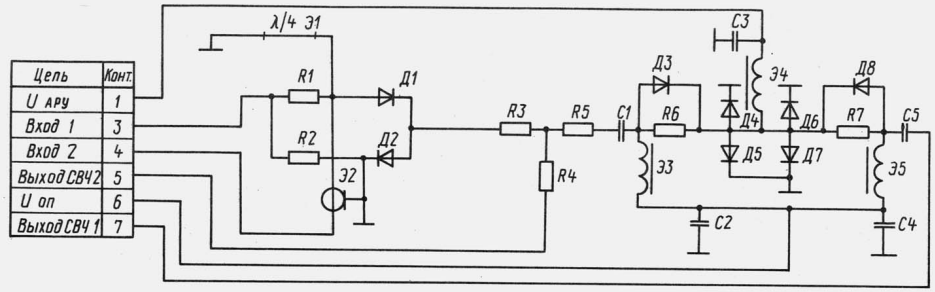


5.408.071 ЭЗ УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

5.408.071 ЭЗ



5.436.063 ЭЗ СМЕСИТЕЛЬ



Обозначение	С1–С5	Д3–Д8	Э3–Э5
5.436.063	К10-17-2б-Н90.001 мкФ-1 ОЖО.460.107 ТУ	2А517А-2 ТТО.326.028 ТУ	5.433.325
5.436.063-01	—	—	—

5.436.063 ЭЗ СМЕСИТЕЛЬ

5.436.063 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
	Резисторы	
R1, R2	20±0,3 Ом	2
R3...R5	16,7 Ом±2 %	3
R6, R7	49 Ом±2 %	2
C1...C5	Конденсатор (см. таблицу)	5
Д1, Д2	Диод 2А116А-1 0.339.104 ТУ	2
Д3...Д8	Диод (см. таблицу)	6
Э1	Заготовка (провод ПЭТВ-939 0,31 мм, l = 15 кОм)	1
Э2	Коаксиальная линия 5.433.057	1
Э3...Э5	Линия с ферритом (см. таблицу)	3

5.436.108 ЭЗ МОСТ

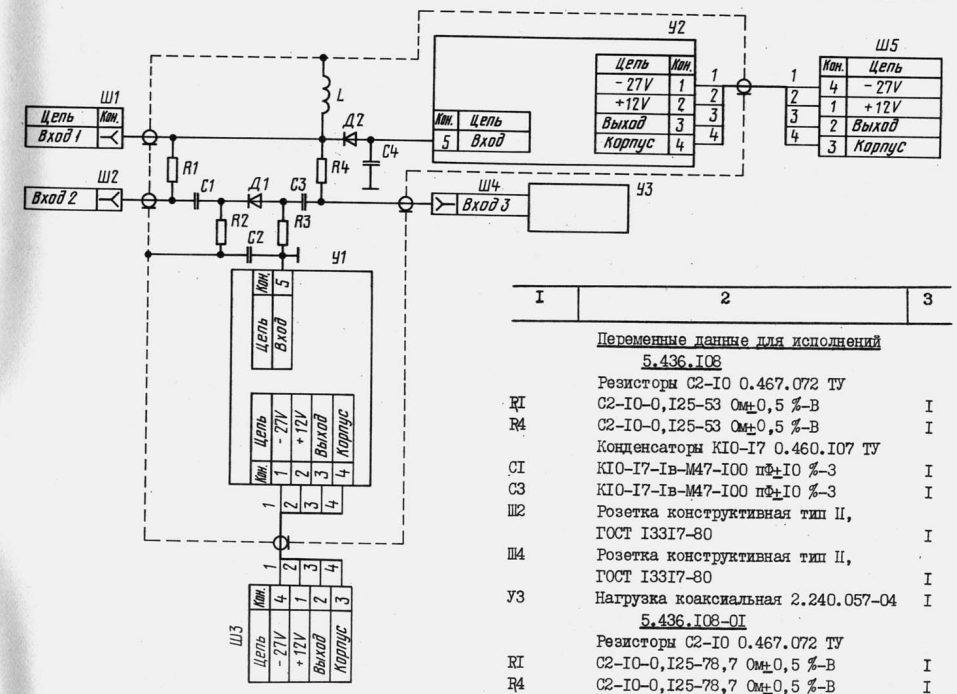
5.436.108 ПЭЗ

Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
1	2	3
R2, R3	Резистор С2-10-0,125-2 кОм±1 %-В 0.467.072 ТУ	2
	Конденсаторы К10-17 0.460.107 ТУ	
C2	К10-17-1в-М47-330 пФ±10 %-3	1
C4	К10-17-1в-М47-330 пФ±10 %-3	1
L	Индуктивность 4.777.276-03	1
Д1, Д2	Диод 2А120А 0.339.068 ТУ	2
Ш1	Розетка конструктивная тип Ш, вариант 1 ГОСТ 13317-80	1
Ш3	Розетка РС4ТВ с кожухом 0.364.047 ТУ	1
Ш5	Розетка РС4ТВ с кожухом 0.364.047 ТУ	1
У1, У2	Усилитель 5.031.089	2

5.436.108 ЭЗ МОСТ

5.436.108 ЭЗ

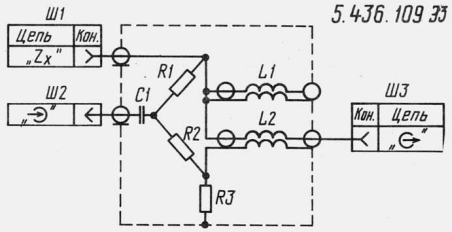


1	2	3
	Переменные данные для исполнений 5.436.108	
	Резисторы С2-10 0.467.072 ТУ	
R1	С2-10-0,125-53 Ом±0,5 %-В	1
R4	С2-10-0,125-53 Ом±0,5 %-В	1
	Конденсаторы К10-17 0.460.107 ТУ	
C1	К10-17-1в-М47-100 пФ±10 %-3	1
C3	К10-17-1в-М47-100 пФ±10 %-3	1
Ш2	Розетка конструктивная тип II, ГОСТ 13317-80	1
Ш4	Розетка конструктивная тип II, ГОСТ 13317-80	1
У3	Нагрузка коаксиальная 2.240.057-04	1
	5.436.108-01	
	Резисторы С2-10 0.467.072 ТУ	
R1	С2-10-0,125-78,7 Ом±0,5 %-В	1
R4	С2-10-0,125-78,7 Ом±0,5 %-В	1

www.ais.ru

I	2	3
	Конденсаторы КІО-І7 0.460.І07 ТУ	
СІ	КІО-І7-Ів-М47-І00 пФ±І0 %-3	І
С3	КІО-І7-Ів-М47-І00 пФ±І0 %-3	І
Ш2	Розетка конструктивная тип УШ, ГОСТ І33І7-80	І
Ш4	Розетка конструктивная тип УШ, ГОСТ І33І7-80	І
У3	Нагрузка коаксиальная 2.240.057	І
	5.436.І08-02	
	Резисторы С2-І0 0.467.072 ТУ	
RІ	С2-І0-0,І25-75 Ом±0,5 %-В	І
R4	С2-І0-0,І25-75 Ом±0,5 %-В	І
СІ	Конденсатор конструктивный	І
С3	Конденсатор конструктивный	І
Ш2	Розетка конструктивная тип УШ, ГОСТ І33І7-80	І
Ш4	Розетка конструктивная тип УШ, ГОСТ І33І7-80	І
У3	Нагрузка коаксиальная 2.240.057	І
	5.436.І08-03	
	Резисторы С2-І0 0.467.072 ТУ	
RІ	С2-І0-0,І25-53 Ом±0,5 %-В	І
R4	С2-І0-0,І25-53 Ом±0,5 %-В	І
	Конденсаторы КІО-І7 0.460.І07 ТУ	
СІ	КІО-І7-Ів-М47-І00 пФ±І0 %-3	І
С3	КІО-І7-Ів-М47-І00 пФ±І0 %-3	І
Ш2	Розетка конструктивная тип Ш, вариант І, ГОСТ І33І7-80	І
Ш4	Розетка конструктивная тип Ш, вариант І, ГОСТ І33І7-80	І
У3	Нагрузка коаксиальная 2.240.056	І
	5.436.І08-04	
	Резисторы С2-І0 0.467.072 ТУ	
RІ	С2-І0-0,І25-53 Ом±0,5 %-В	І
R4	С2-І0-0,І25-53 Ом±0,5 %-В	І
	Конденсаторы КІО-І7 0.460.І07 ТУ	
СІ	КІО-І7-Ів-М47-І00 пФ±І0 %-3	І
С3	КІО-І7-Ів-М47-І00 пФ±І0 %-3	І
Ш2	Розетка конструктивная тип IX, вариант 3, ГОСТ І33І7-80	І
Ш4	Розетка конструктивная тип IX, вариант 3, ГОСТ І33І7-80	І
У3	Нагрузка коаксиальная 2.243.339	І

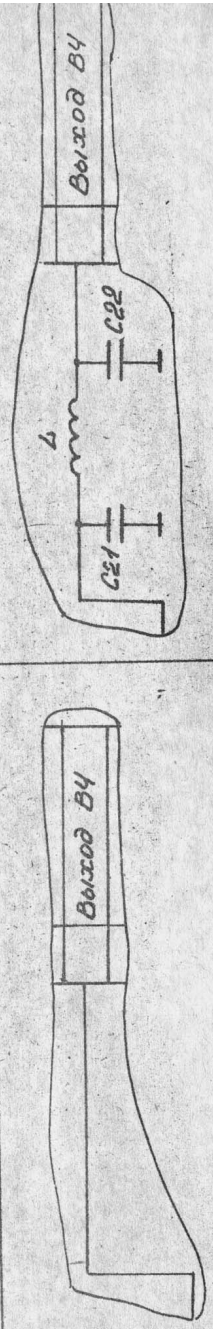
5.436.І09 ЭЗ МОСТ



5.436.І09 ПЭ3
Перечень элементов

Обозначение	Наименование	Количество
СІ	Конденсатор конструктивный	І
LІ...L2	Индуктивность конструктивная	2
RІ, R2	Резистор РІ-6-50 Ом±І % 0.467.І6І ТУ	2
R3	Резистор С6-3-0,5-50 Ом±2 %-В 0.467.І0І ТУ	І
Ш2	Вилка конструктивная 3.640.052 тип Ш, вариант І ГОСТ І33І7-80	І
Ш3	Розетка конструктивная 3.640.І38 тип Ш, вариант І ГОСТ І33І7-80	І
	Переменные данные для исполнений	
	5.436.І09	
Ш	Розетка конструктивная 3.640.024 тип Ш, вариант І ГОСТ І33І7-80	І
	5.436.І09-0І	
Ш	Розетка конструктивная тип II ГОСТ І33І7-80	І
	5.436.І09-02	
Ш	Розетка конструктивная тип IX, вариант 3 ГОСТ І33І7-80	І

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В АЛЬБОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ НА Р2-78* Р2-82

Напечатано

Должно быть